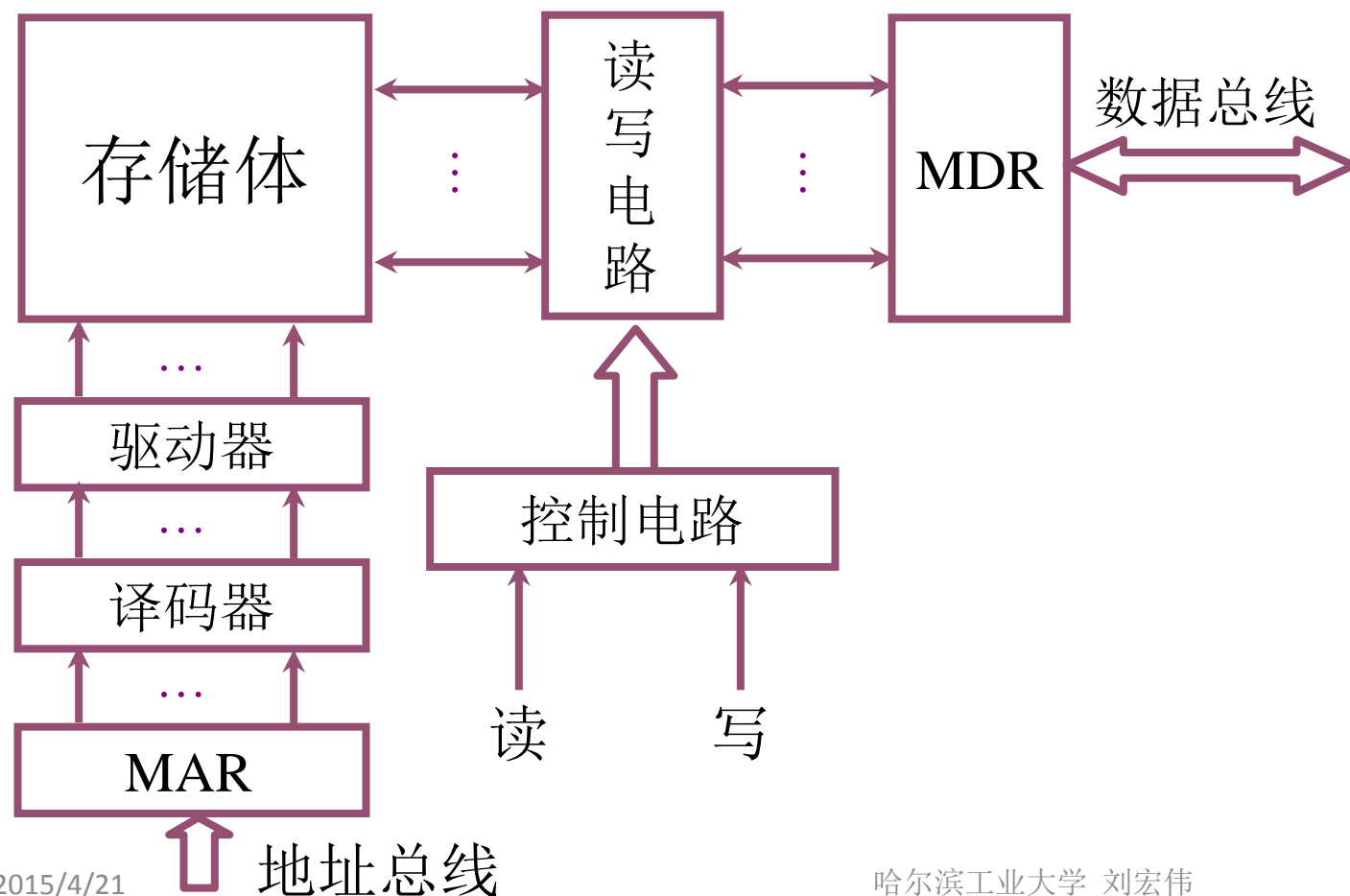


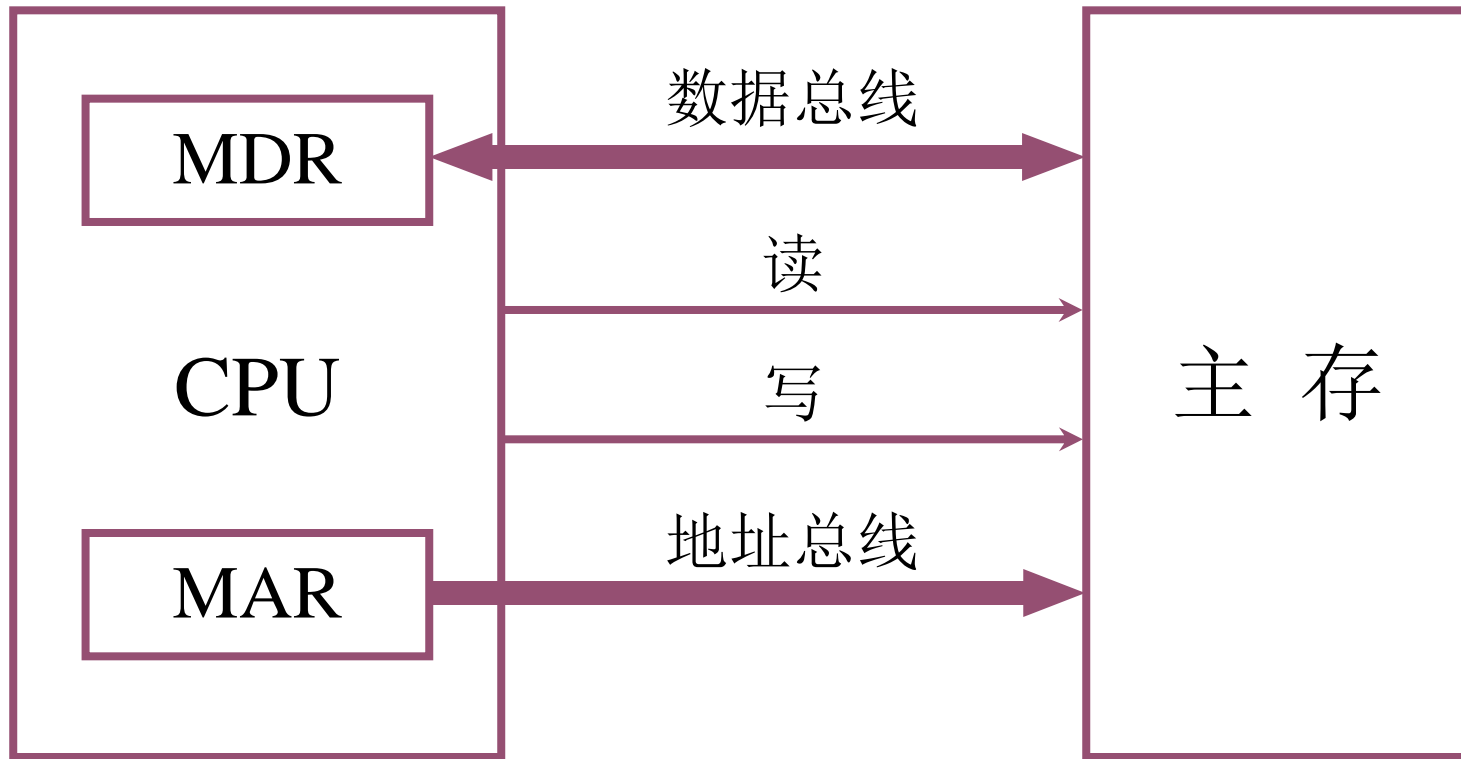
4.2 主存储器

一、概述

1. 主存的基本组成



2. 主存和 CPU 的联系



3. 主存中存储单元地址的分配

12345678H 这个数据如何在主存储器中进行存储？

高位字节 地址为字地址

字地址	字节地址			
0	12	34	56	78
4				
8				

大端、大尾方式

低位字节 地址为字地址

字地址	字节地址			
0	78	56	34	12
4				
8				

小端、小尾方式

设地址线 **24** 根 按 **字节** 寻址 $2^{24} = 16 \text{ MB}$

若字长为 **16** 位 按 **字** 寻址 **8 MW**

若字长为 **32** 位 按 **字** 寻址 **4 MW**

4. 主存的技术指标

4.2

(1) 存储容量 主存 存放二进制代码的总位数

(2) 存储速度

- 存取时间 存储器的 访问时间

读出时间 写入时间

- 存取周期 连续两次独立的存储器操作

(读或写) 所需的 最小间隔时间

读周期 写周期

(3) 存储器的带宽 位/秒

4.2 主存储器

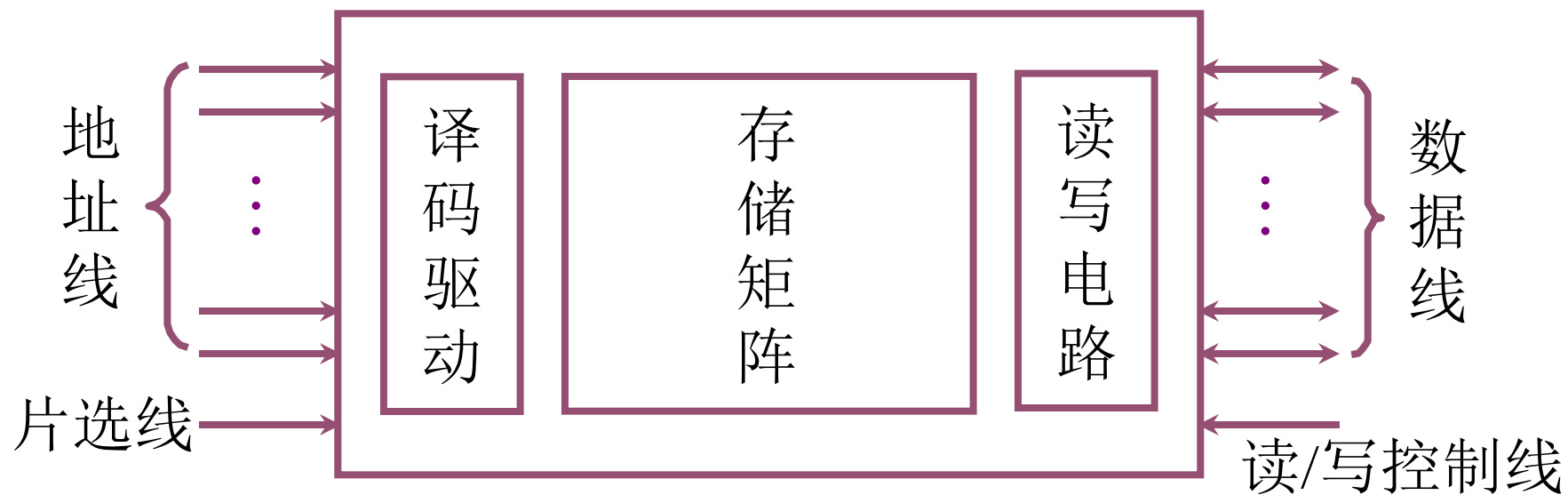
- 一、概述
- 二、半导体存储芯片简介
- 三、随机存取存储器 (RAM)
- 四、只读存储器 (ROM)
- 五、存储器与 CPU 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

4.2 主存储器———半导体芯片简介

- 1. 半导体存储芯片的基本结构
- 2. 半导体存储芯片的译码驱动方式
 - ✓线选法
 - ✓重合法

二、半导体存储芯片简介

1. 半导体存储芯片的基本结构



地址线（单向）

数据线（双向）

芯片容量

10

4

1K×4位

14

1

16K×1位

13

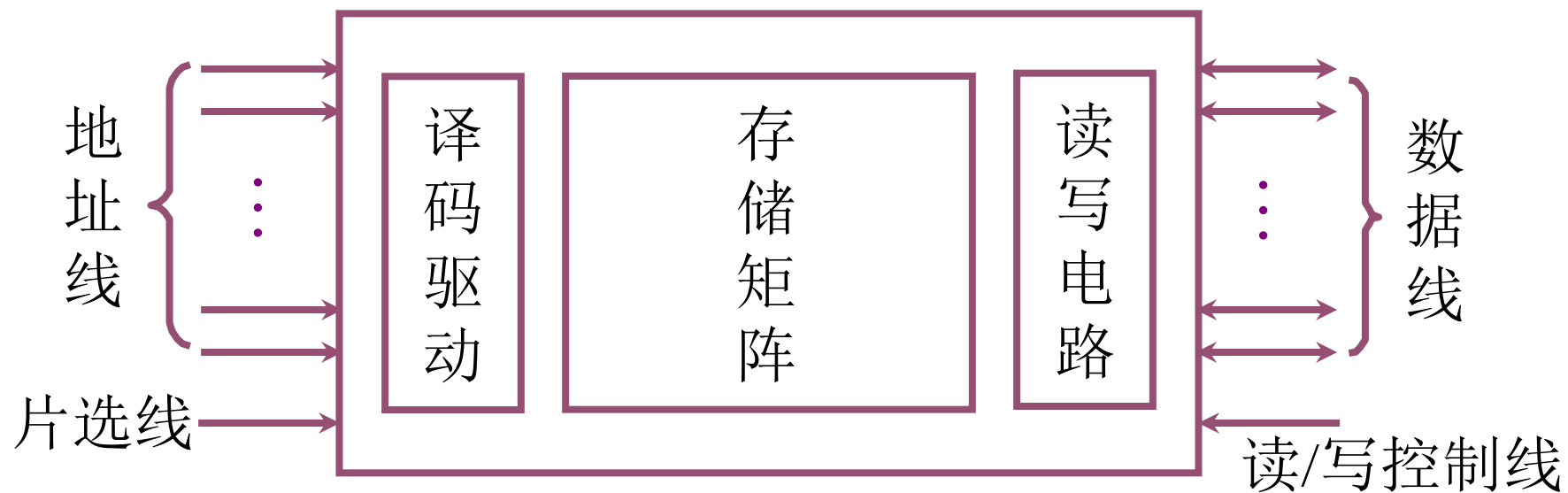
8

8K×8位

二、半导体存储芯片简介

4.2

1. 半导体存储芯片的基本结构



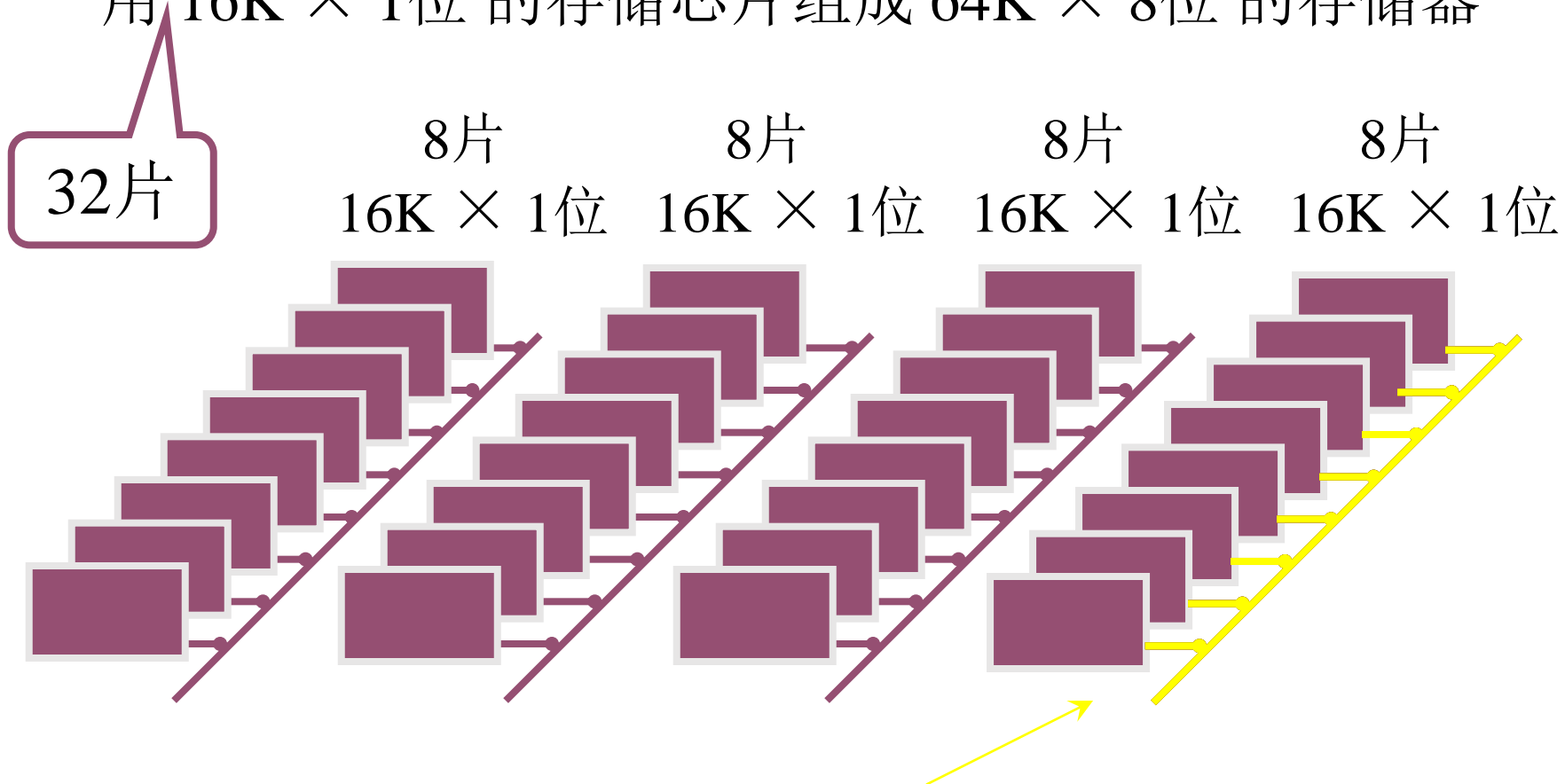
片选线 \overline{CS} \overline{CE}

读/写控制线 \overline{WE} (低电平写 高电平读)

\overline{OE} (允许读) \overline{WE} (允许写)

存储芯片片选线的作用

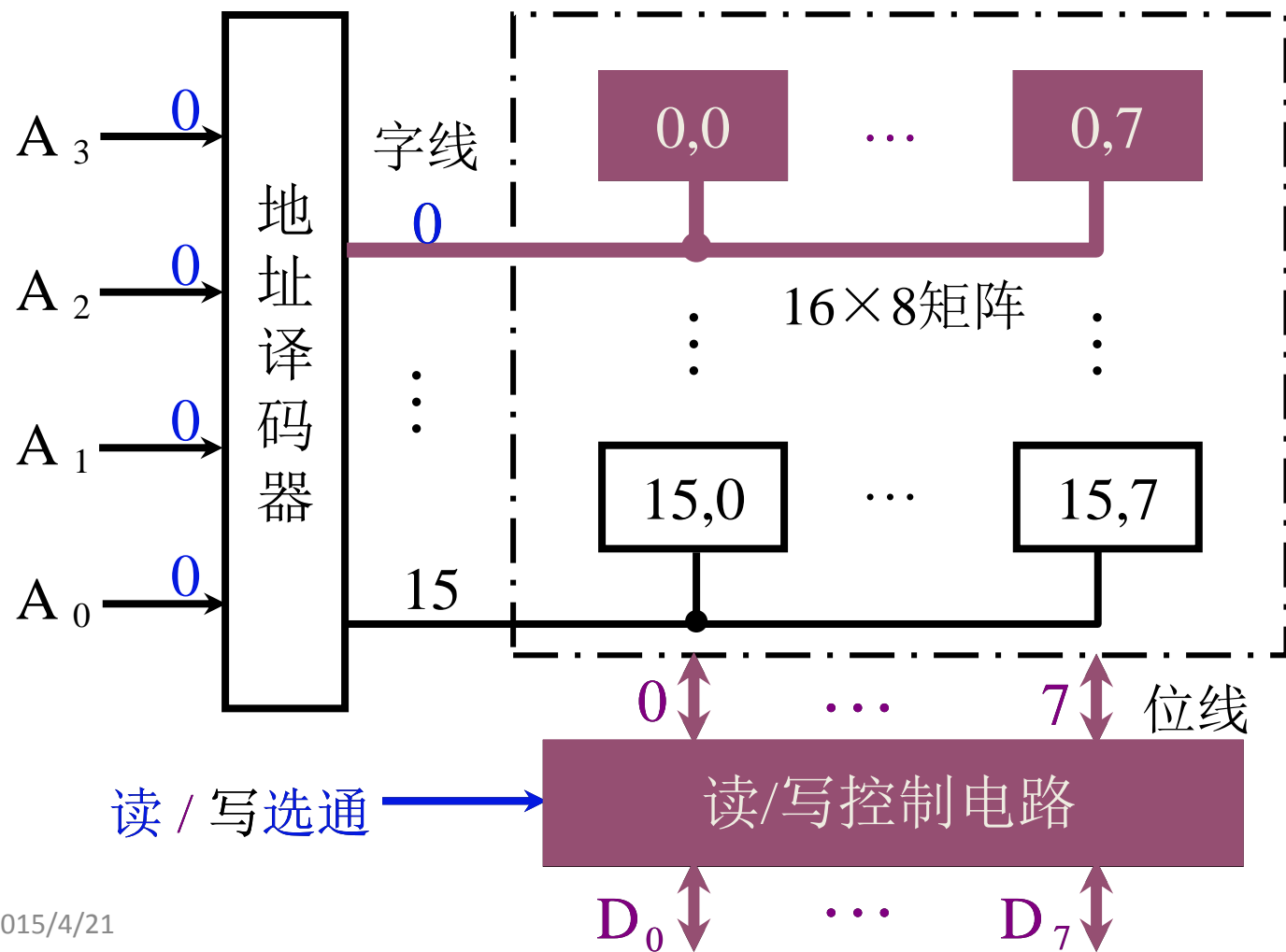
用 $16\text{K} \times 1$ 位的存储芯片组成 $64\text{K} \times 8$ 位的存储器



当地址为 65 535 时，此 8 片的片选有效

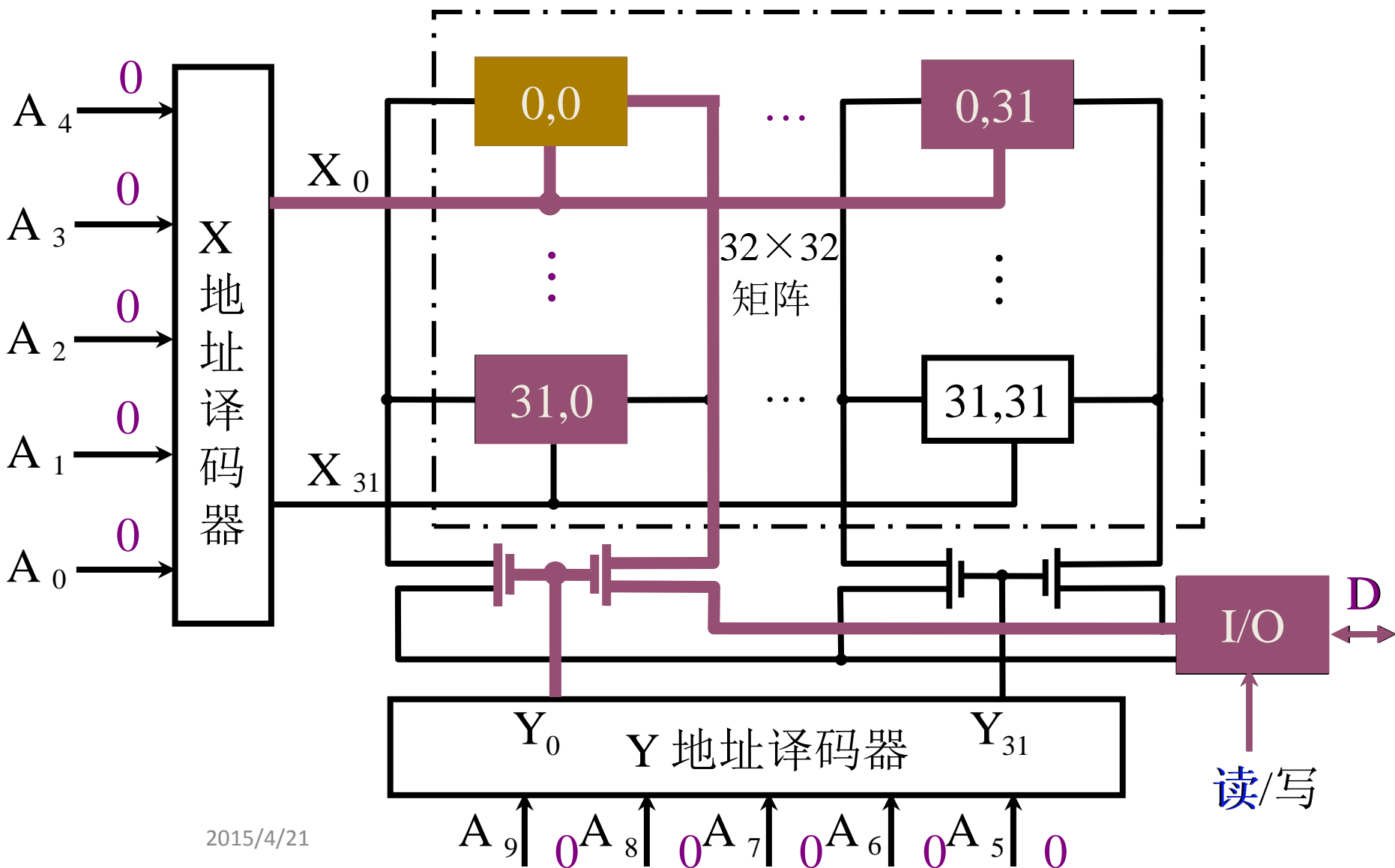
2. 半导体存储芯片的译码驱动方式 4.2

(1) 线选法



(2) 重合法

4.2



4.2 主存储器

- 一、概述
- 二、半导体存储芯片简介
- 三、随机存取存储器 (**RAM**)
- 四、只读存储器 (**ROM**)
- 五、存储器与 **CPU** 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

4.2 主存储器——随机存取存储器

- 1. 静态 RAM (SRAM)

- ✓保存0和1的原理是什么？
- ✓基本单元电路的构成是什么？
- ✓对单元电路如何读出和写入？
- ✓典型芯片的结构是很么样子的？
- ✓静态RAM芯片的如何进行读出和写入操作？

- 2. 动态 RAM (DRAM)

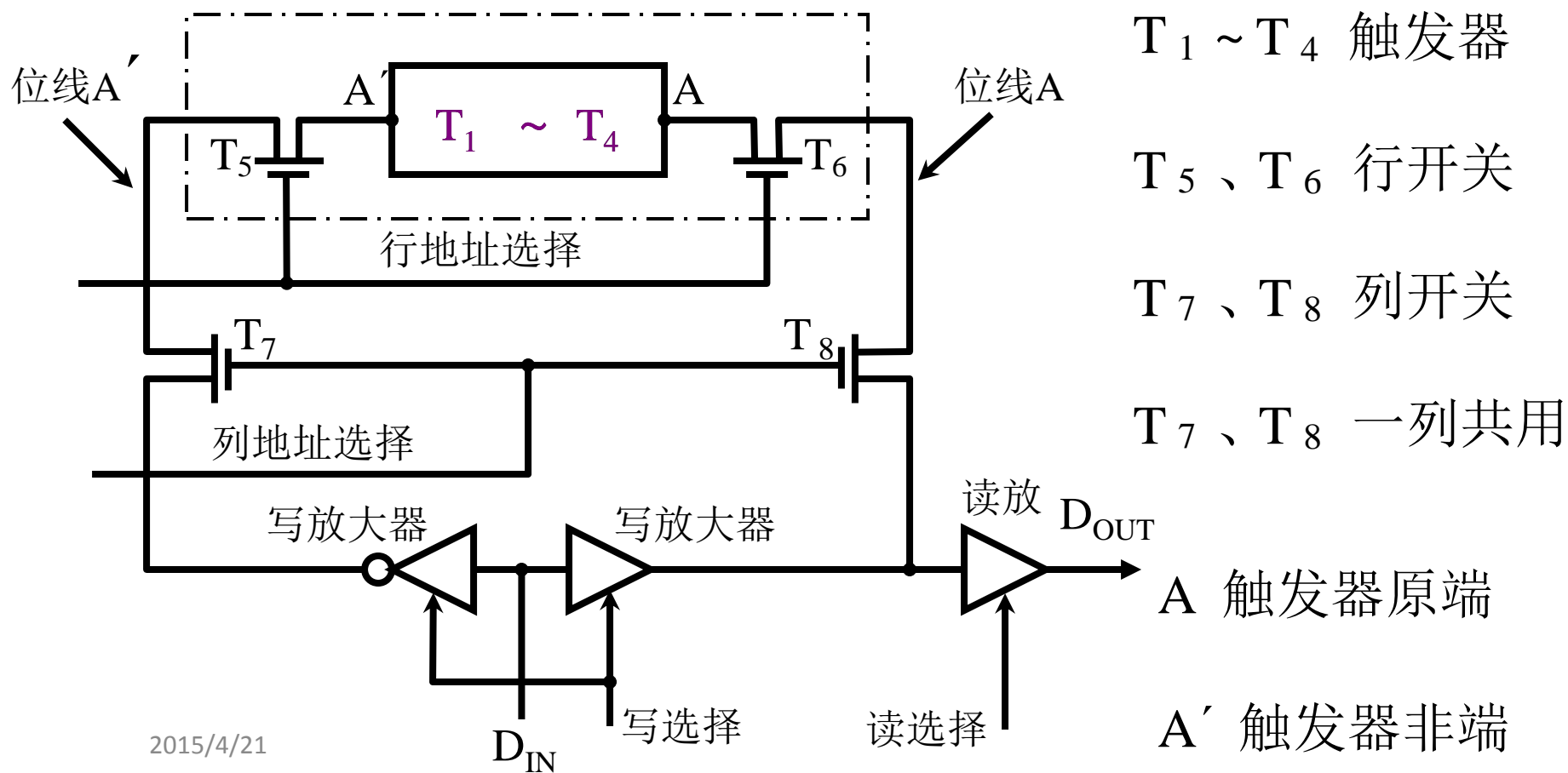
- 3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较

三、随机存取存储器 (RAM)

4.2

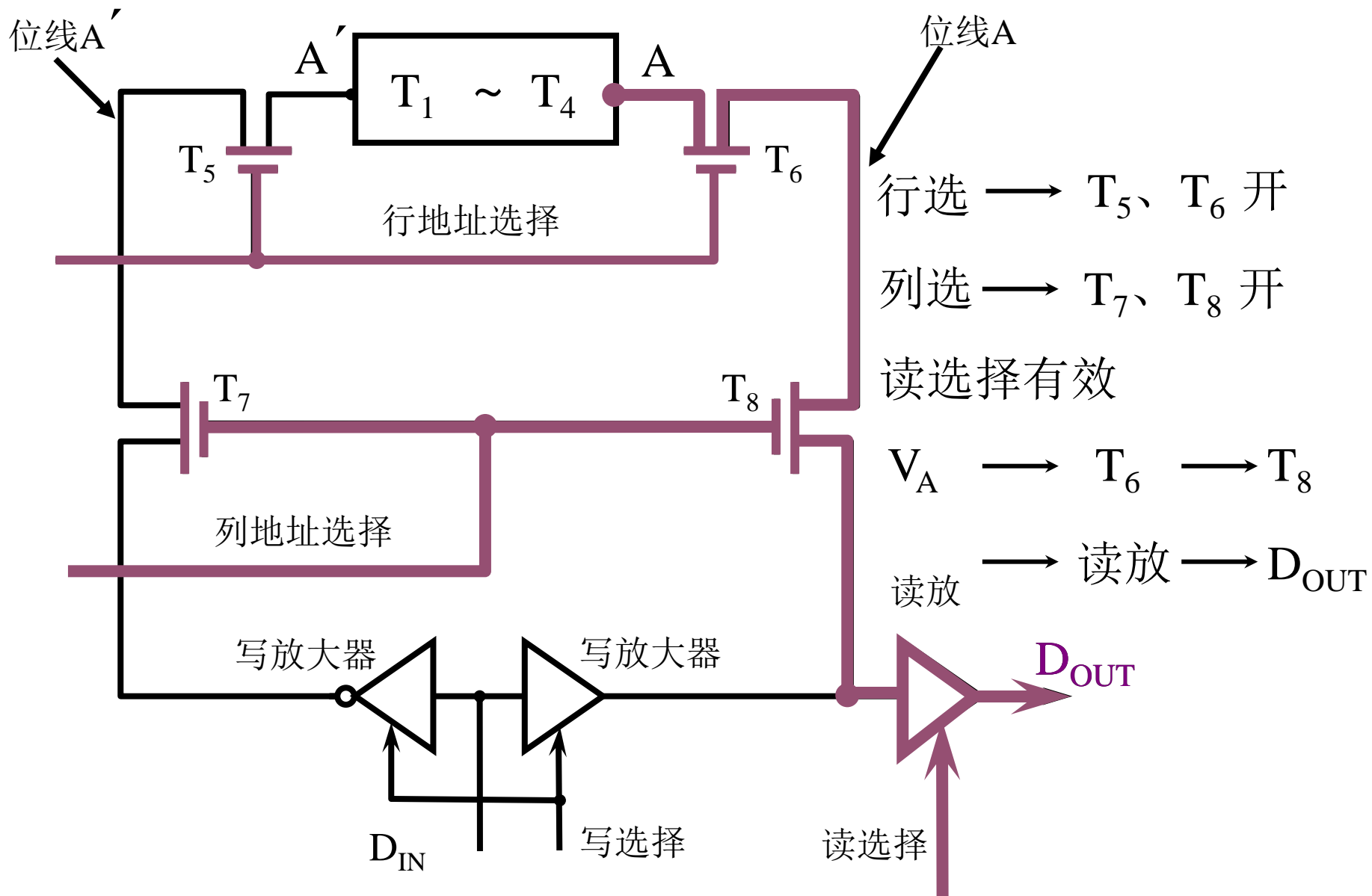
1. 静态 RAM (SRAM)

(1) 静态 RAM 基本电路



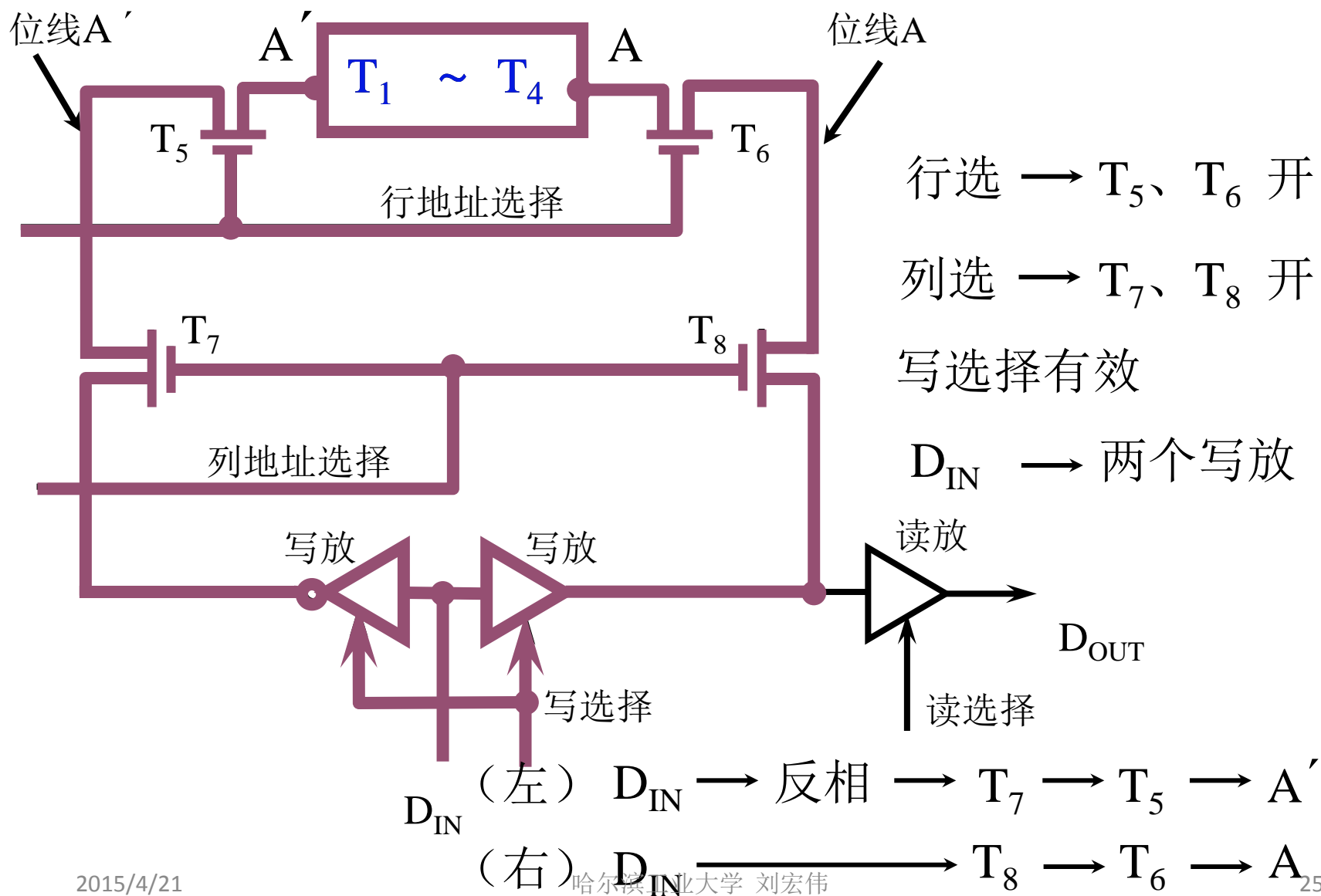
① 静态 RAM 基本电路的 读 操作

4.2



② 静态 RAM 基本电路的 写 操作

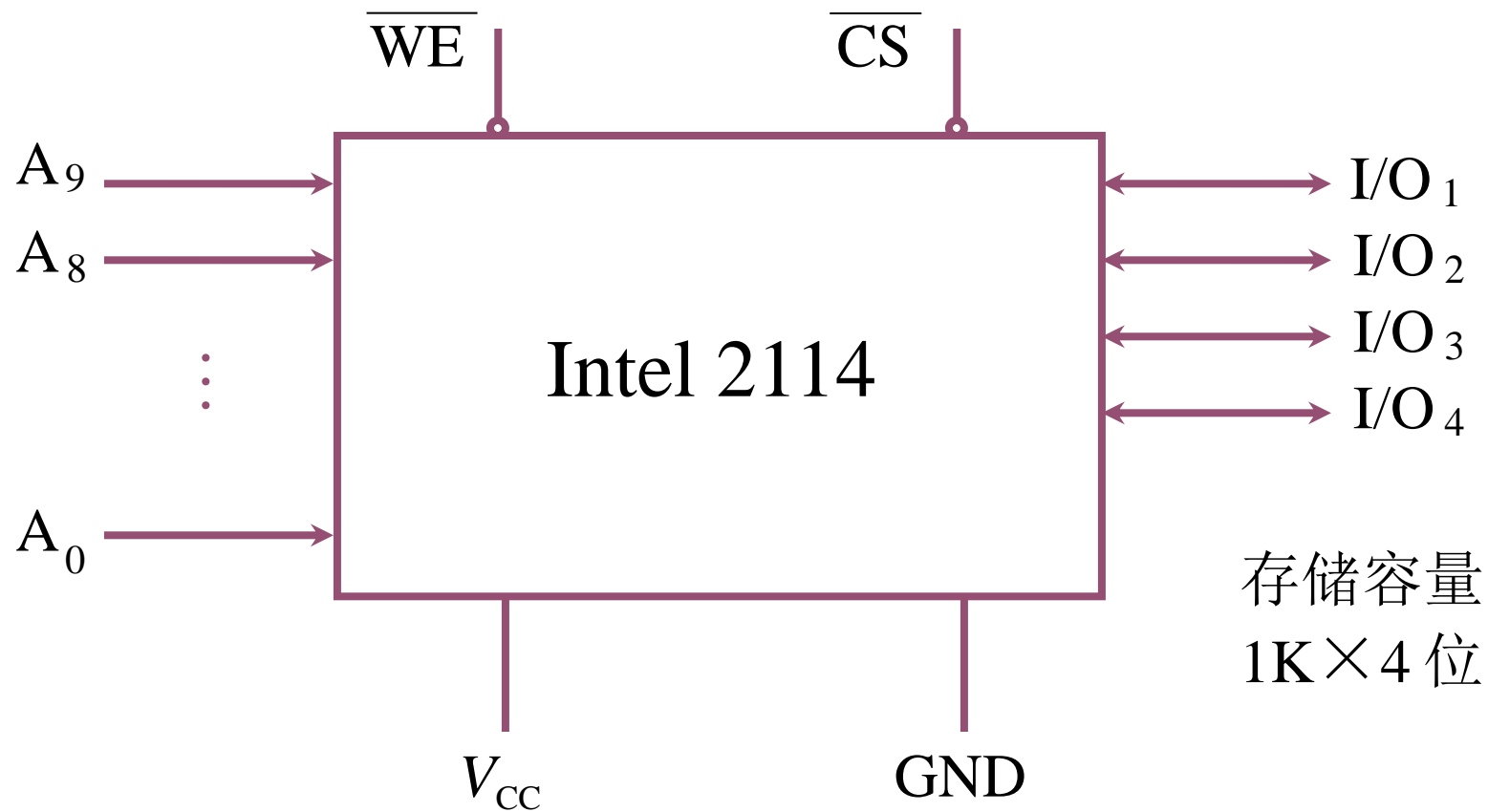
4.2



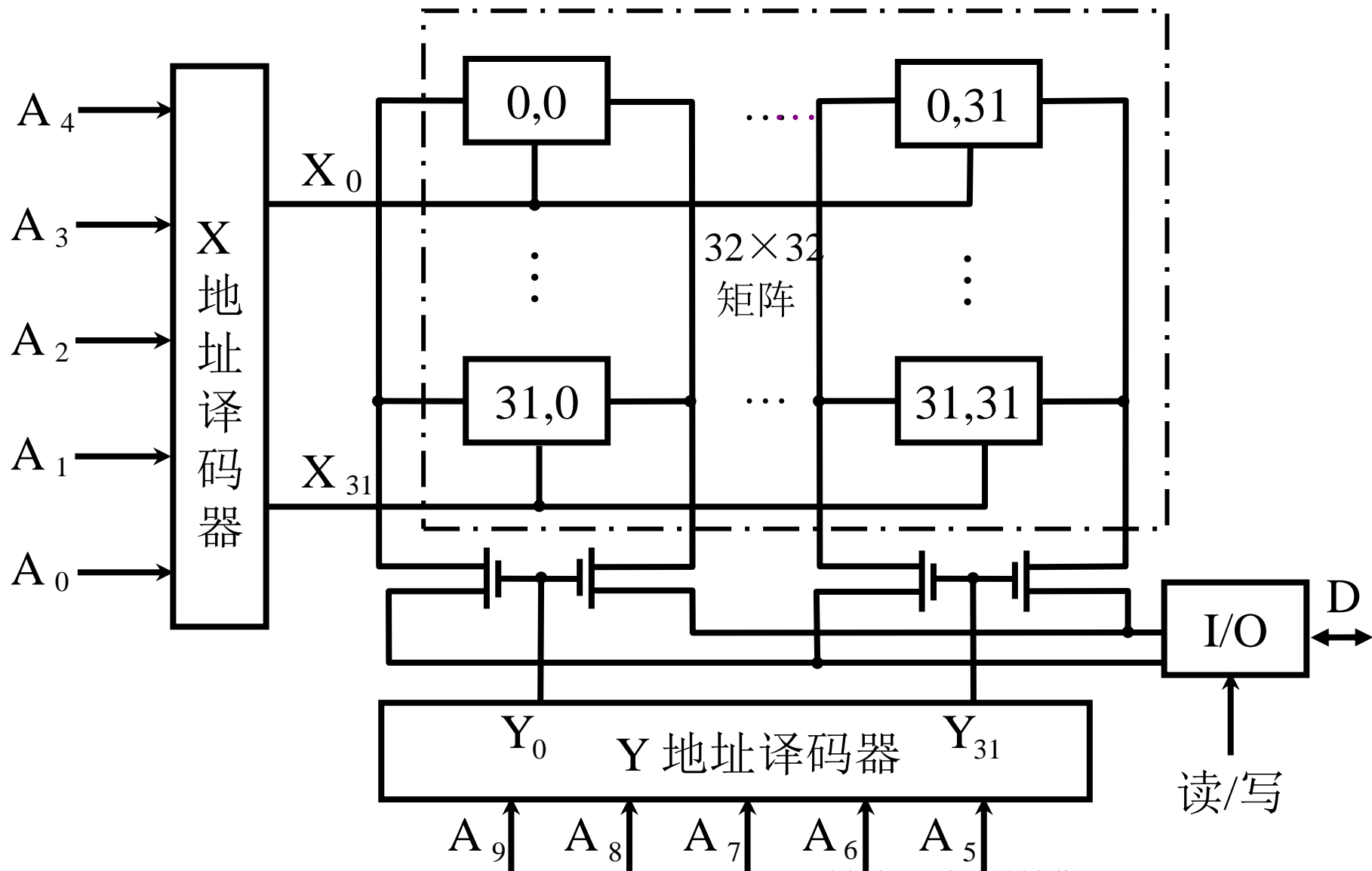
4.2

(2) 静态 RAM 芯片举例

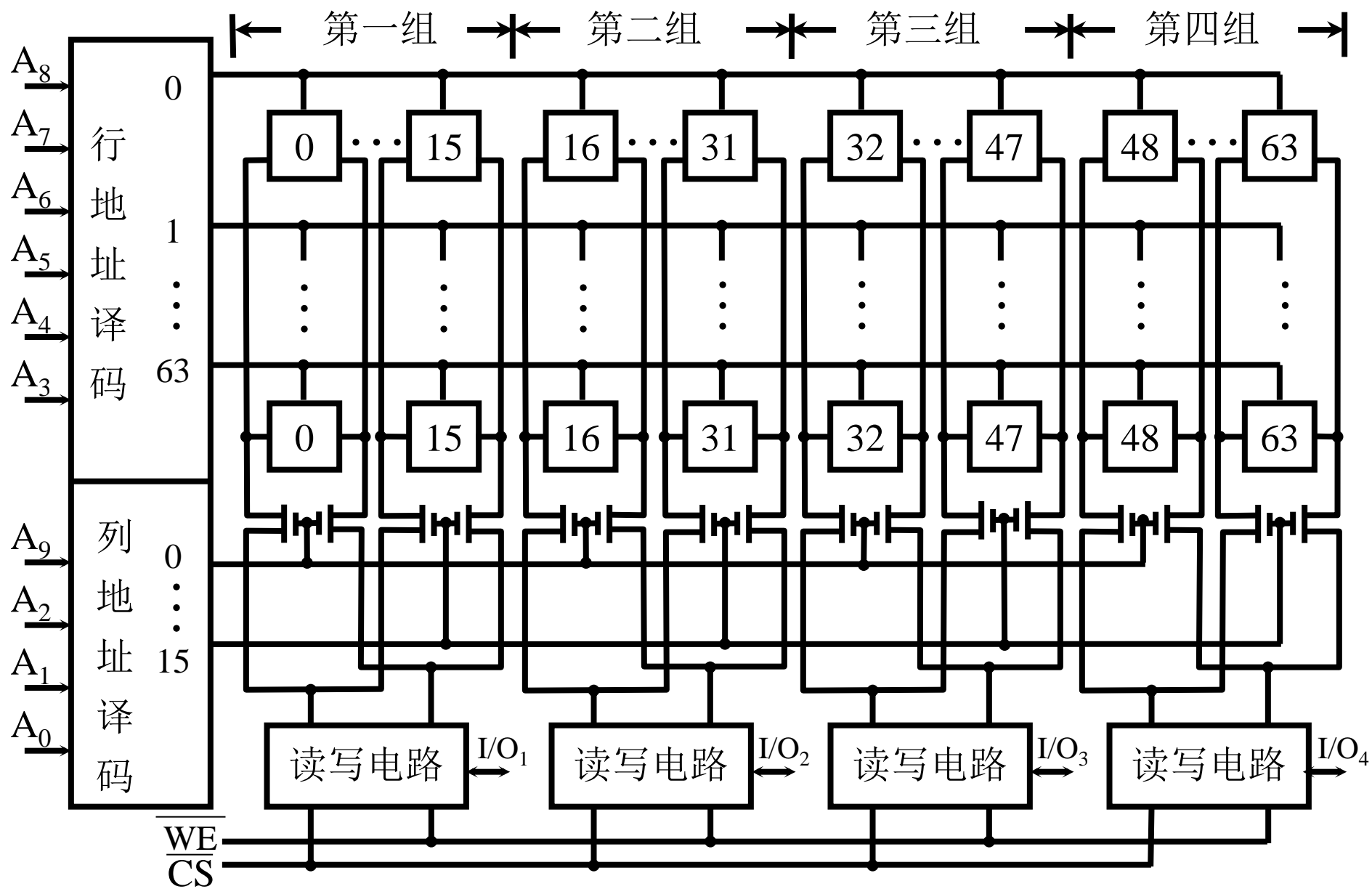
① Intel 2114 外特性



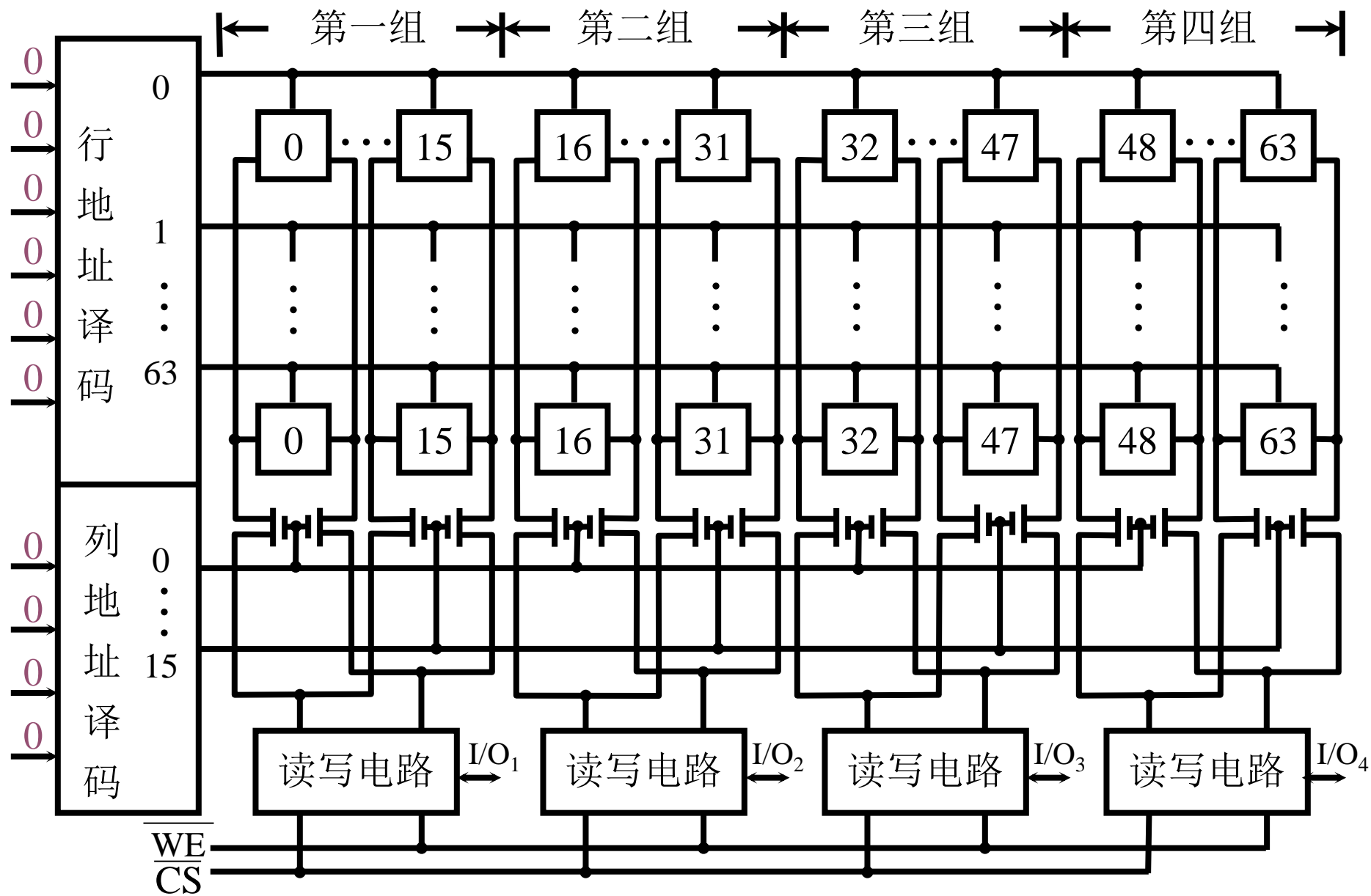
曾经讲到过的重合法，怎么实现选一次四列？



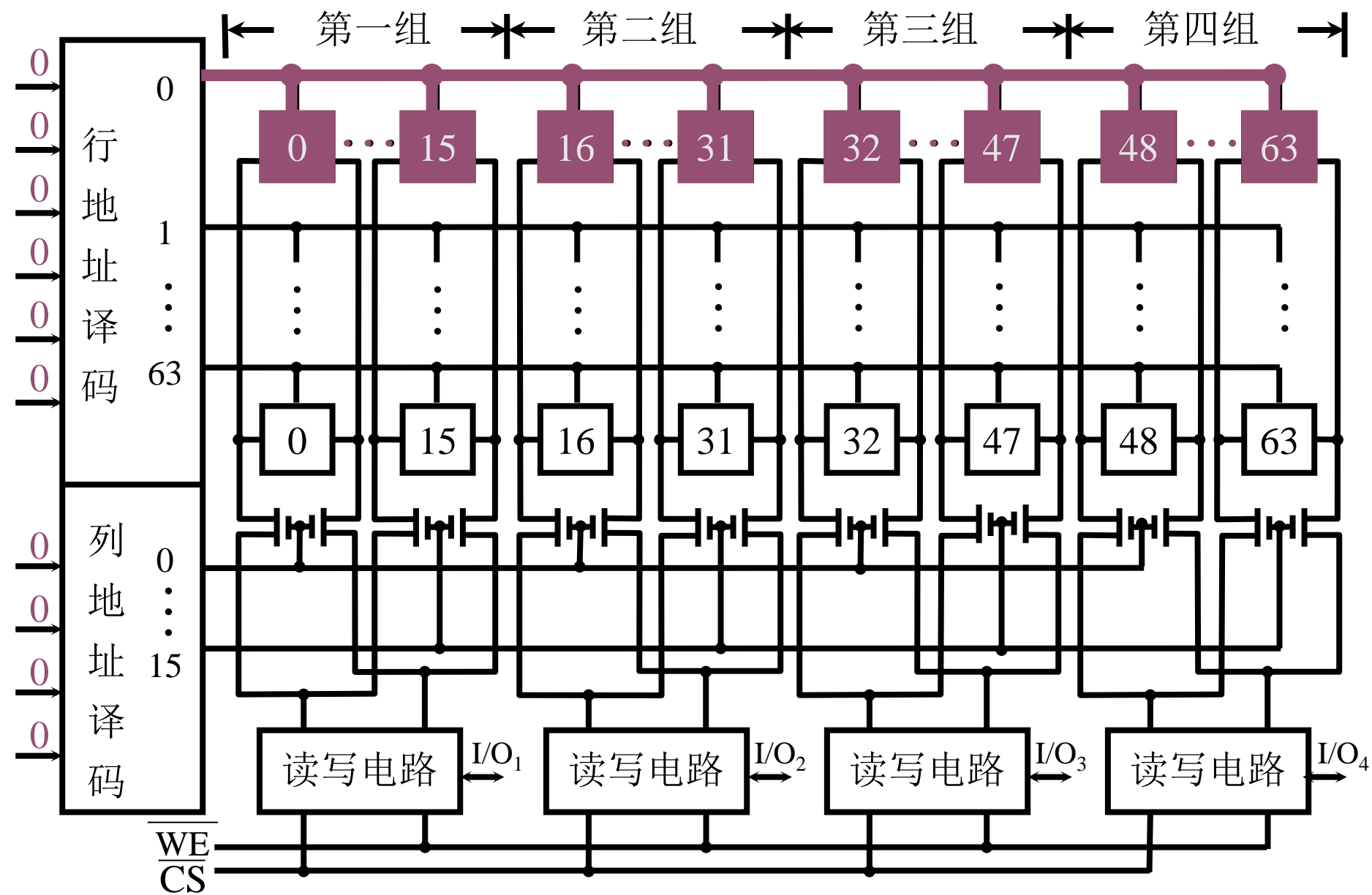
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2



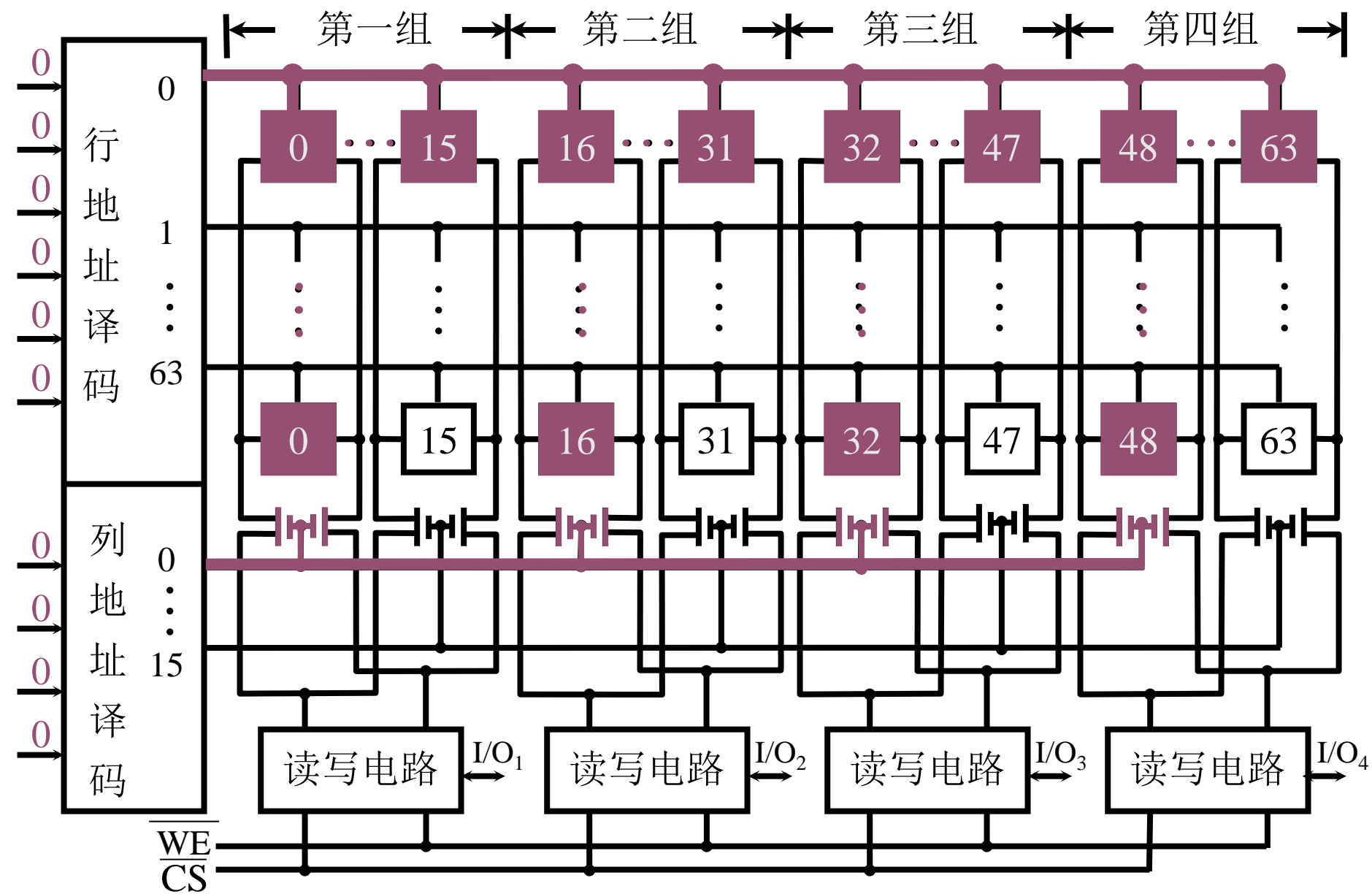
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2



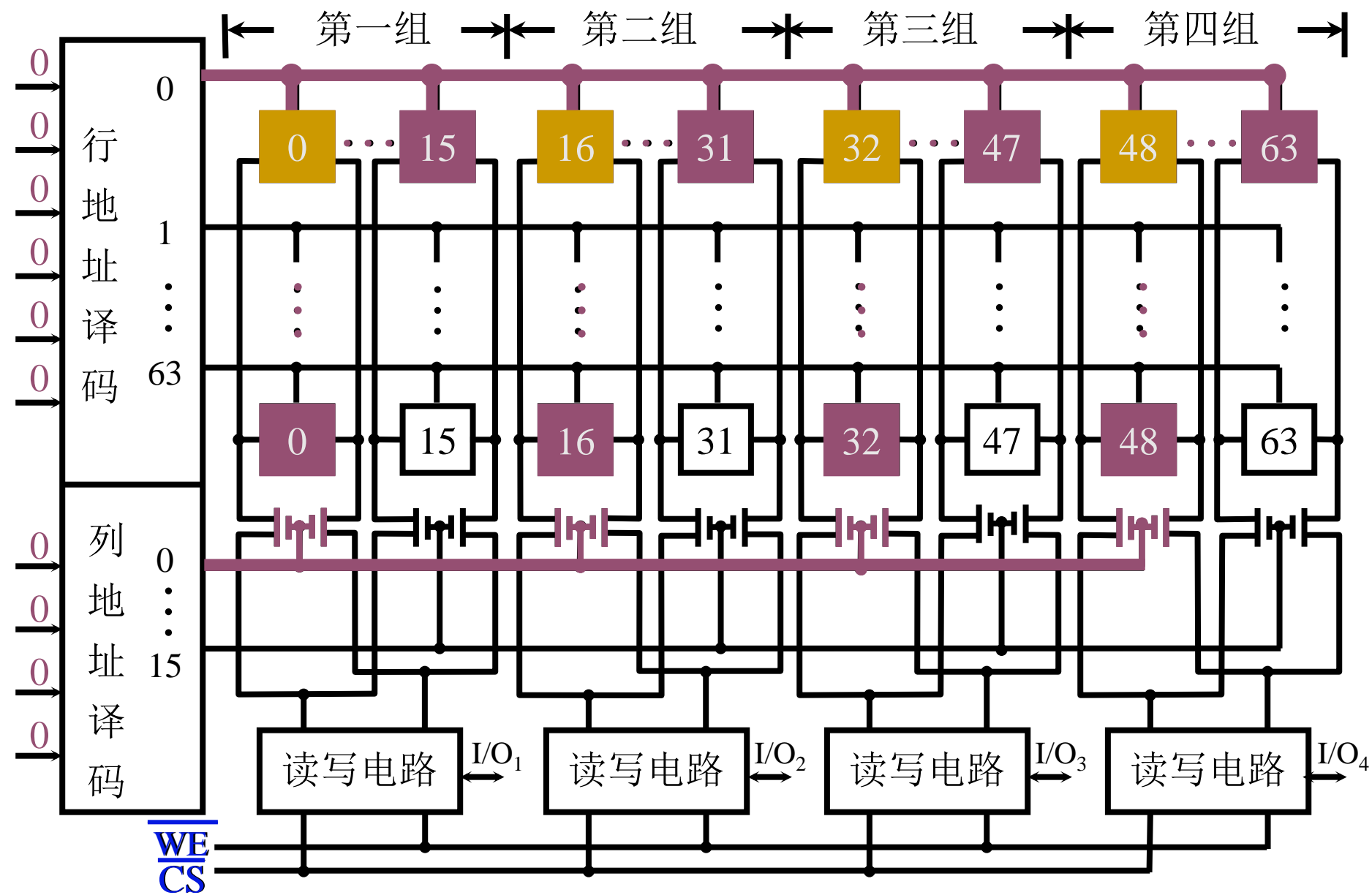
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2



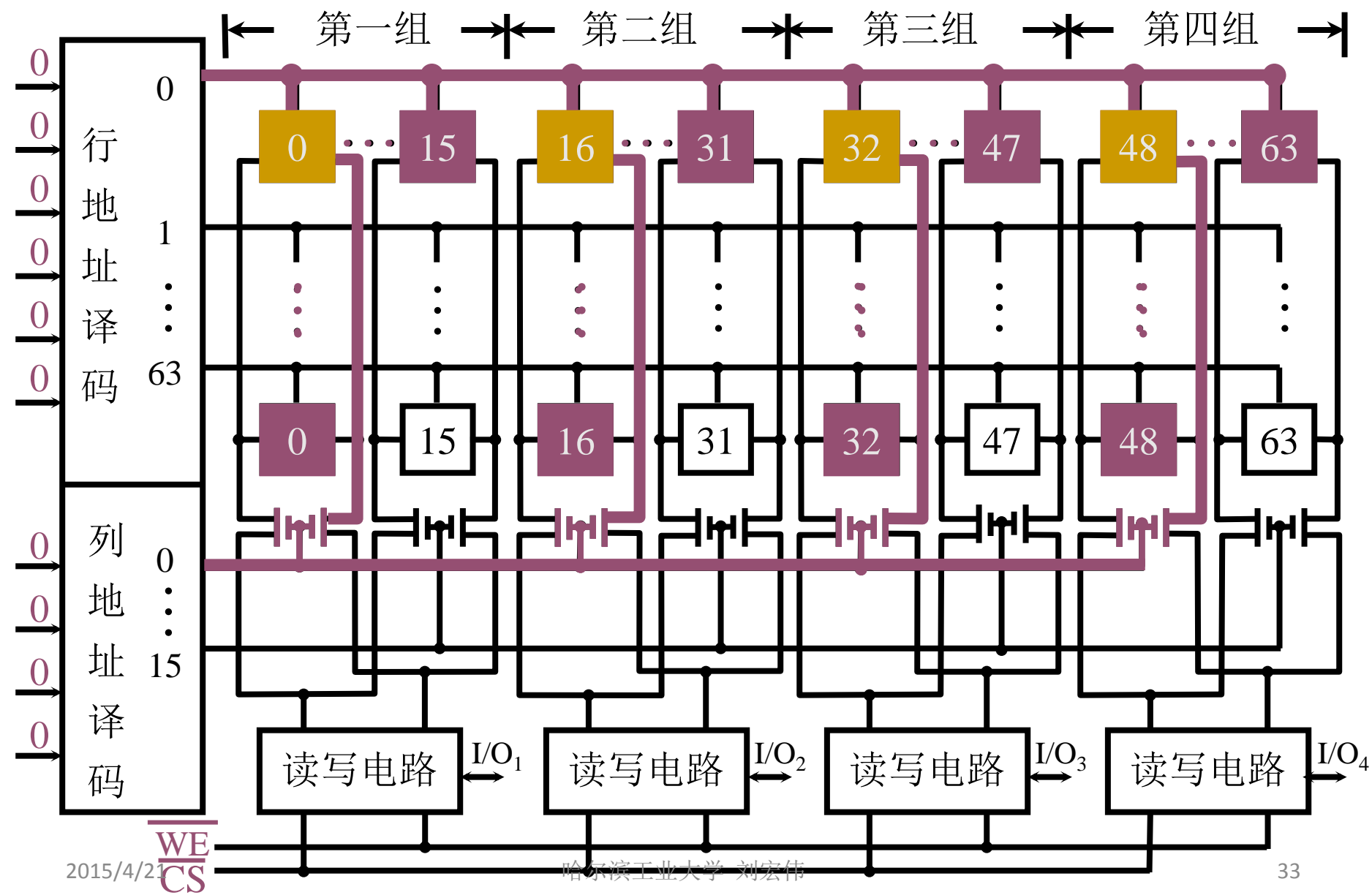
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2



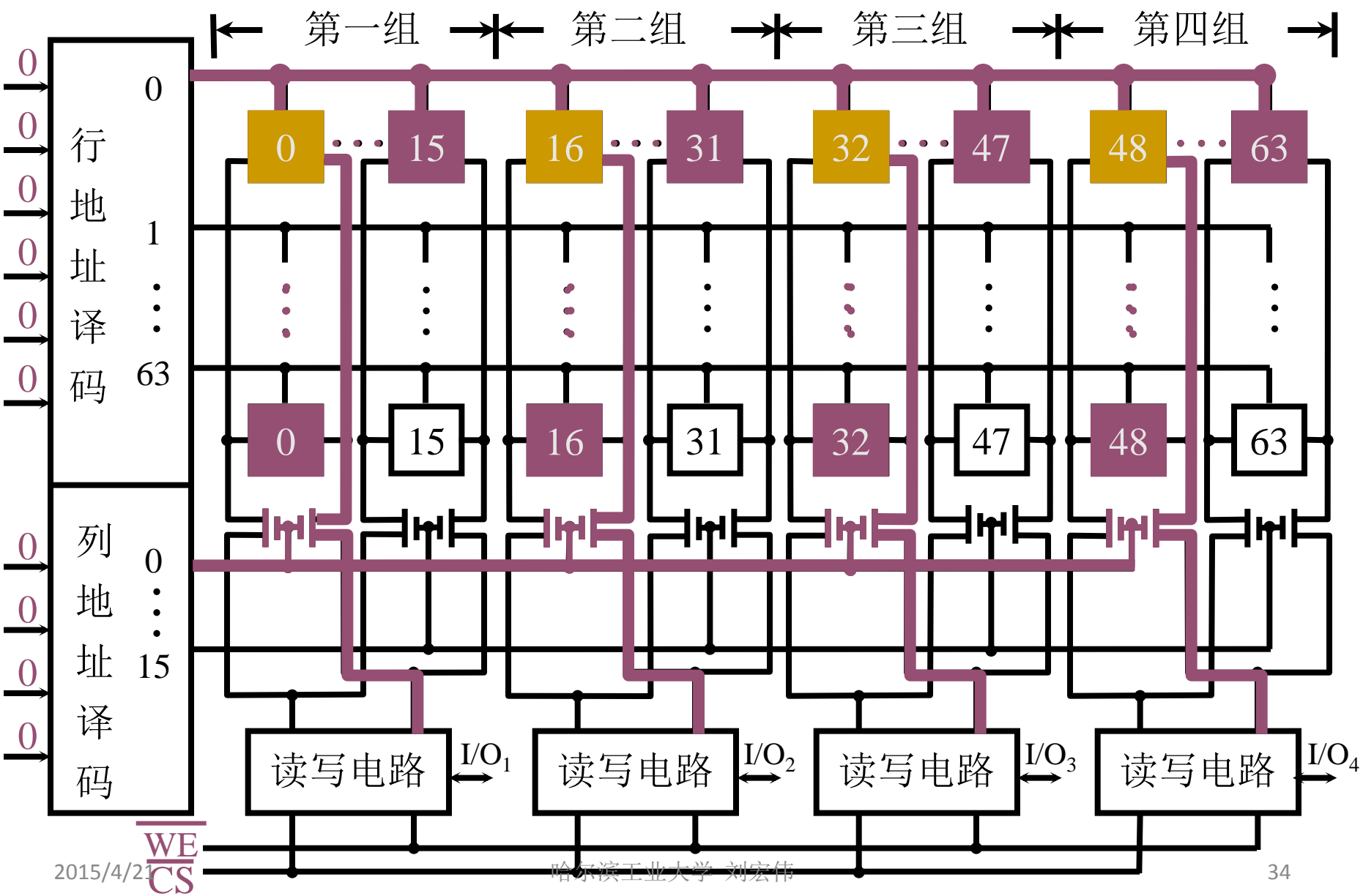
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2



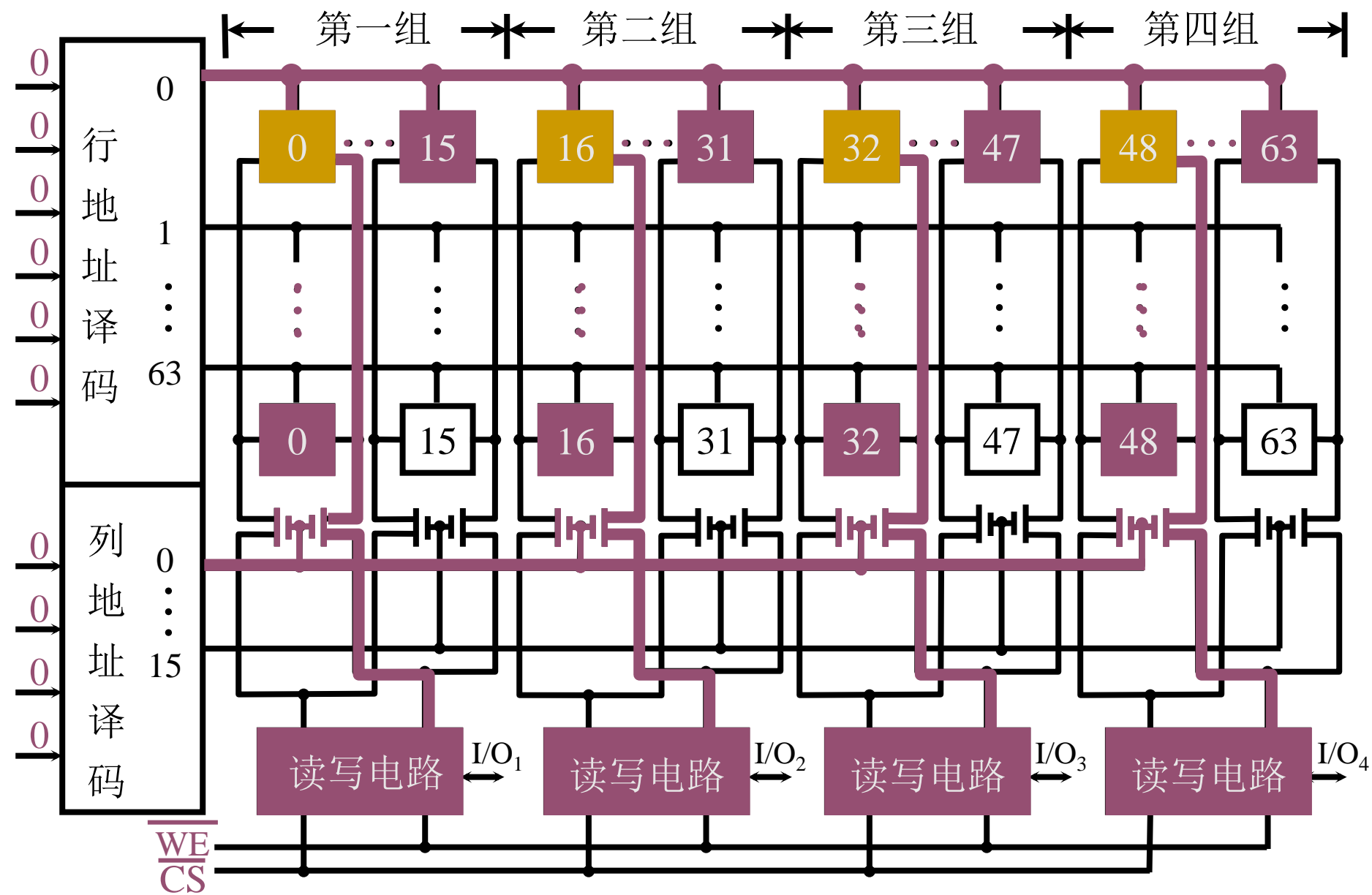
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2



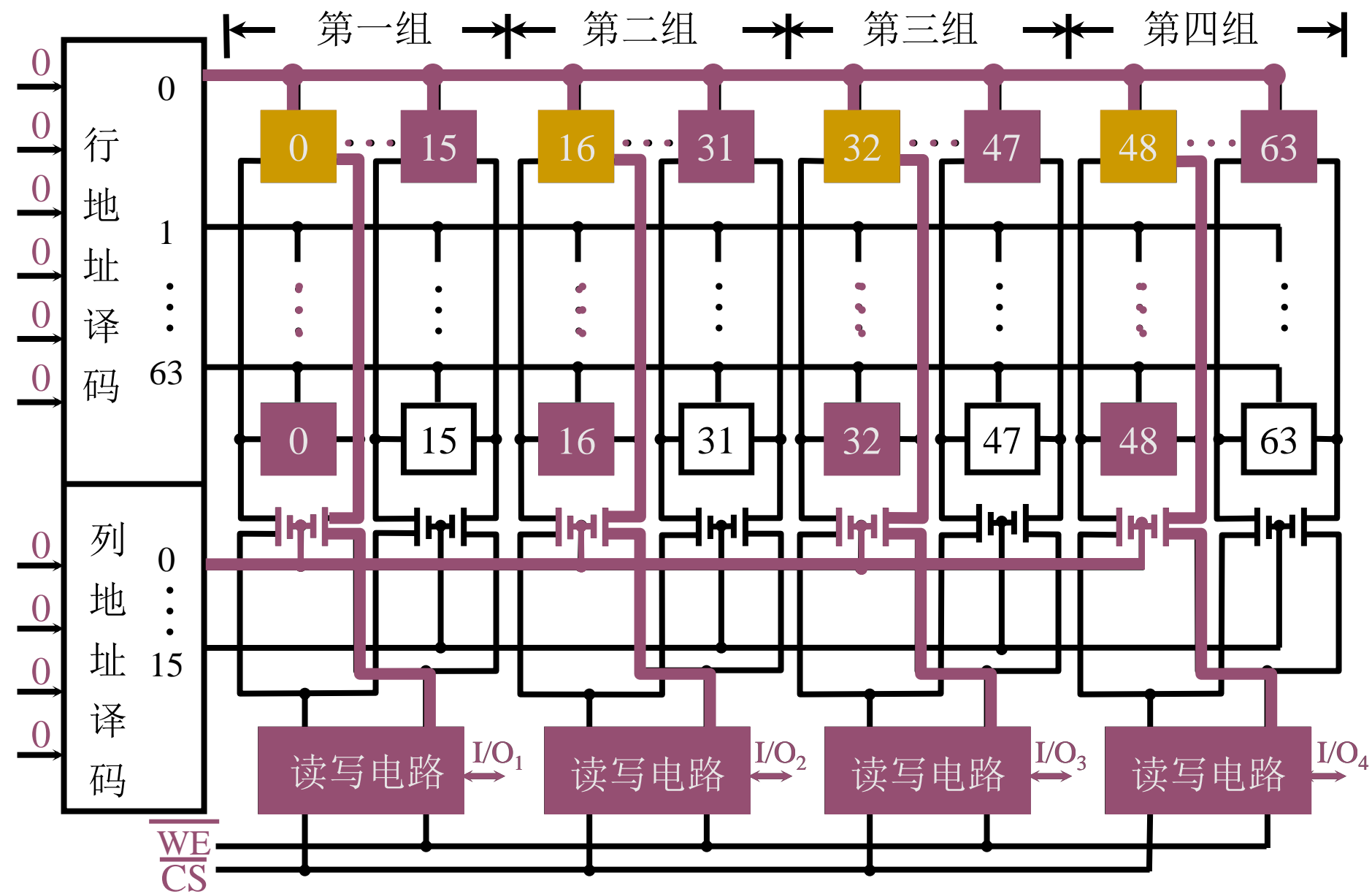
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2



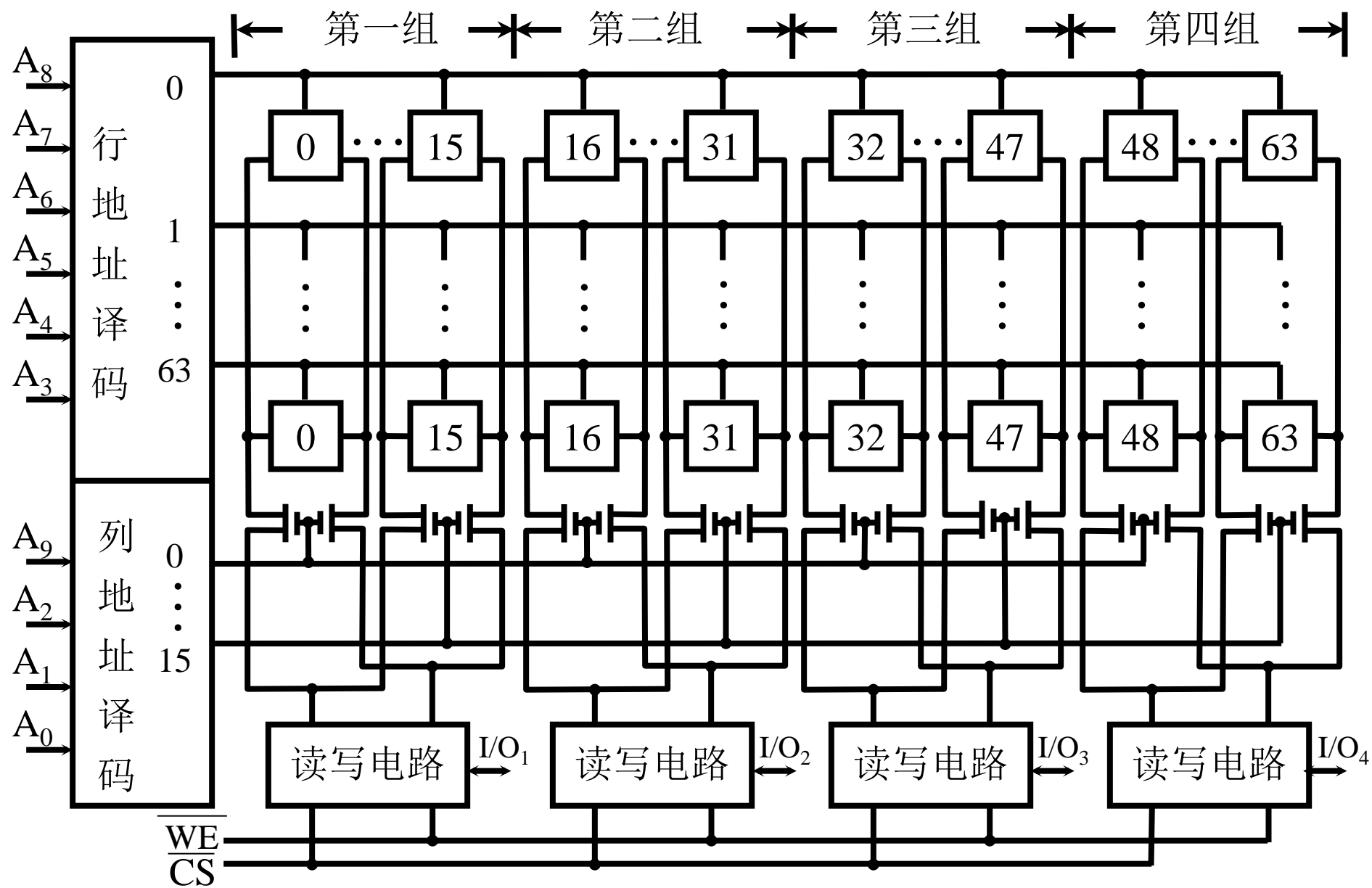
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 读 4.2



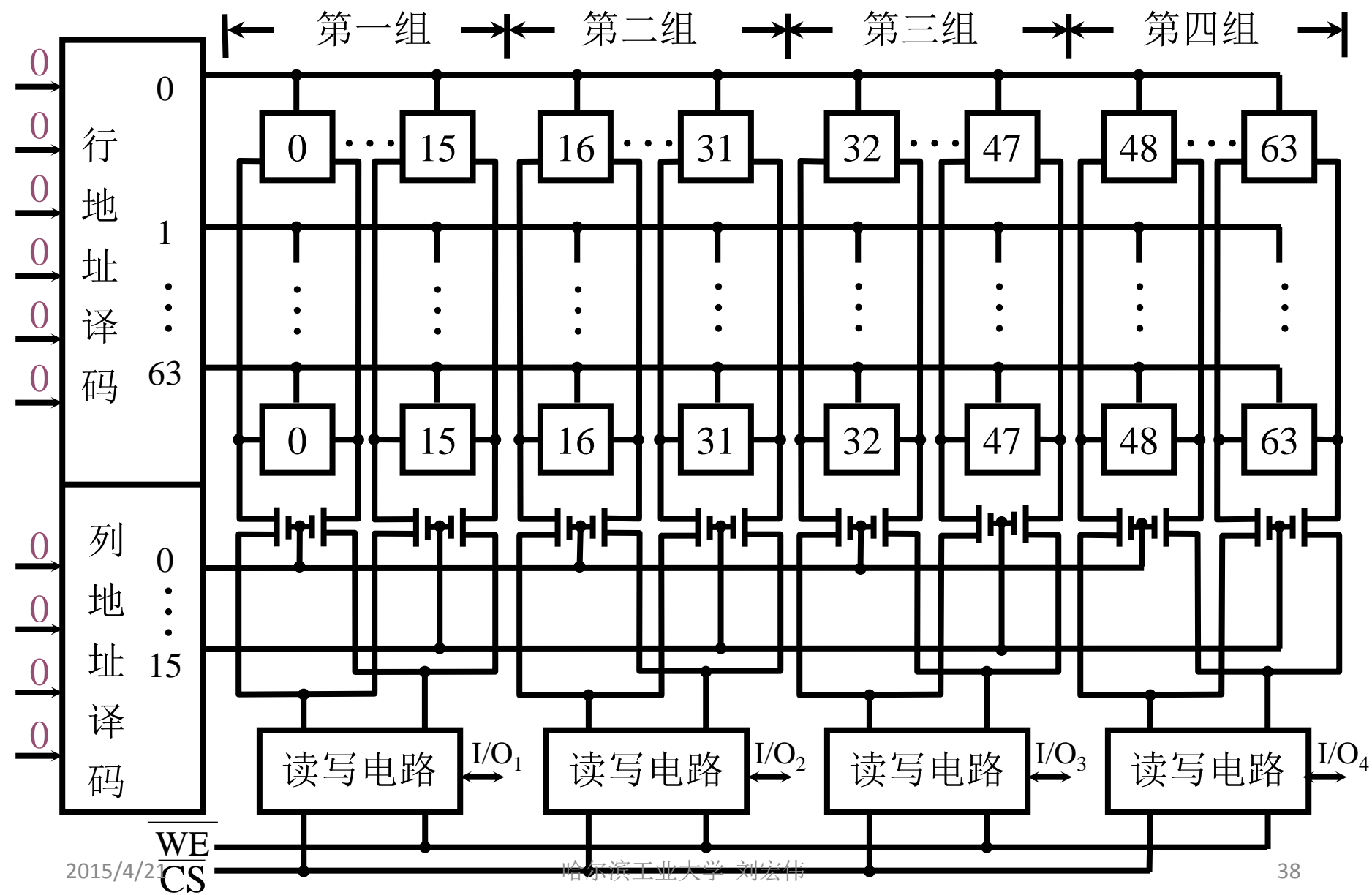
② Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读 4.2



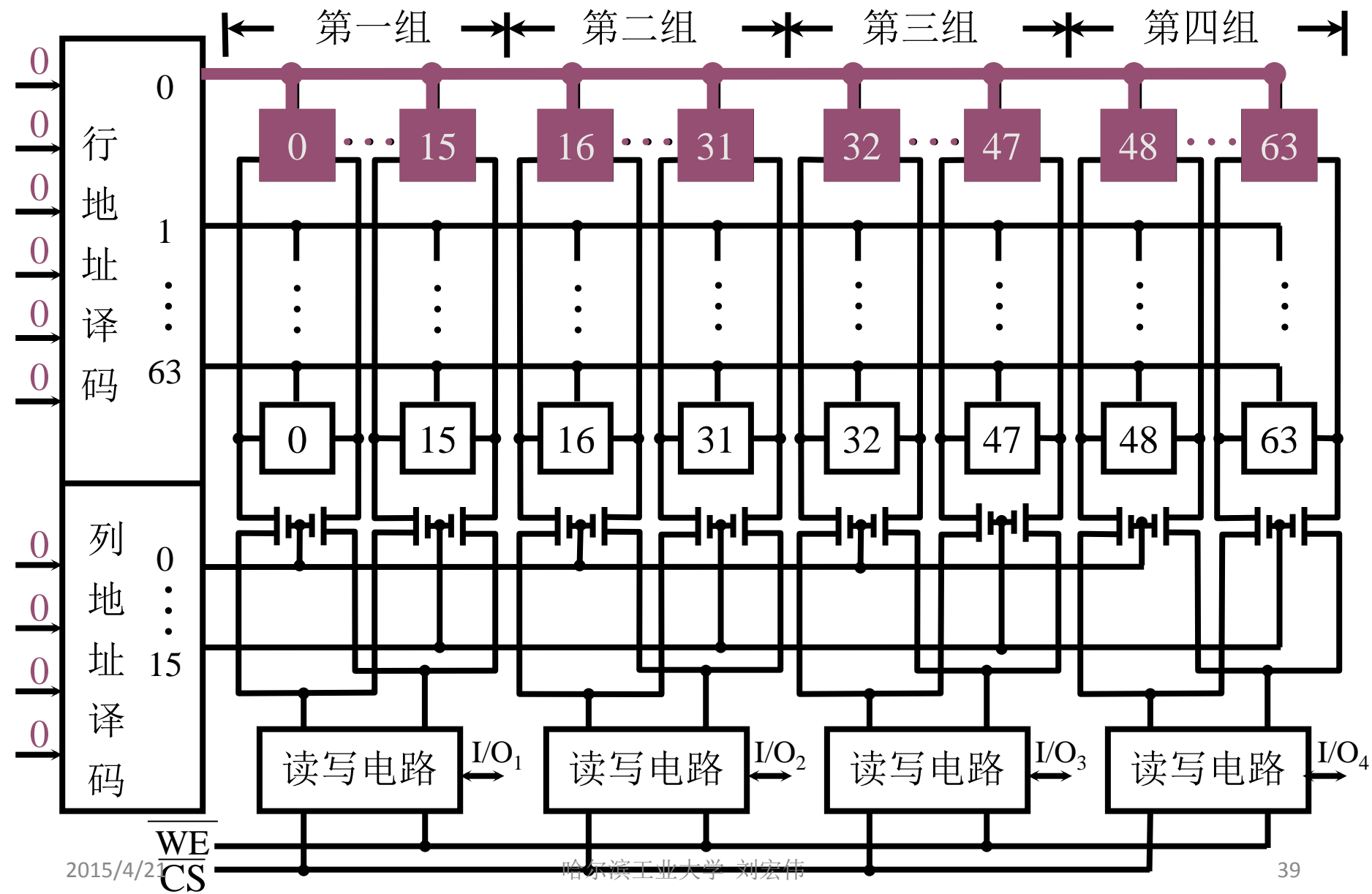
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 写 4.2



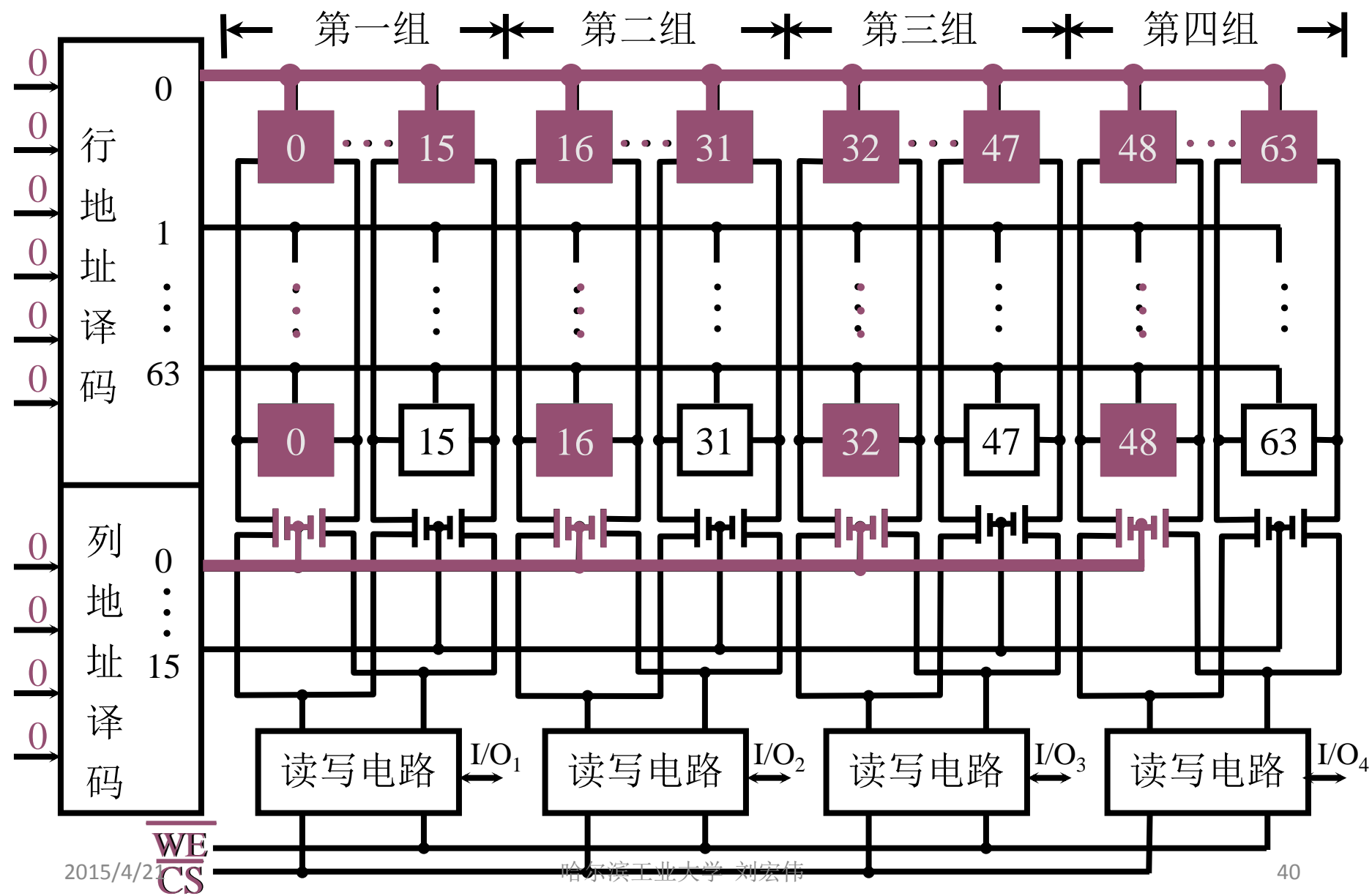
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 写 4.2



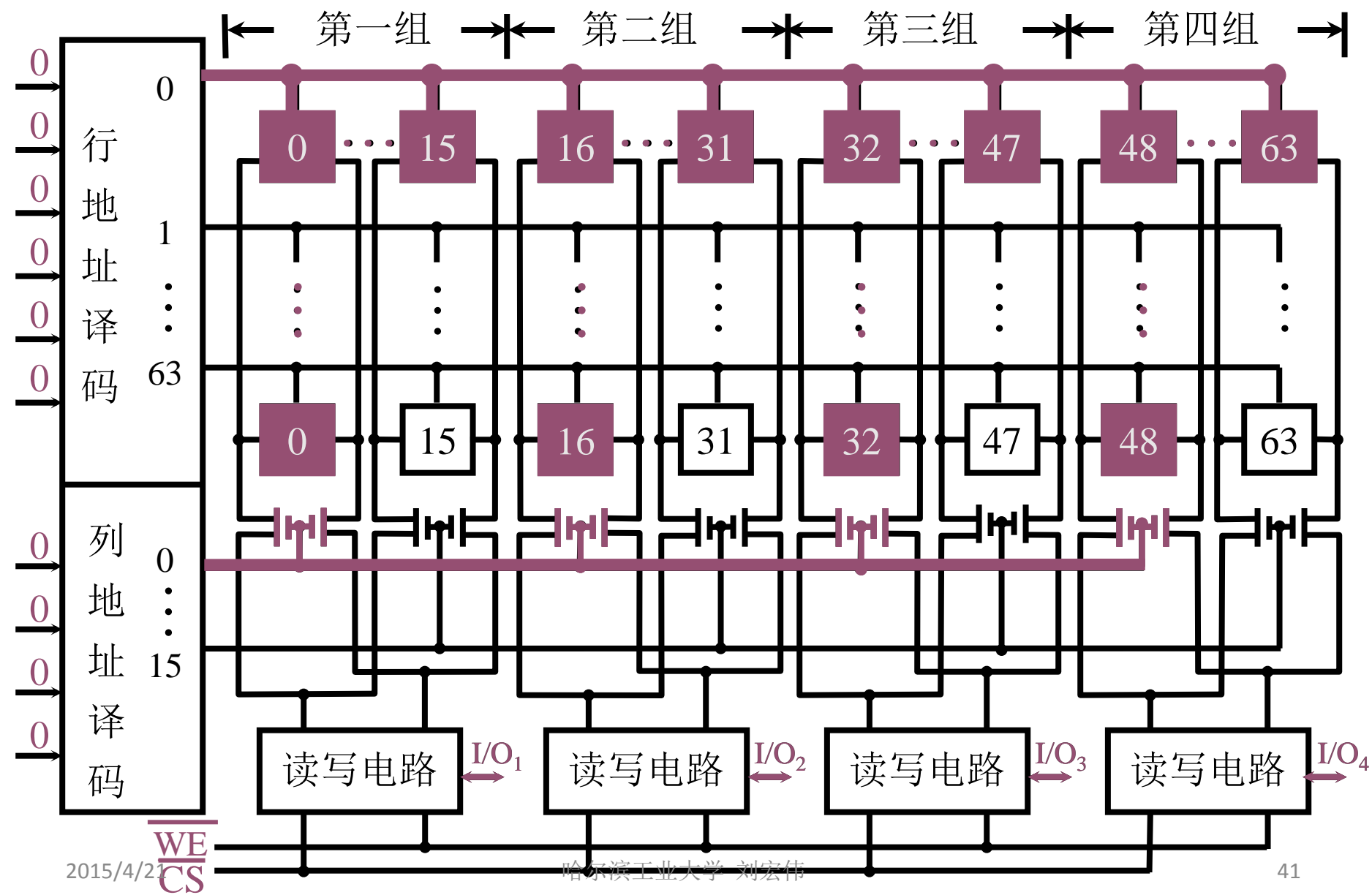
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 写 4.2



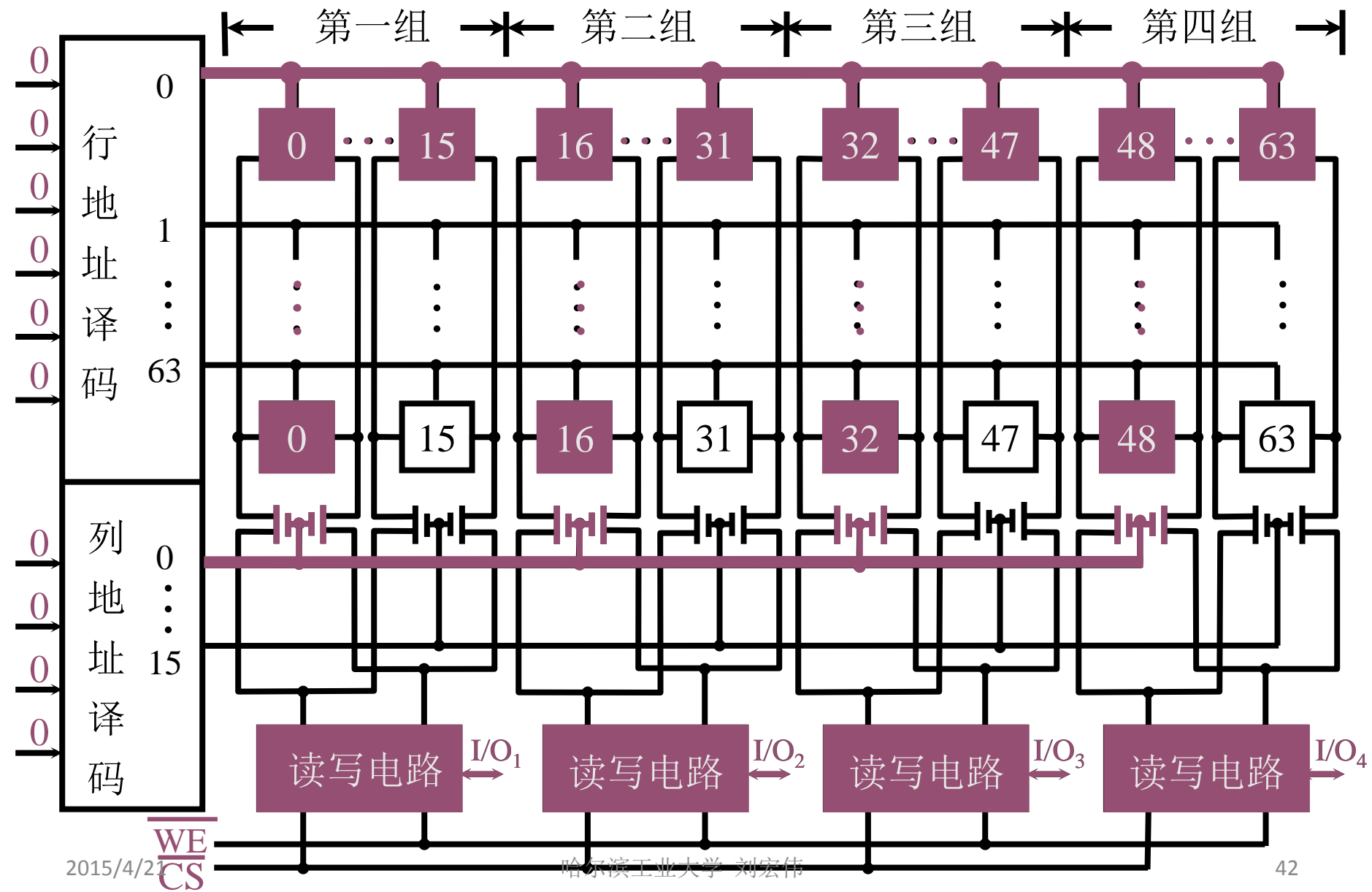
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2



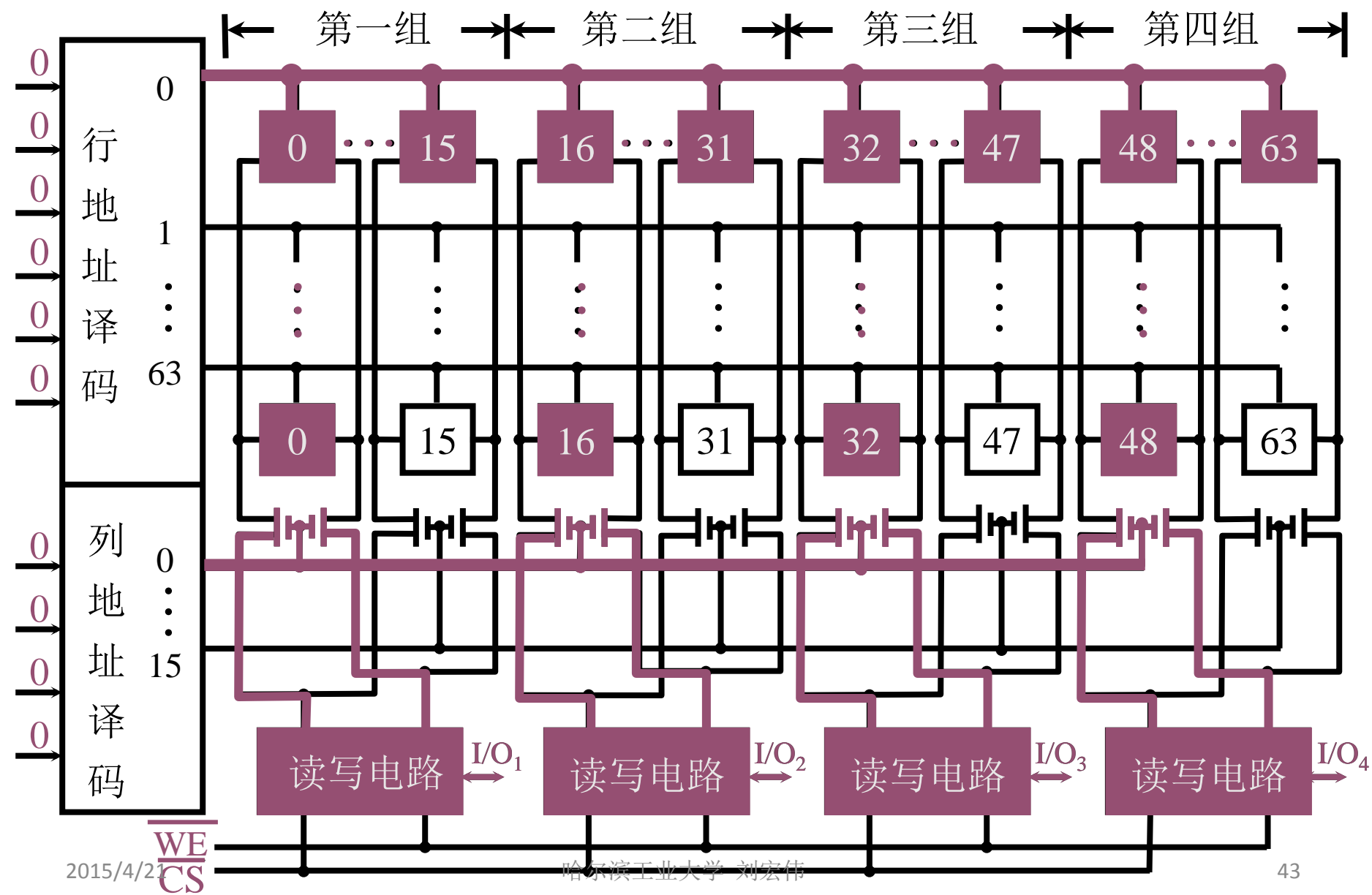
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2



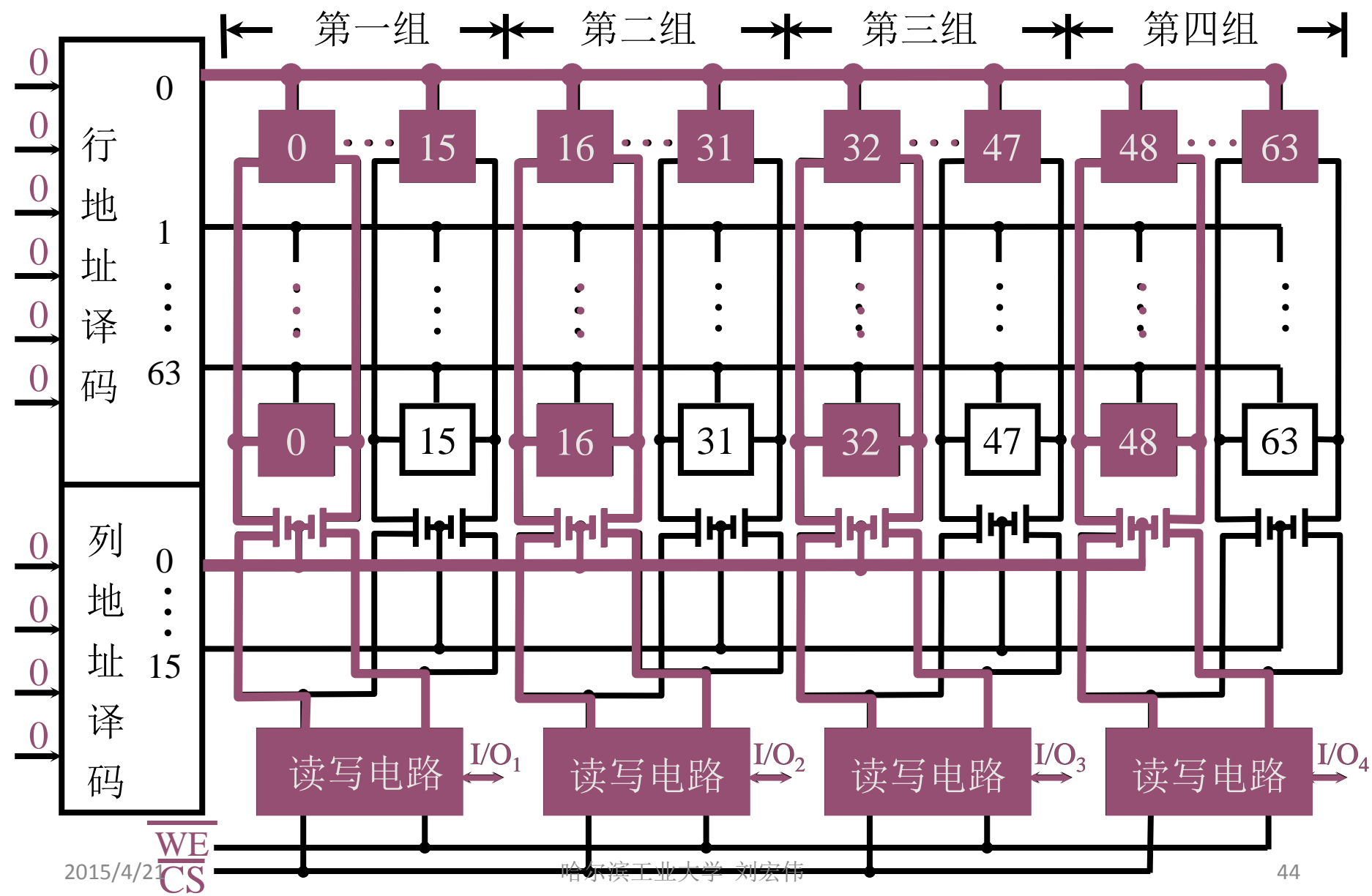
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2



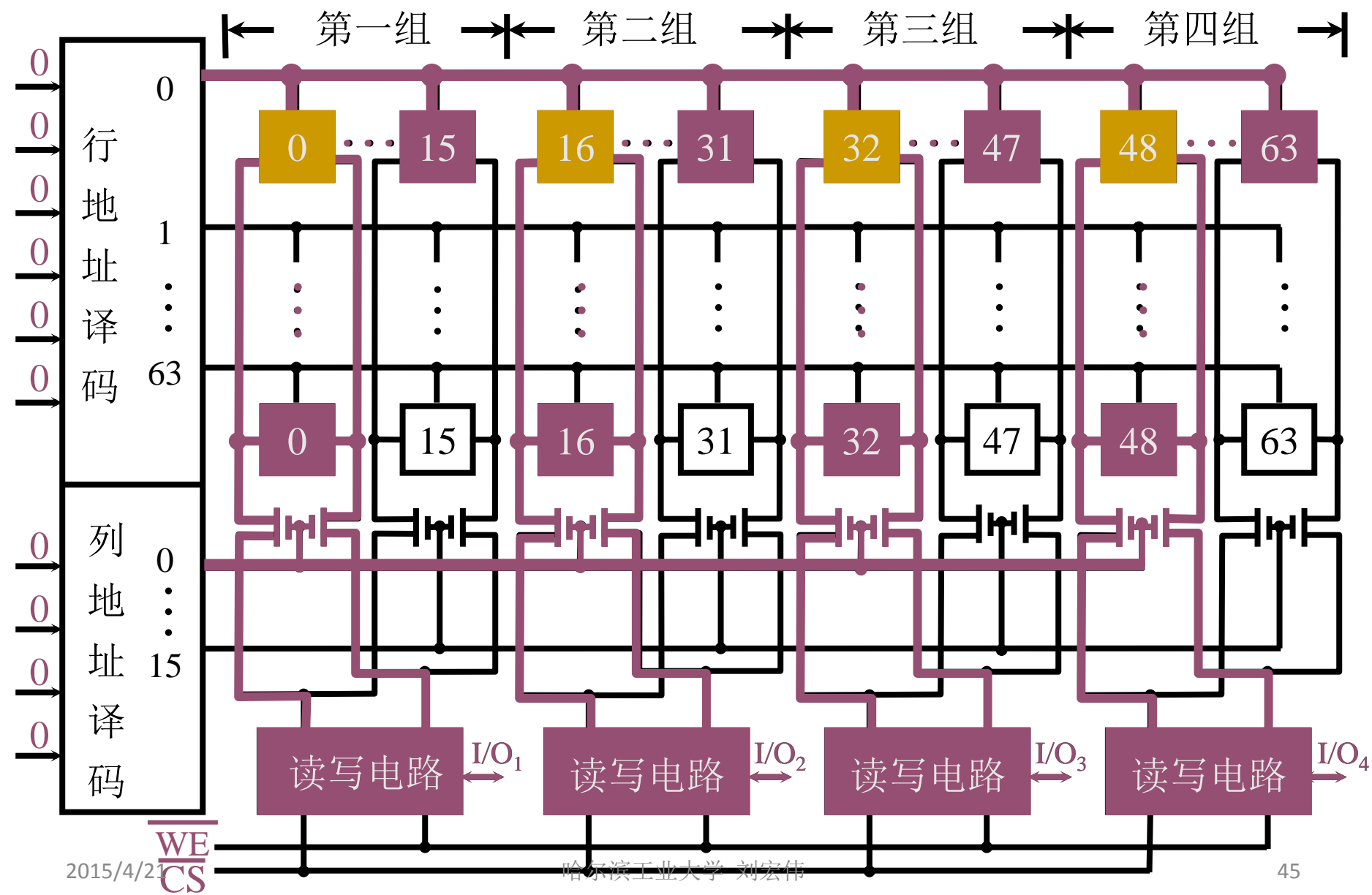
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2



③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写 4.2



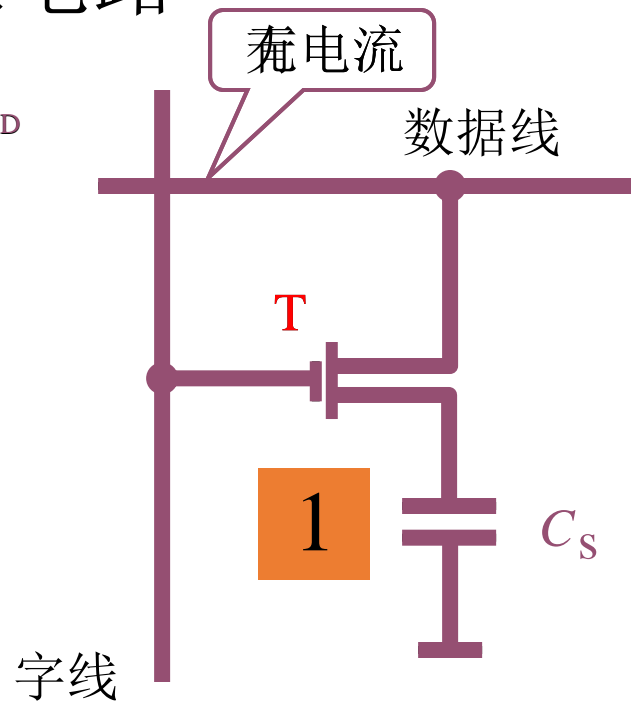
③ Intel 2114 RAM 矩阵 (64×64) 写 4.2



4.2 主存储器——随机存取存储器

- 1. 静态 RAM (SRAM)
- 2. 动态 RAM (DRAM)
 - ✓ 保存0和1的原理是什么？
 - ✓ 基本单元电路的构成是什么？
 - ✓ 对单元电路如何读出和写入？
 - ✓ 典型芯片的结构是很么样子的？
 - ✓ 动态RAM芯片的如何进行读出和写入操作？
 - ✓ 动态RAM为什么要刷新，刷新方法？
- 3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较

4.2

[illegible]

写入与输入信息相同

写入时 C_S 充电为 “1” 放电为 “0”

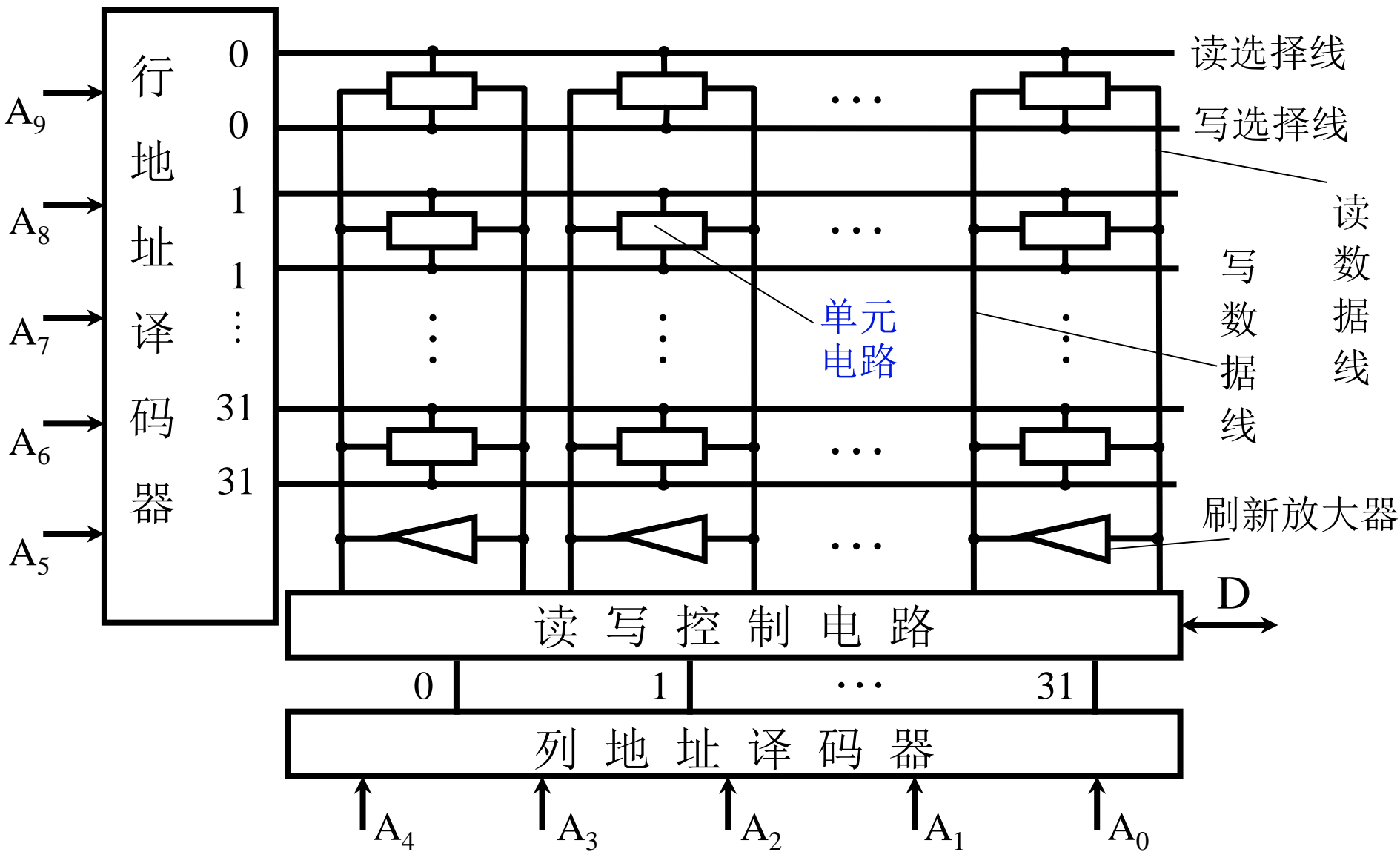
4.2

读



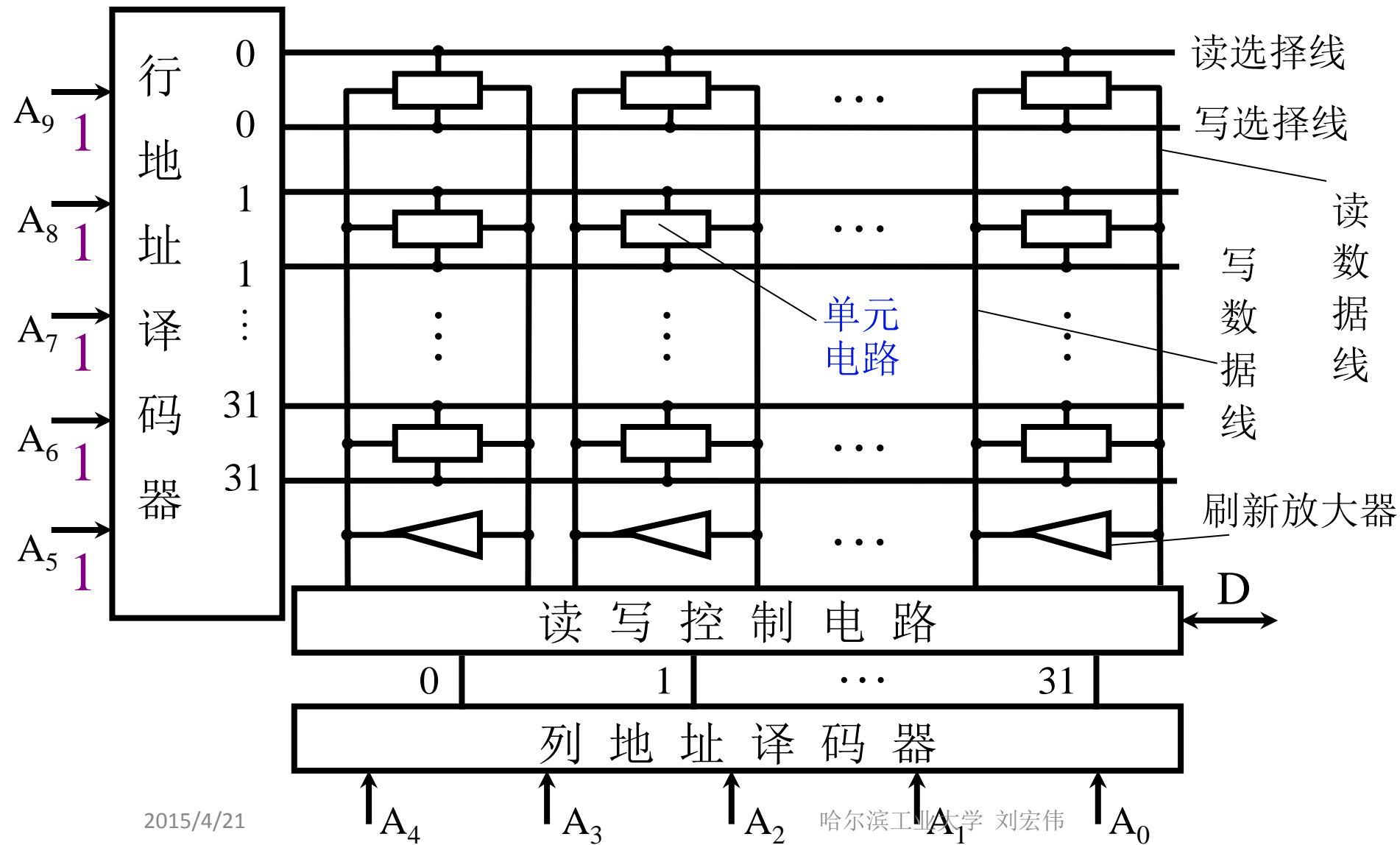
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写

4.2

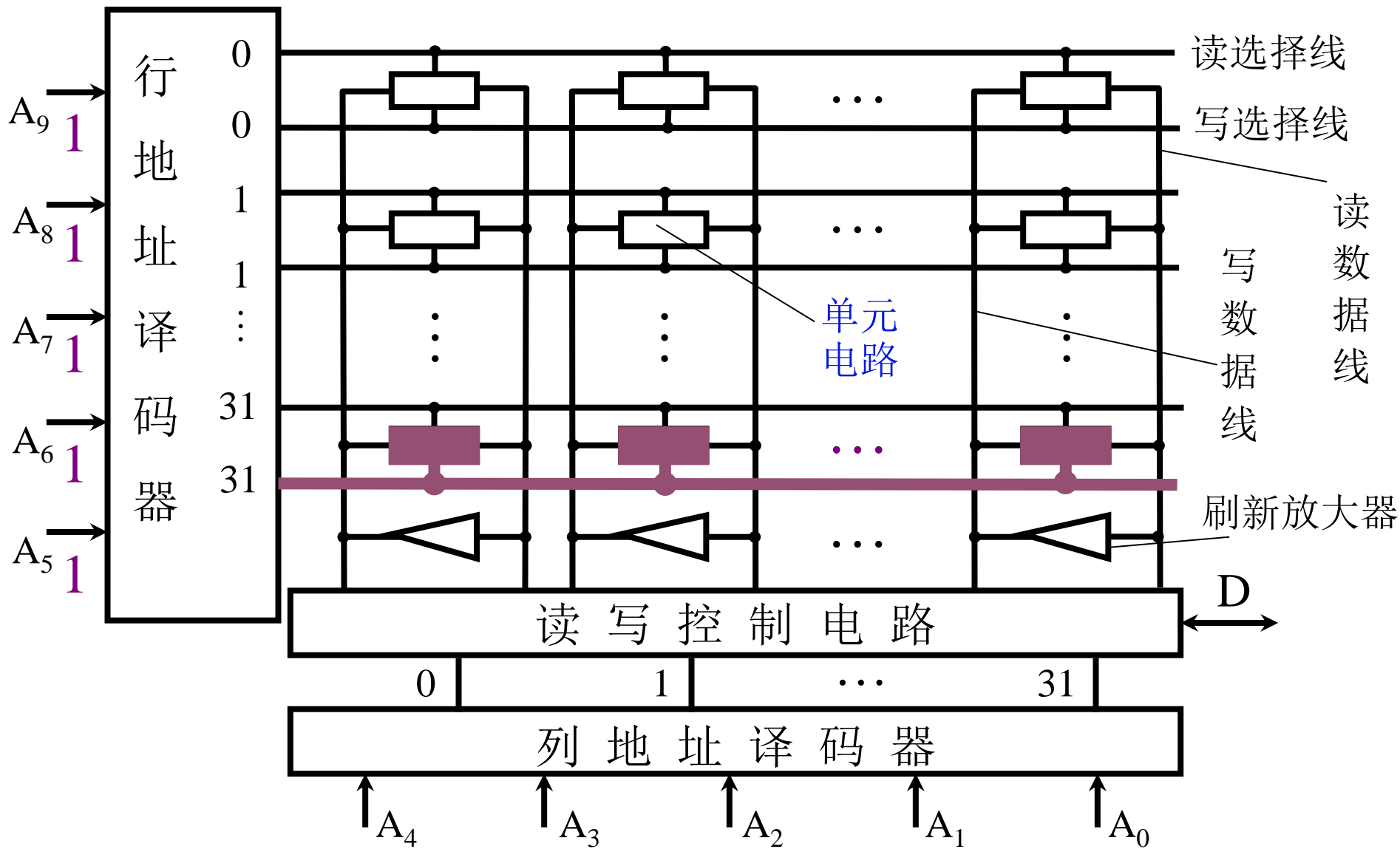


② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写

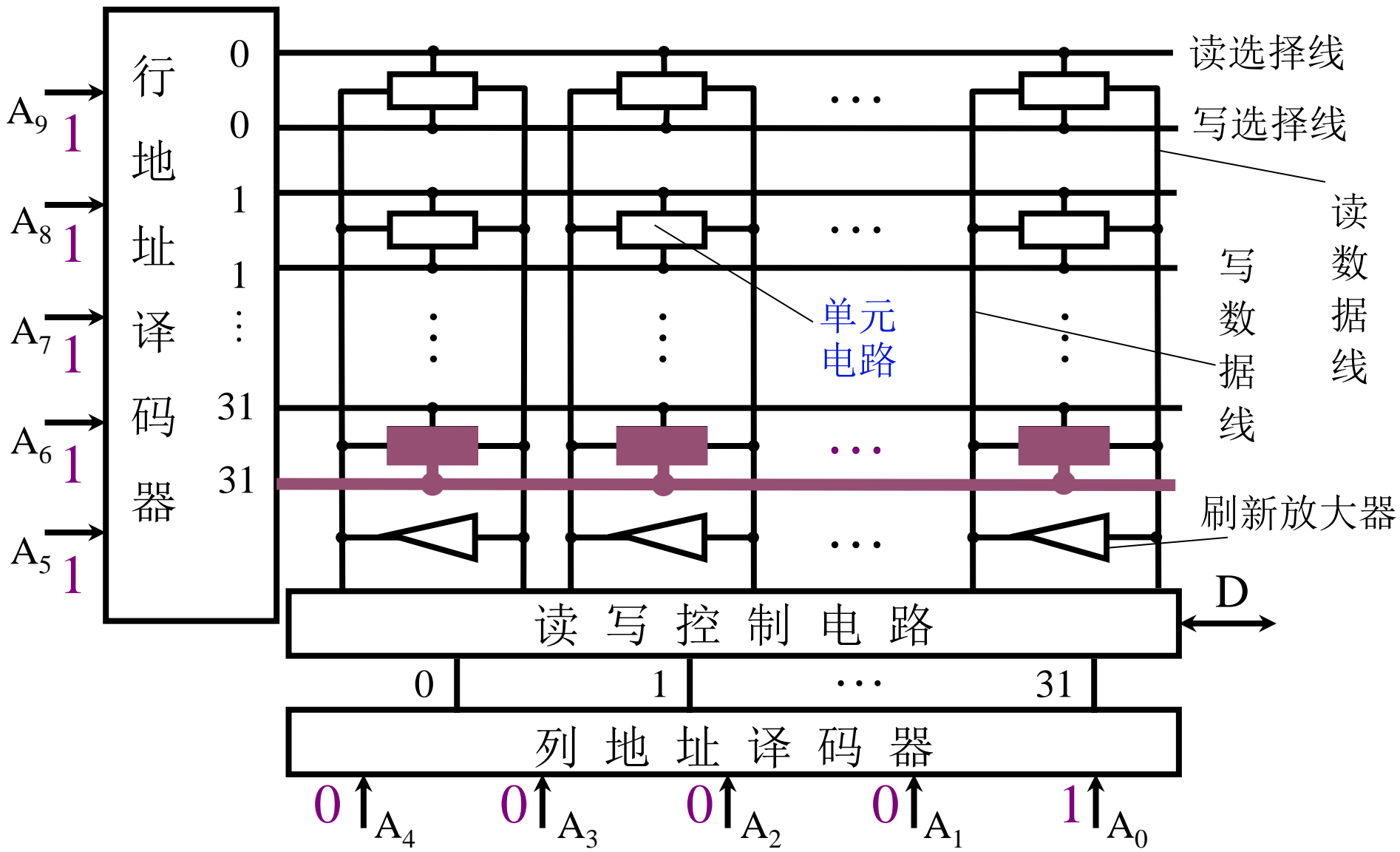
4.2



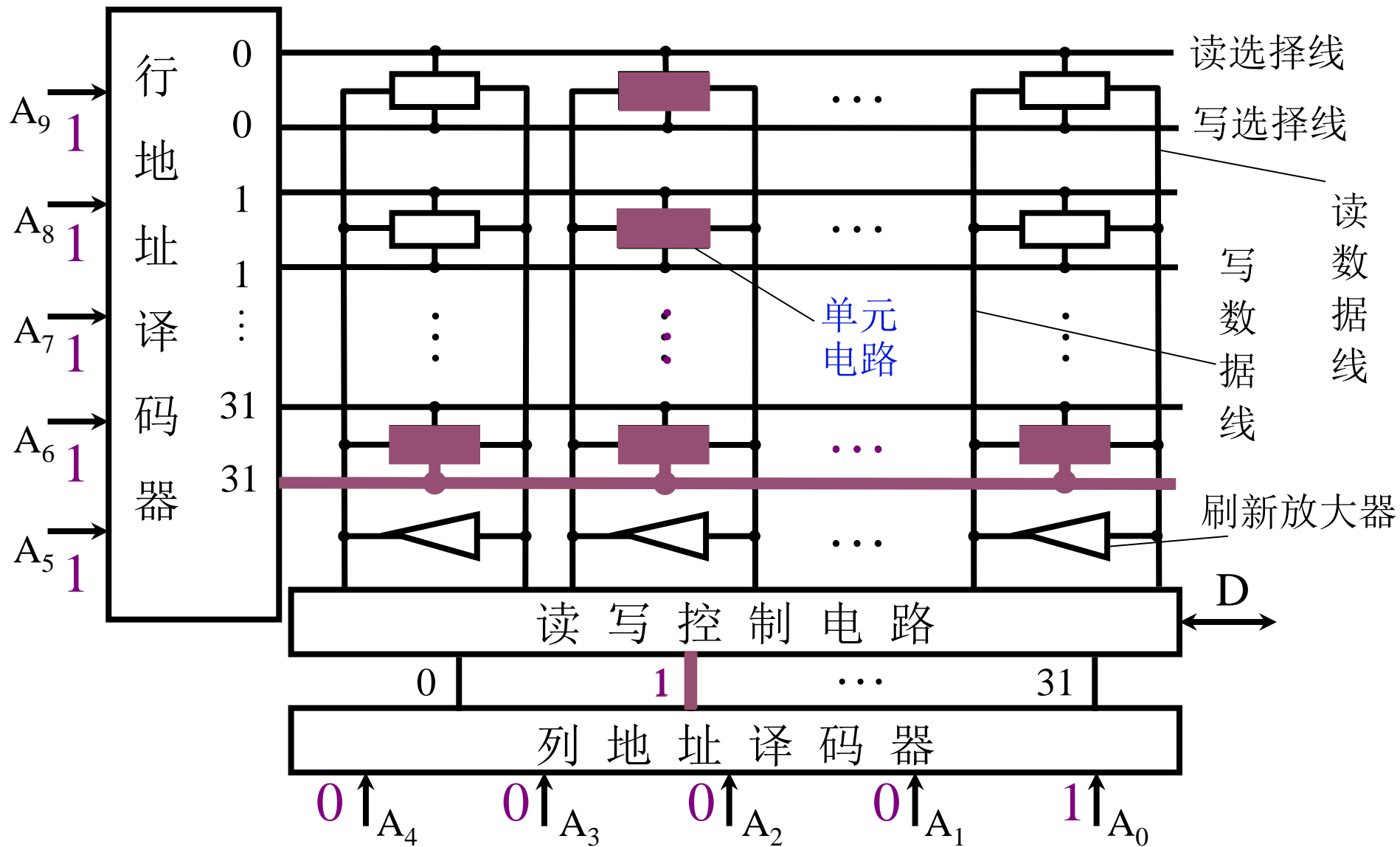
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2



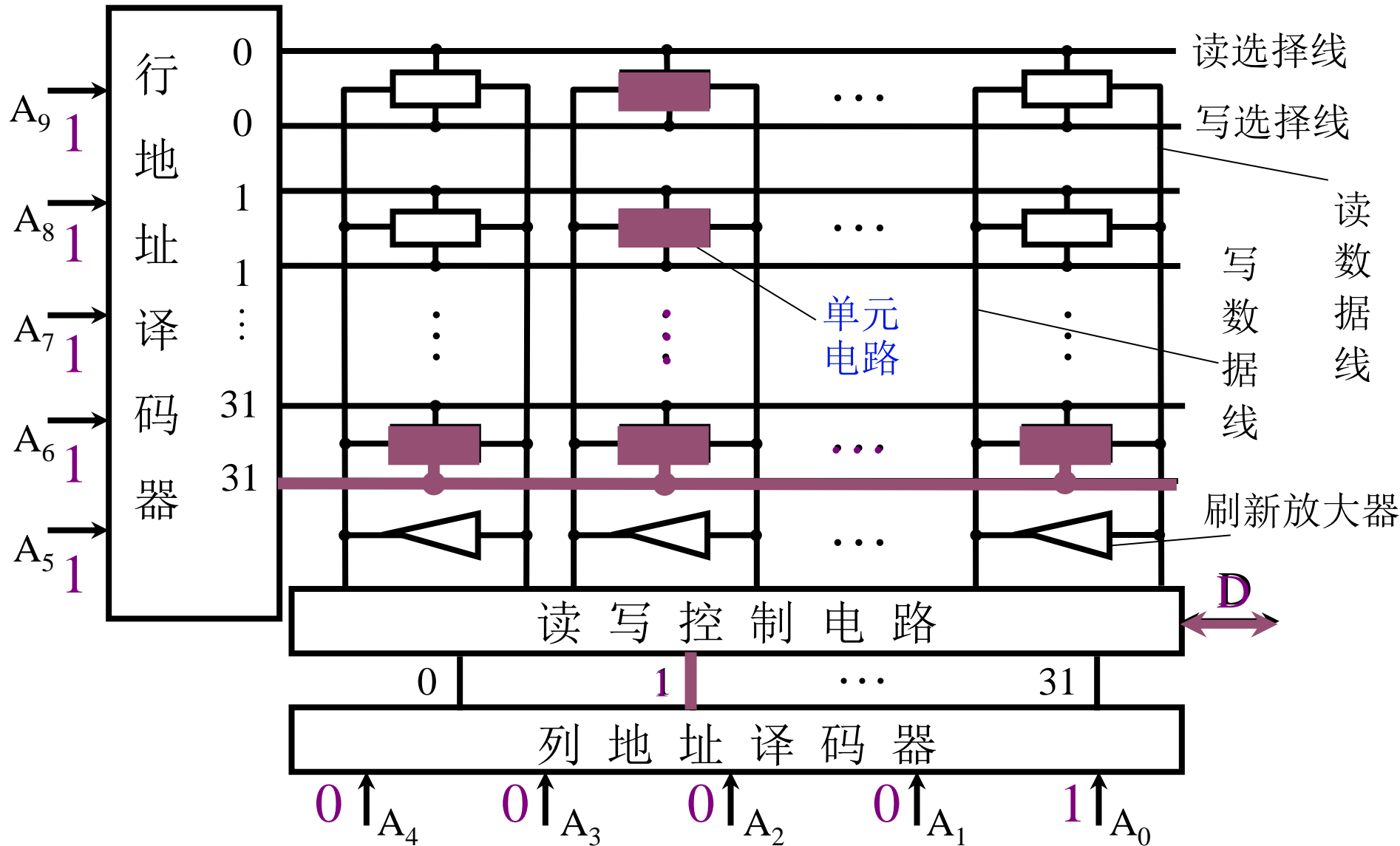
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2



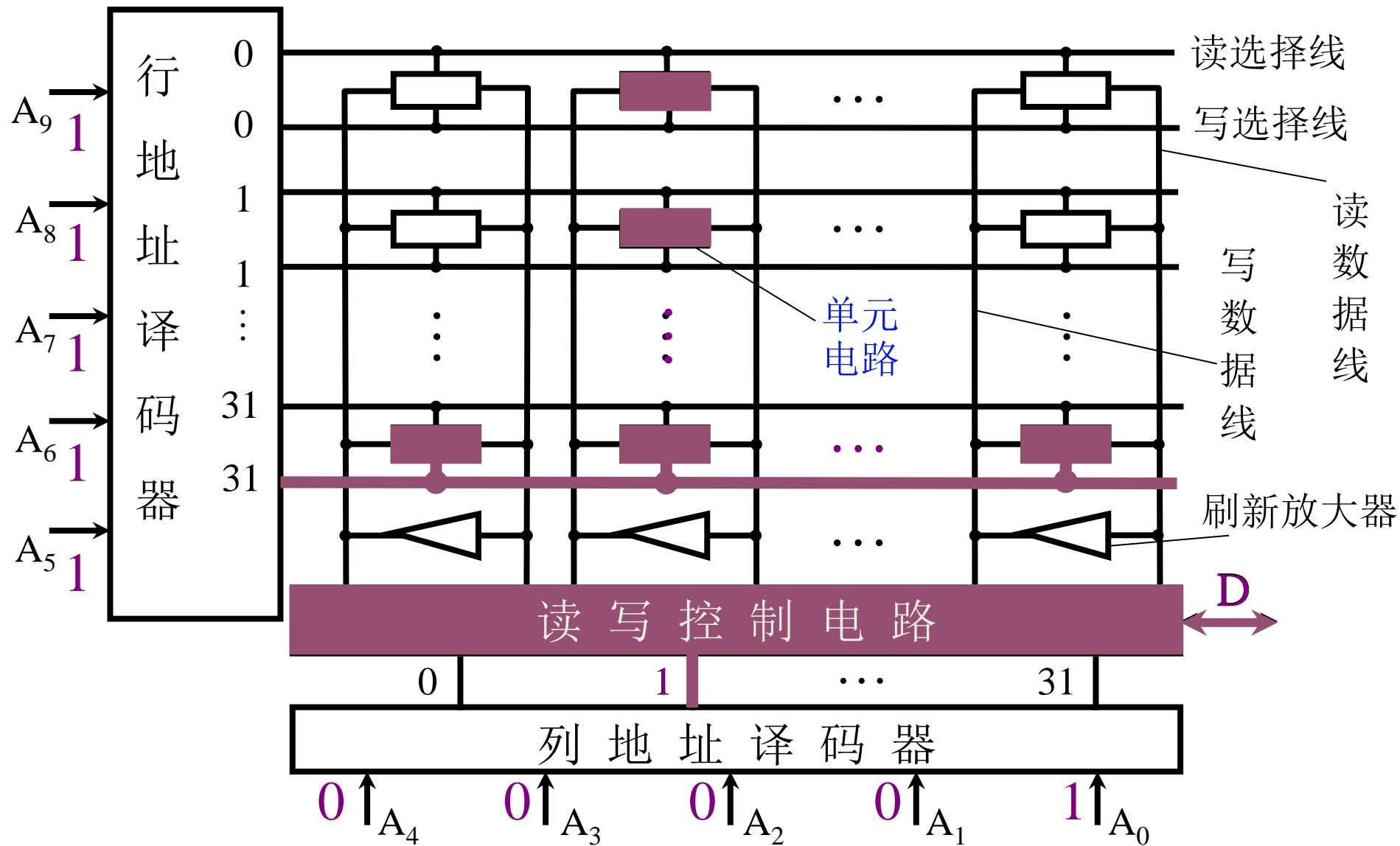
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2



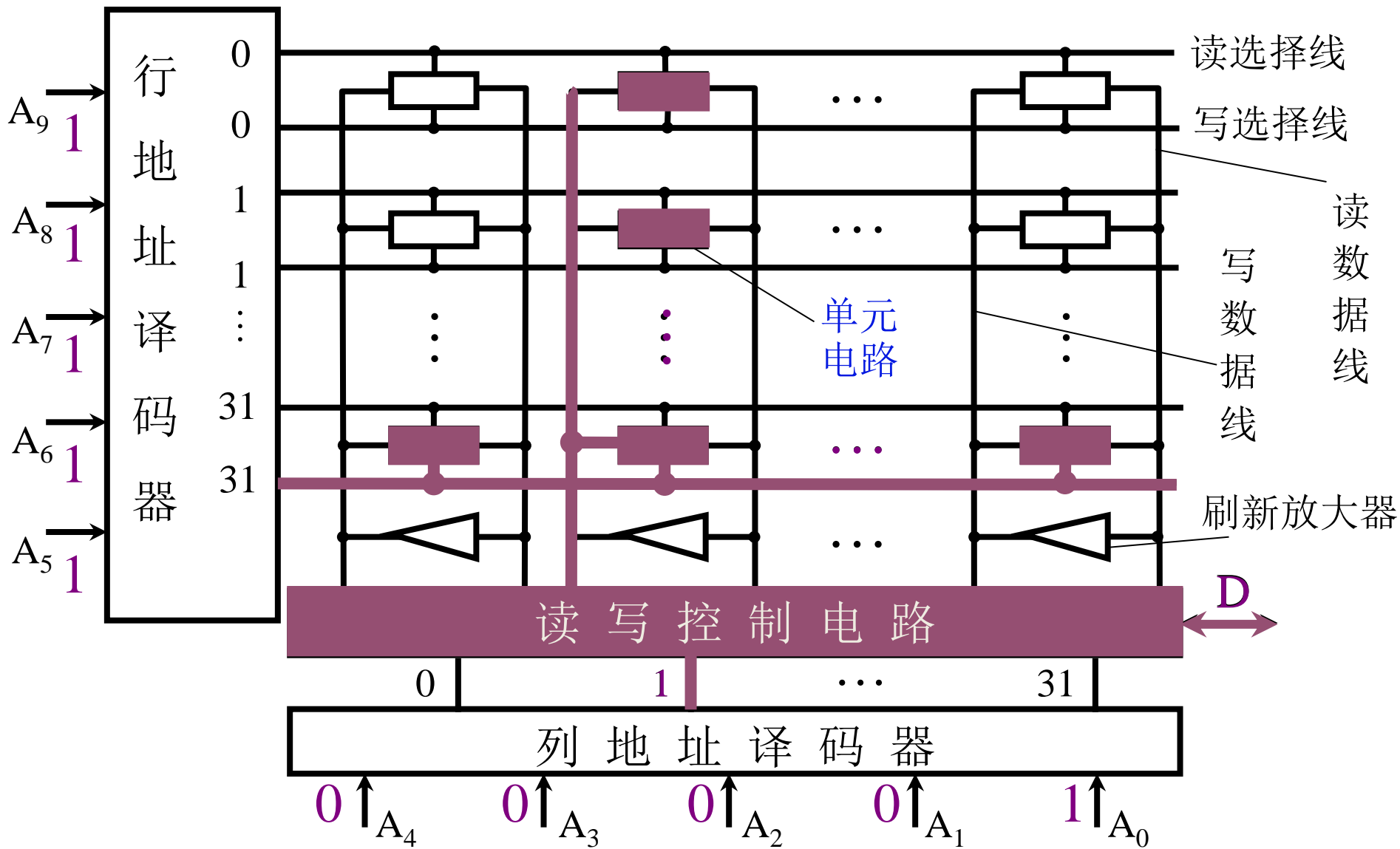
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2



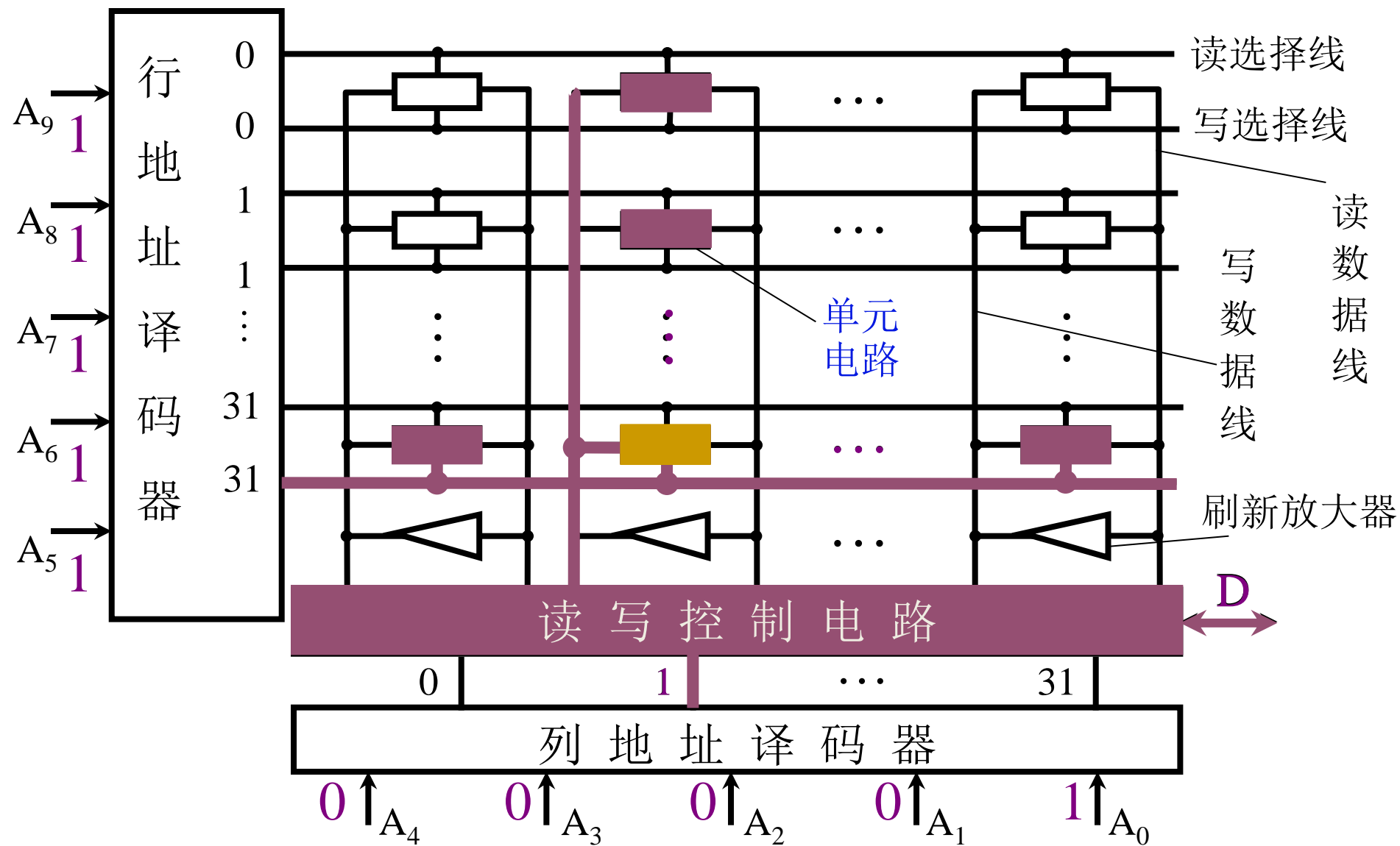
4.2



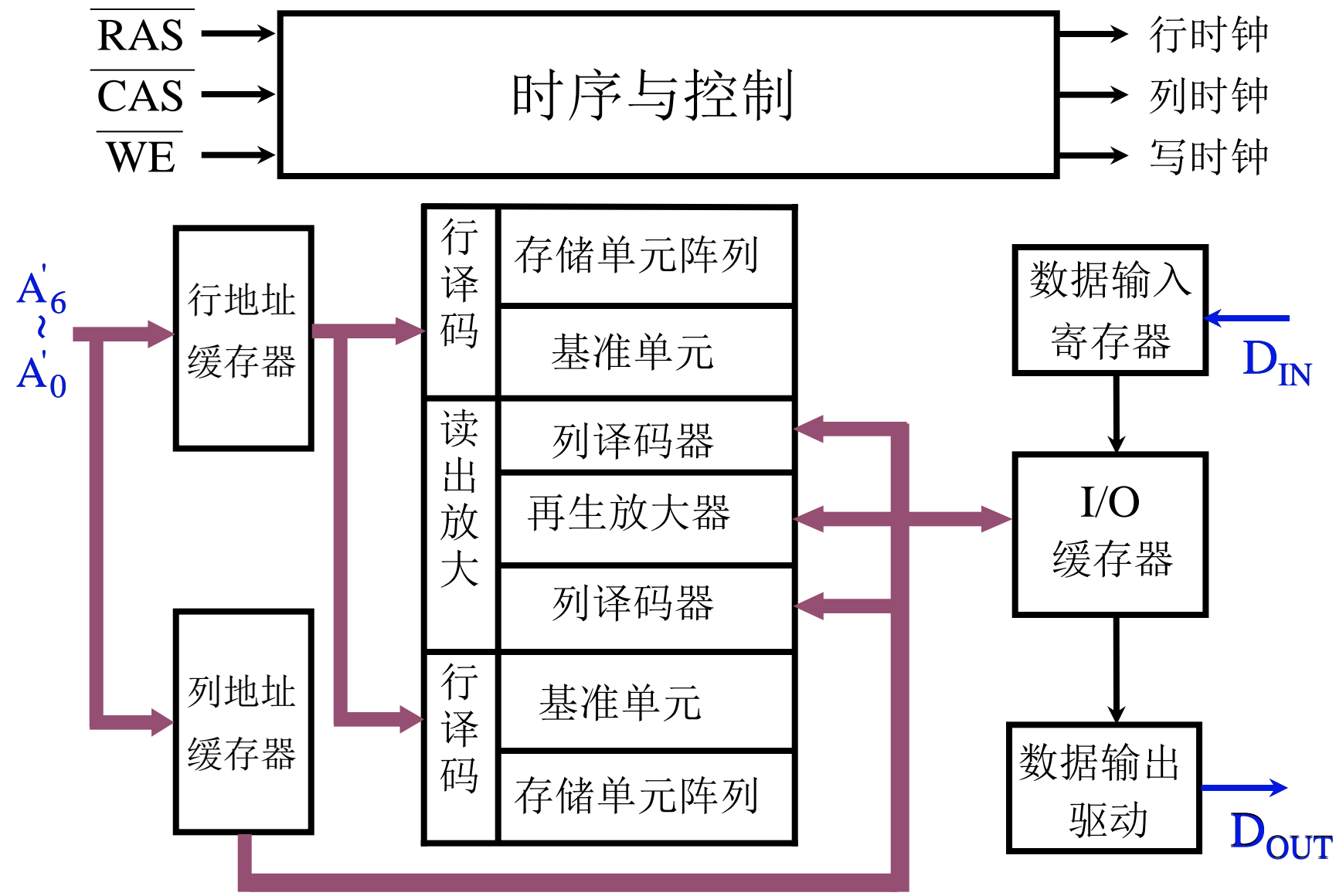
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2



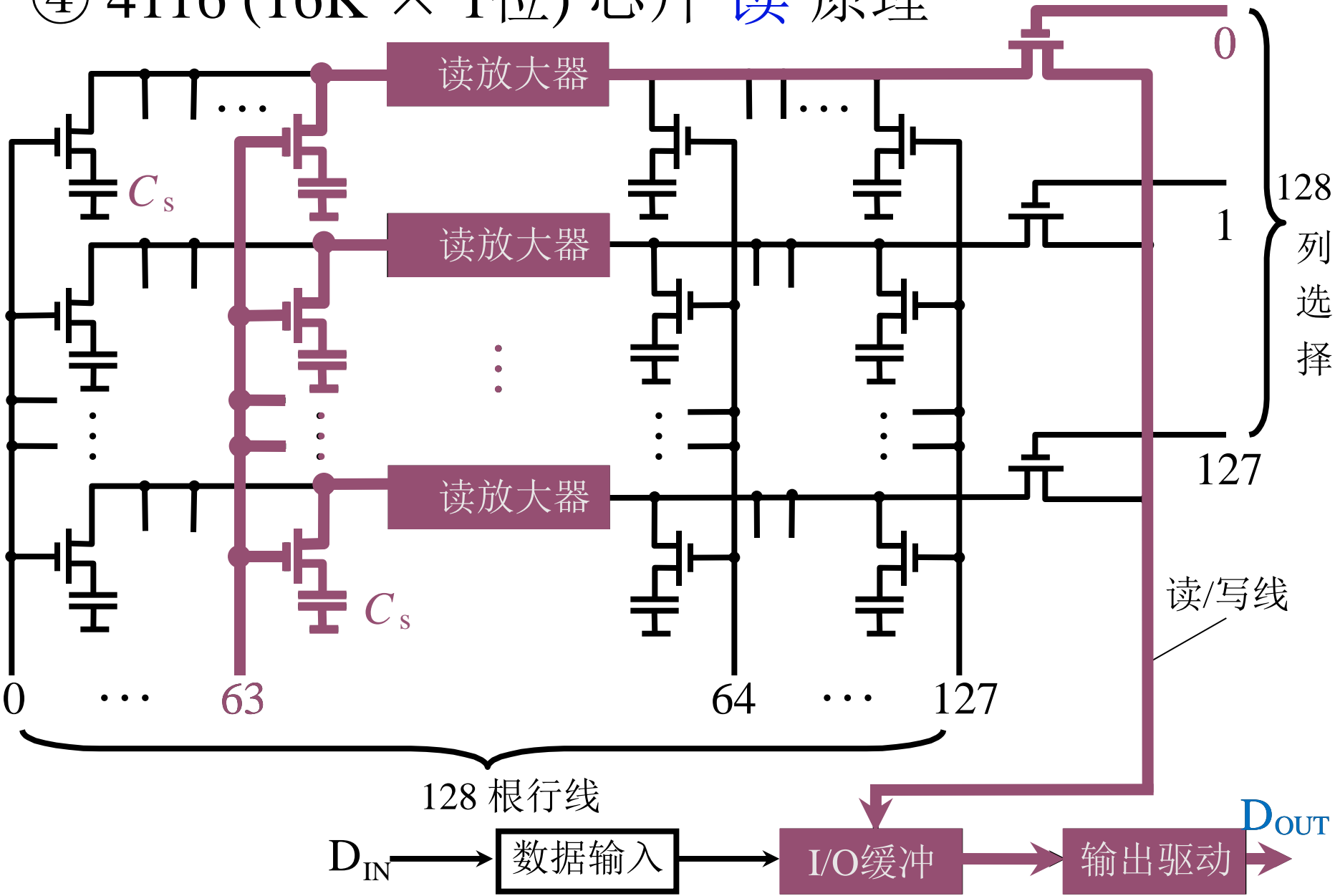
② 三管动态 RAM 芯片 (Intel 1103) 写 4.2



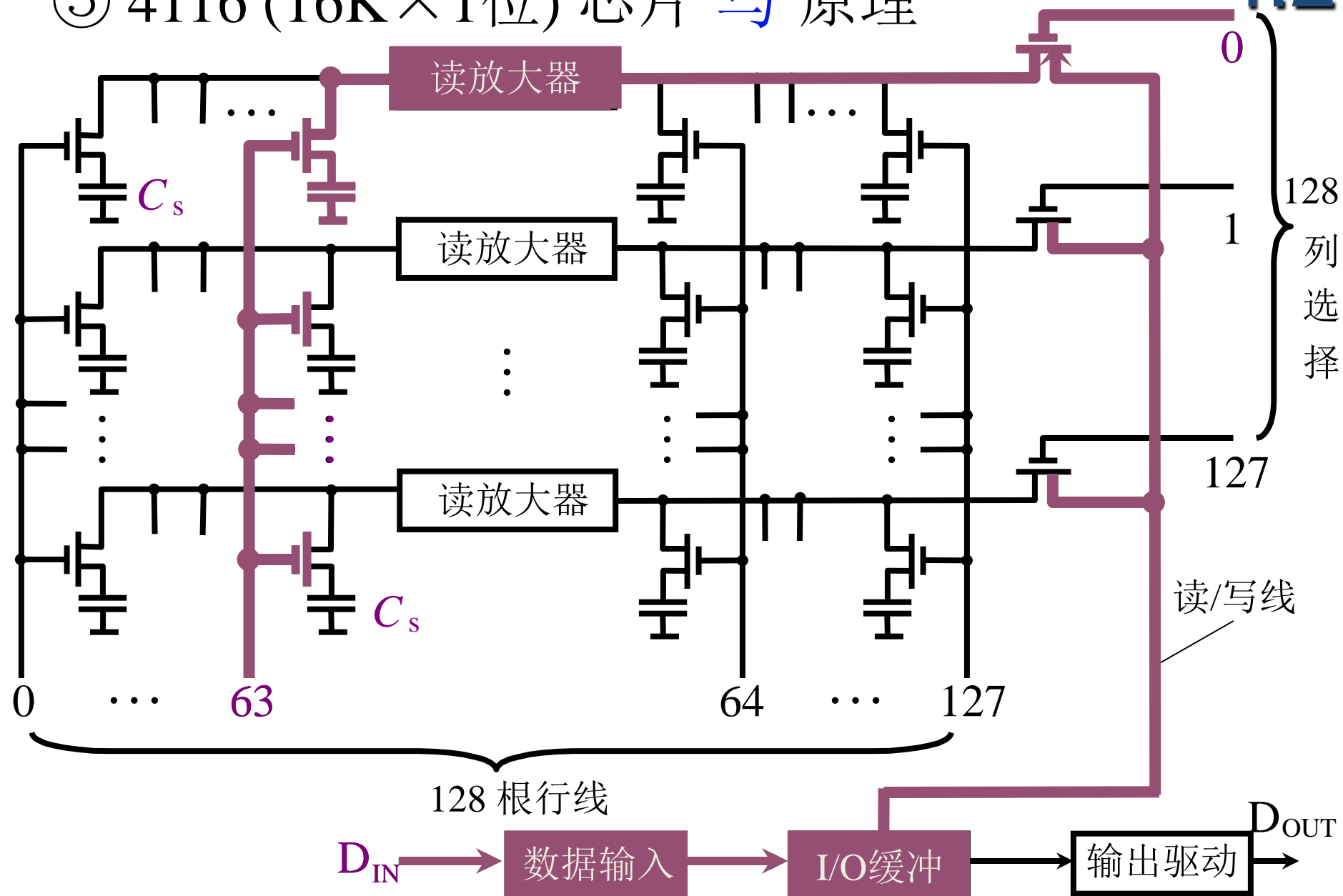
③ 单管动态 RAM 4116 (16K × 1位) 外特性 4.2



④ 4116 (16K × 1位) 芯片 读 原理



4.2

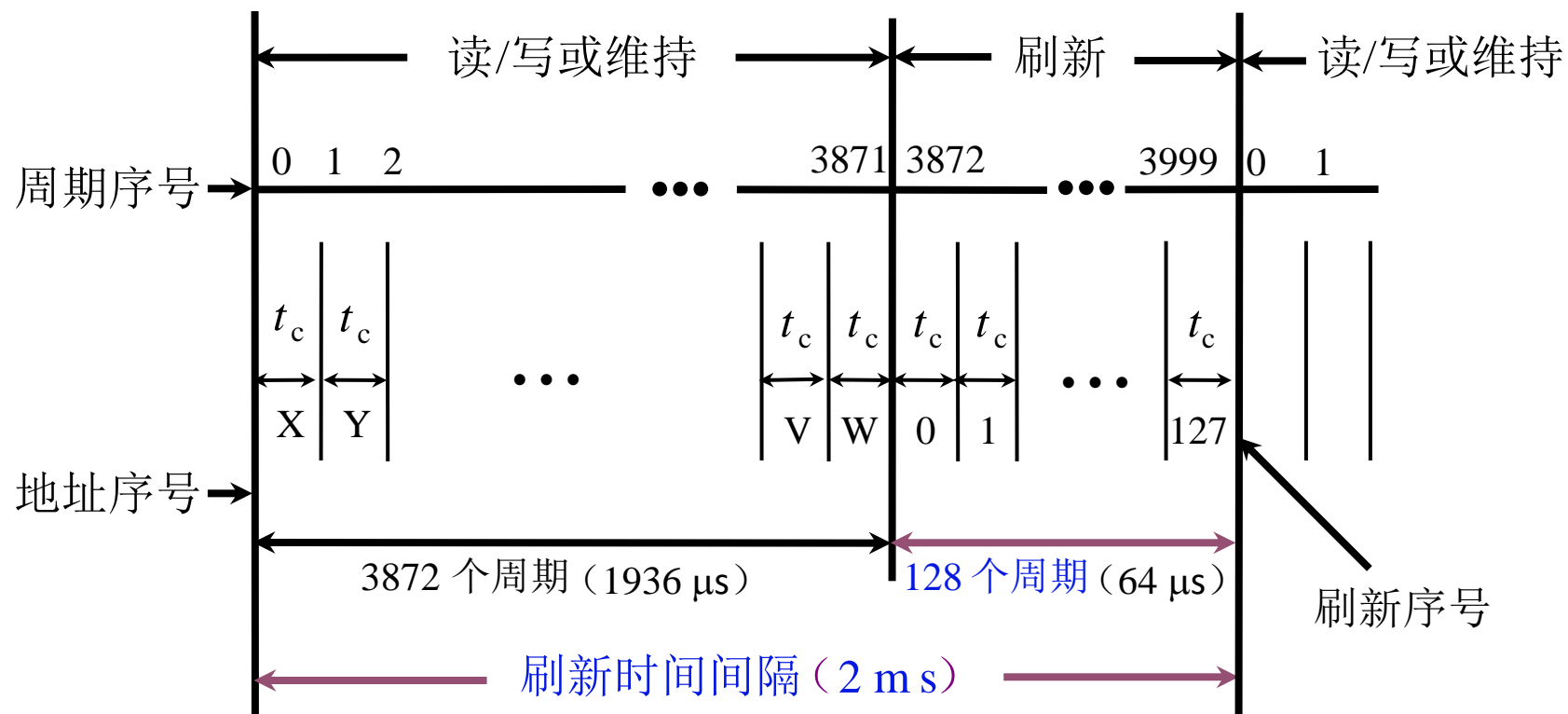


(4) 动态 RAM 刷新

4.2

刷新与行地址有关

① 集中刷新 （存取周期为 $0.5\ \mu\text{s}$ ）以 128×128 矩阵为例



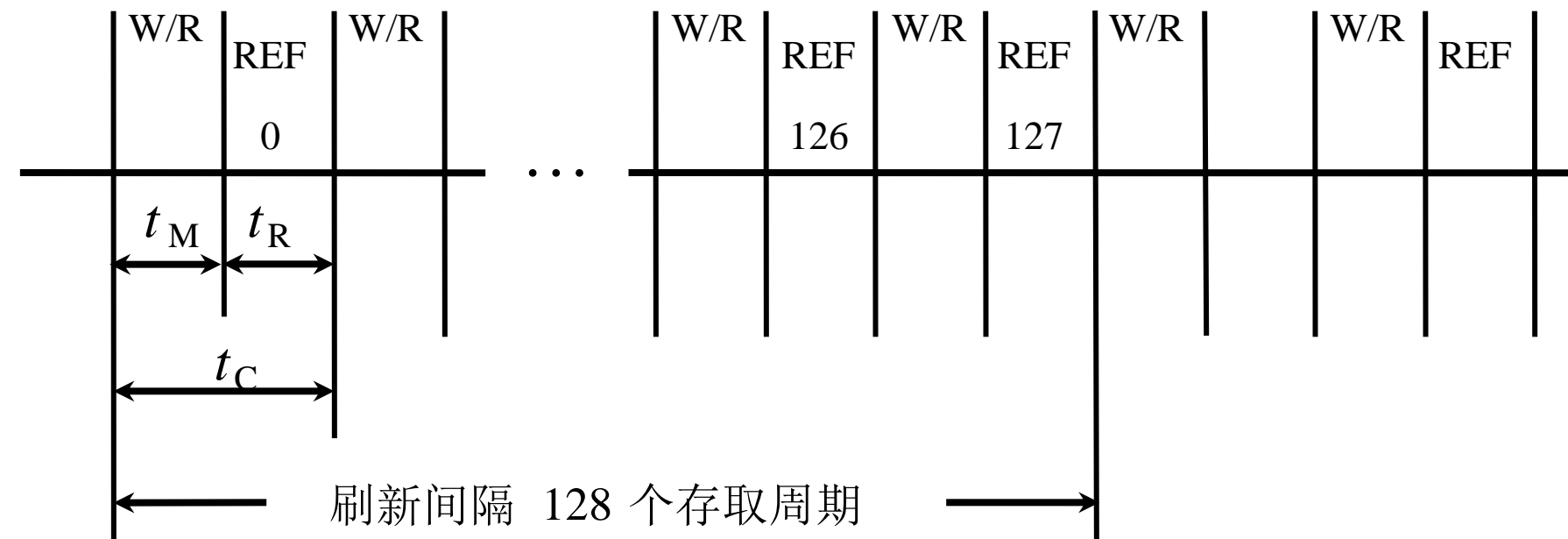
“死区” 为 $0.5\ \mu\text{s} \times 128 = 64\ \mu\text{s}$

“死时间率” 为 $128/4\ 000 \times 100\% = 3.2\%$

② 分散刷新（存取周期为 $1\mu\text{s}$ ）

4.2

以 128×128 矩阵为例



$$t_C = t_M + t_R$$

无“死区”

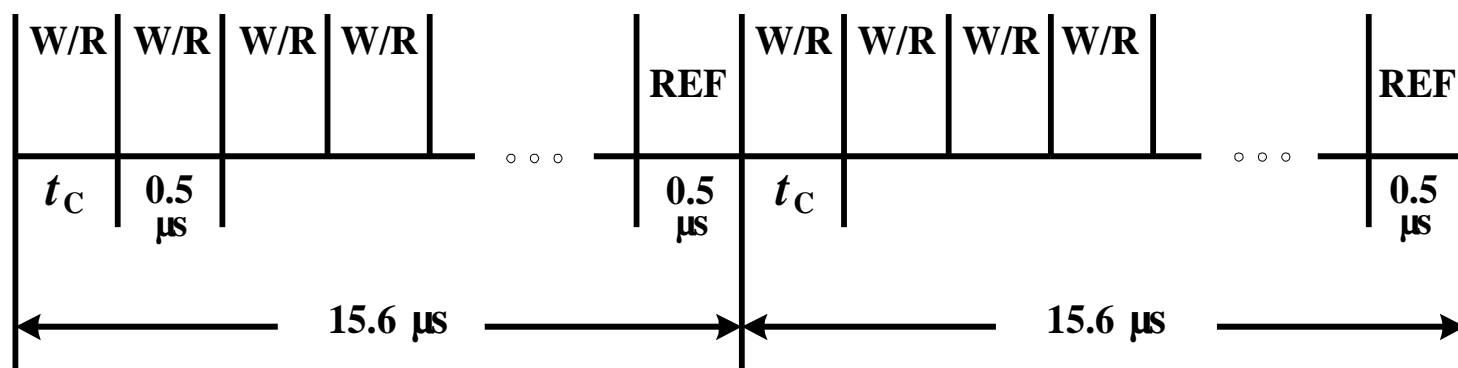
读写 刷新

(存取周期为 $0.5\mu\text{s} + 0.5\mu\text{s}$)

③ 分散刷新与集中刷新相结合（异步刷新）^{4.2}

对于 128×128 的存储芯片（存取周期为 $0.5 \mu\text{s}$ ）

若每隔 $15.6 \mu\text{s}$ 刷新一次行



每行每隔 2 ms 刷新一次

“死区”为 $0.5 \mu\text{s}$

将刷新安排在指令译码阶段，不会出现“死区”

3. 动态 RAM 和静态 RAM 的比较

	<div>主存</div> DRAM	SRAM <div>缓存</div>
存储原理	电容	触发器
集成度	高	低
芯片引脚	少	多
功耗	小	大
价格	低	高
速度	慢	快
刷新	有	无

4.2 主存储器

- 一、概述
- 二、半导体存储芯片简介
- 三、随机存取存储器 (RAM)
- 四、只读存储器 (ROM)
- 五、存储器与 CPU 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

四、只读存储器（ROM）

- 早期的只读存储器——在厂家就写好了内容
- 改进1——用户可以自己写——一次性
- 改进2——可以多次写——要能对信息进行擦除
- 改进3——电可擦写——特定设备
- 改进4——电可擦写——直接连接到计算机上

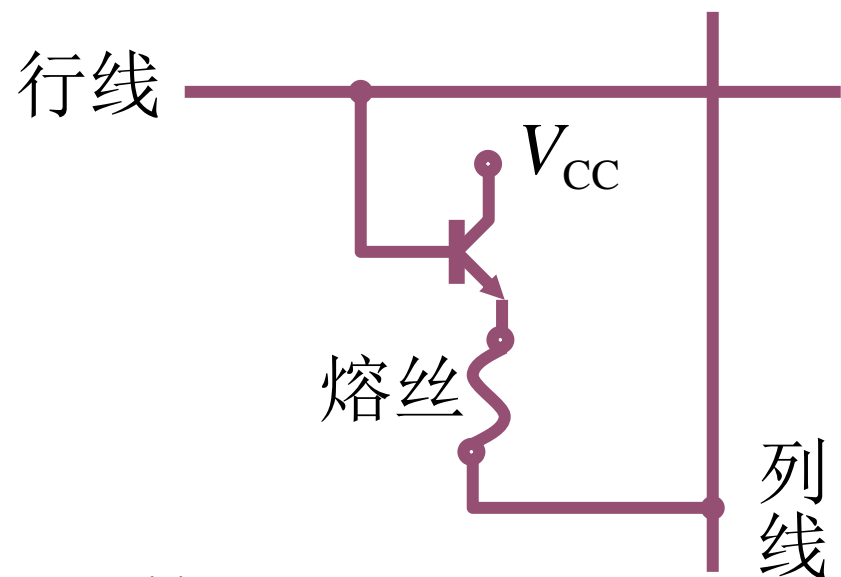
四、只读存储器（ROM）

1. 掩模 ROM (MROM)

行列选择线交叉处有 MOS 管为 “1”

行列选择线交叉处无 MOS 管为 “0”

2. PROM (一次性编程)



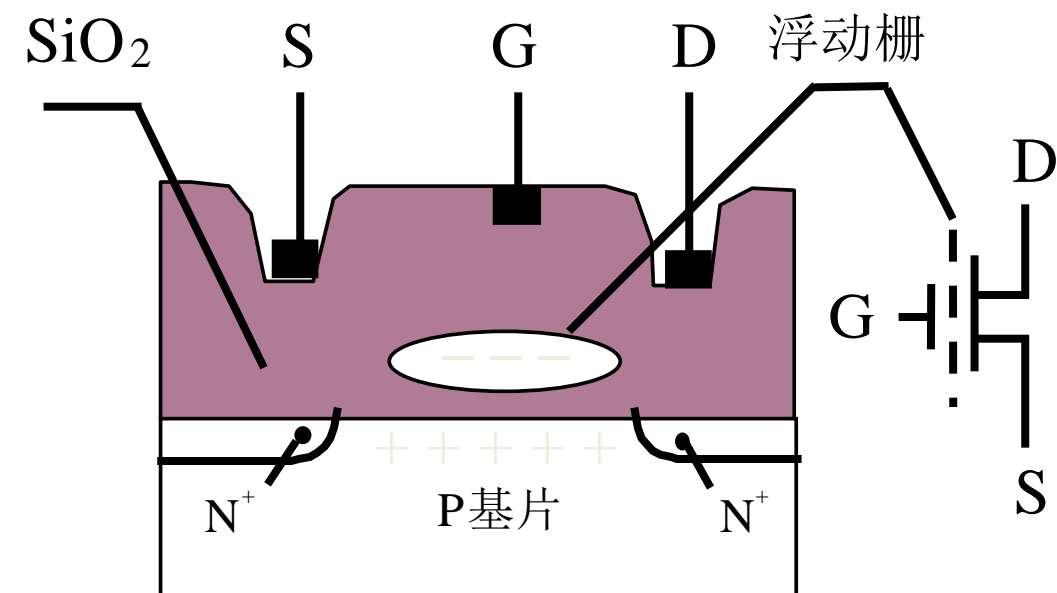
熔丝断 为 “0”

熔丝未断 为 “1”

3. EPROM (多次性编程)

4.2

N型沟道浮动栅 MOS 电路



G 栅极

S 源

D 漏



紫外线全部擦洗

D 端加正电压

形成浮动栅

S 与 D 不导通为 “0”

D 端不加正电压

不形成浮动栅

S 与 D 导通为 “1”

4. EEPROM (多次性编程)

电可擦写

局部擦写

全部擦写

5. Flash Memory (闪速型存储器)

EPROM 价格便宜 集成度高

EEPROM 电可擦洗重写

比 EEPROM快 具备 RAM 功能

4.2 主存储器

- 一、概述
- 二、半导体存储芯片简介
- 三、随机存取存储器 (RAM)
- 四、只读存储器 (ROM)
- 五、存储器与 CPU 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

4.2 主存储器——存储器与 CPU 的连接

- 1. 存储器容量的扩展

- ✓ 位扩展

- ✓ 字扩展

- ✓ 同时扩展

- 2. 存储器与 CPU 的连接

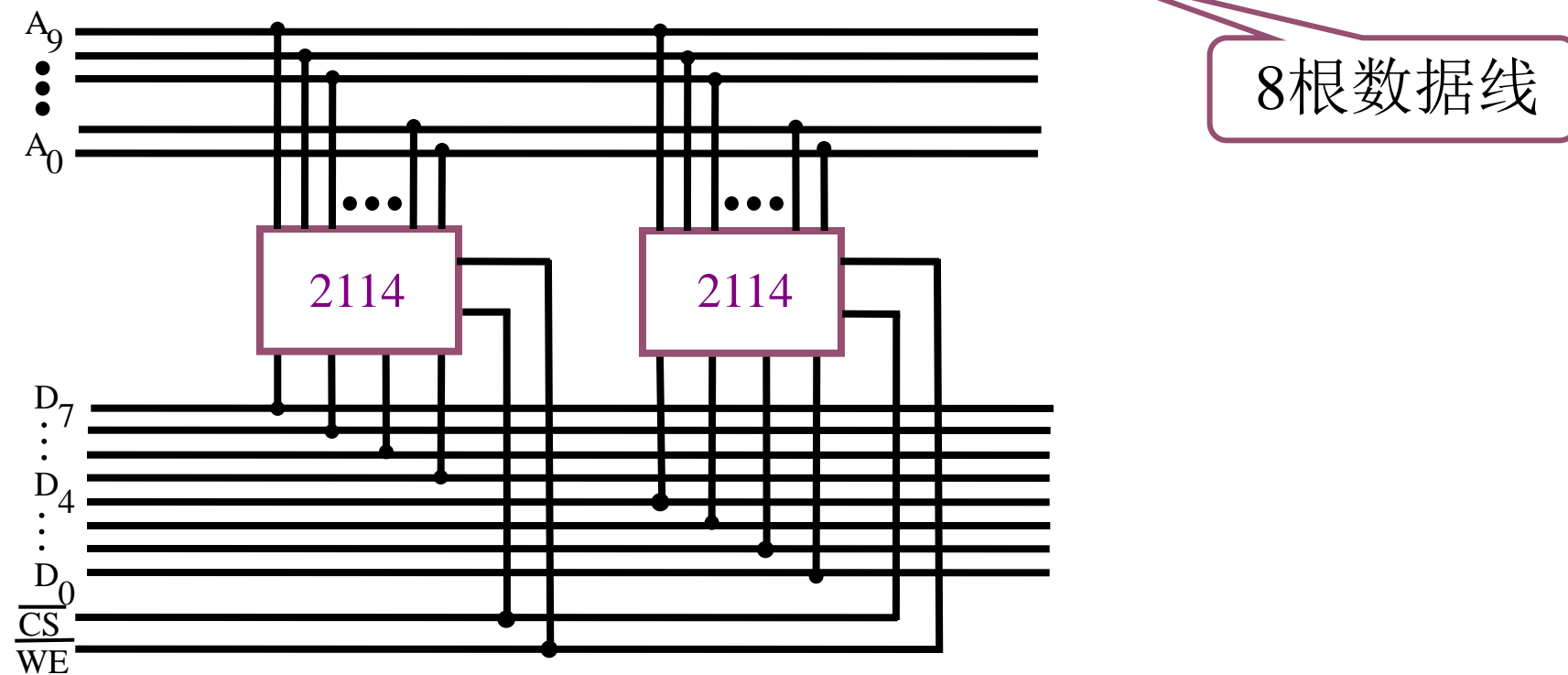
五、存储器与 CPU 的连接

4.2

1. 存储器容量的扩展

(1) 位扩展（增加存储字长）

用 2 片 $1\text{K} \times 4$ 位 存储芯片组成 $1\text{K} \times 8$ 位的存储器



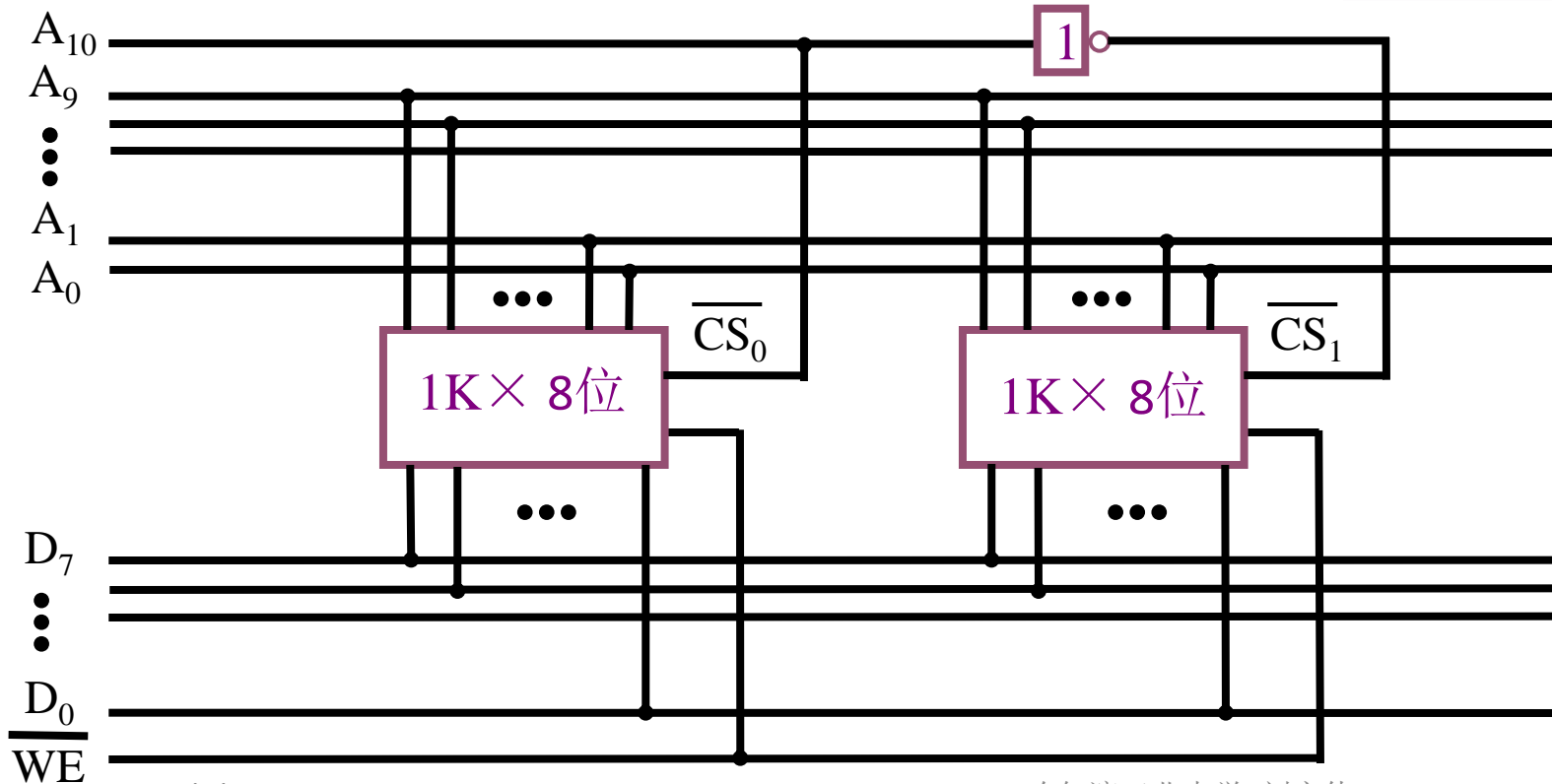
4.2

(2) 字扩展（增加存储字的数量）

用 **2片** $1\text{K} \times 8\text{位}$ 存储芯片组成 $2\text{K} \times 8\text{位}$ 的存储器

11根地址线

8根数据线



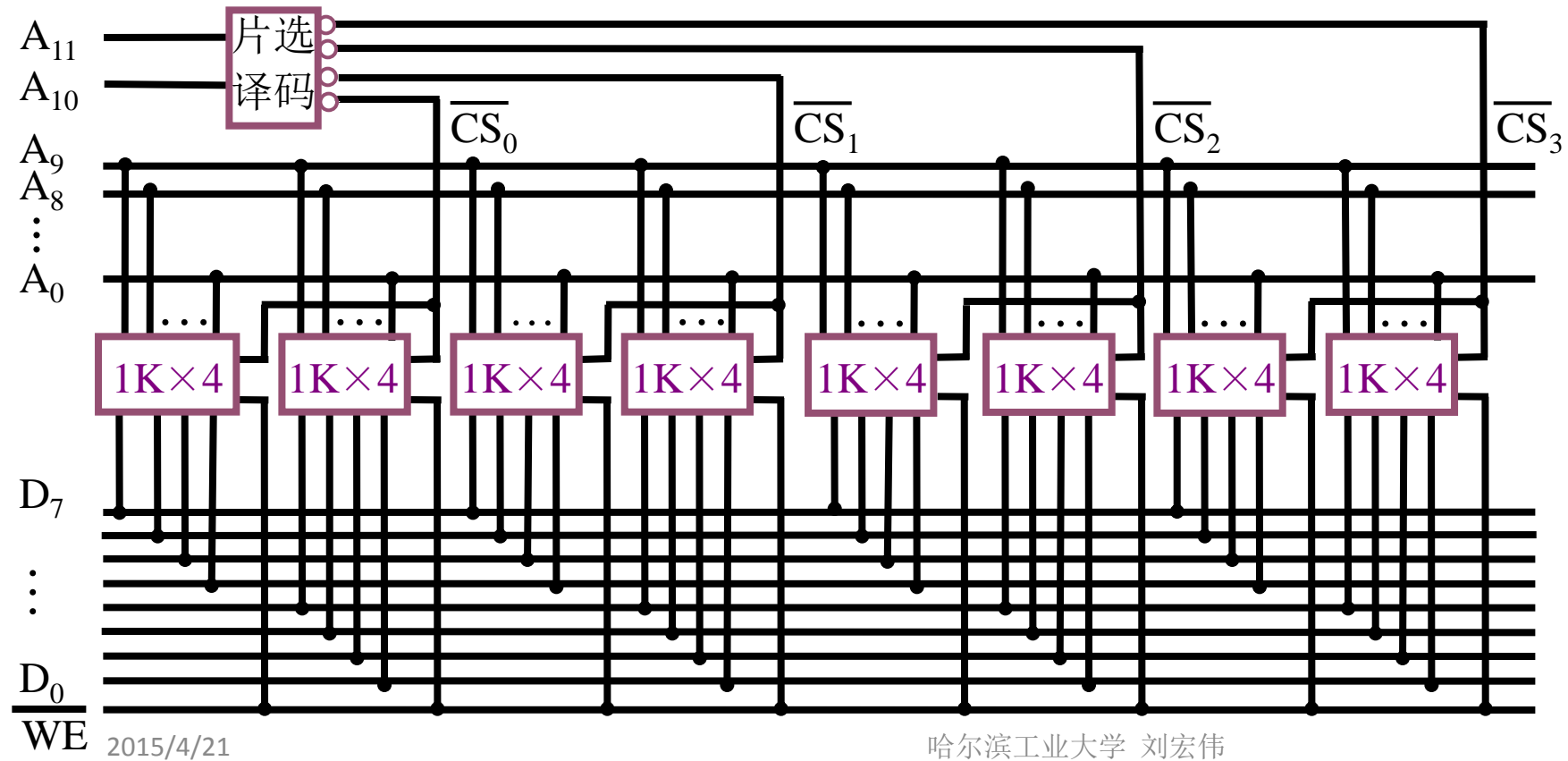
(3) 字、位扩展

4.2

用 8 片 $1\text{K} \times 4$ 位 存储芯片组成 $4\text{K} \times 8$ 位的存储器

12根地址线

8根数据线



4.2 主存储器——存储器与 CPU 的连接

- 1. 存储器容量的扩展
 - ✓位扩展
 - ✓字扩展
 - ✓同时扩展
- 2. 存储器与 CPU 的连接
 - ✓基本方法
 - ✓举例

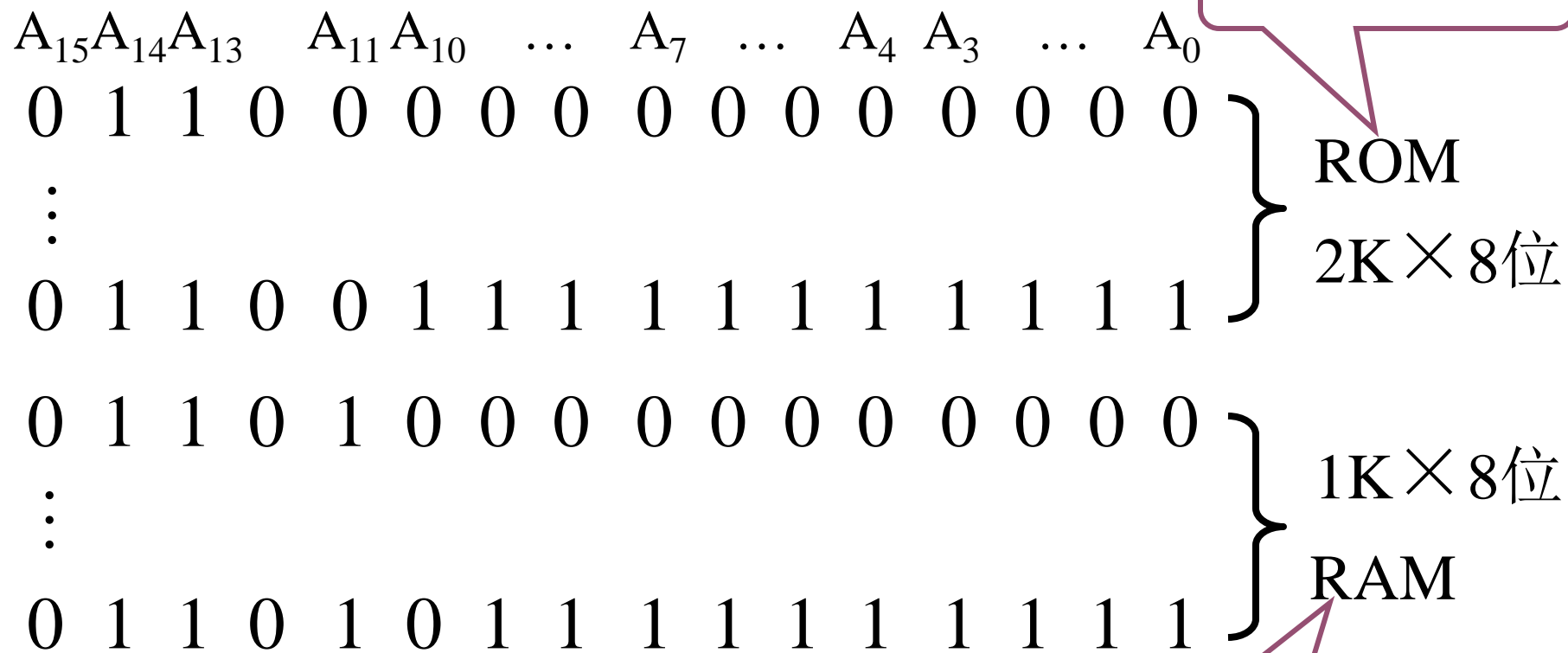
2. 存储器与 CPU 的连接

- (1) 地址线的连接
- (2) 数据线的连接
- (3) 读/写命令线的连接
- (4) 片选线的连接
- (5) 合理选择存储芯片
- (6) 其他 时序、负载

例4.1 解:

4.2

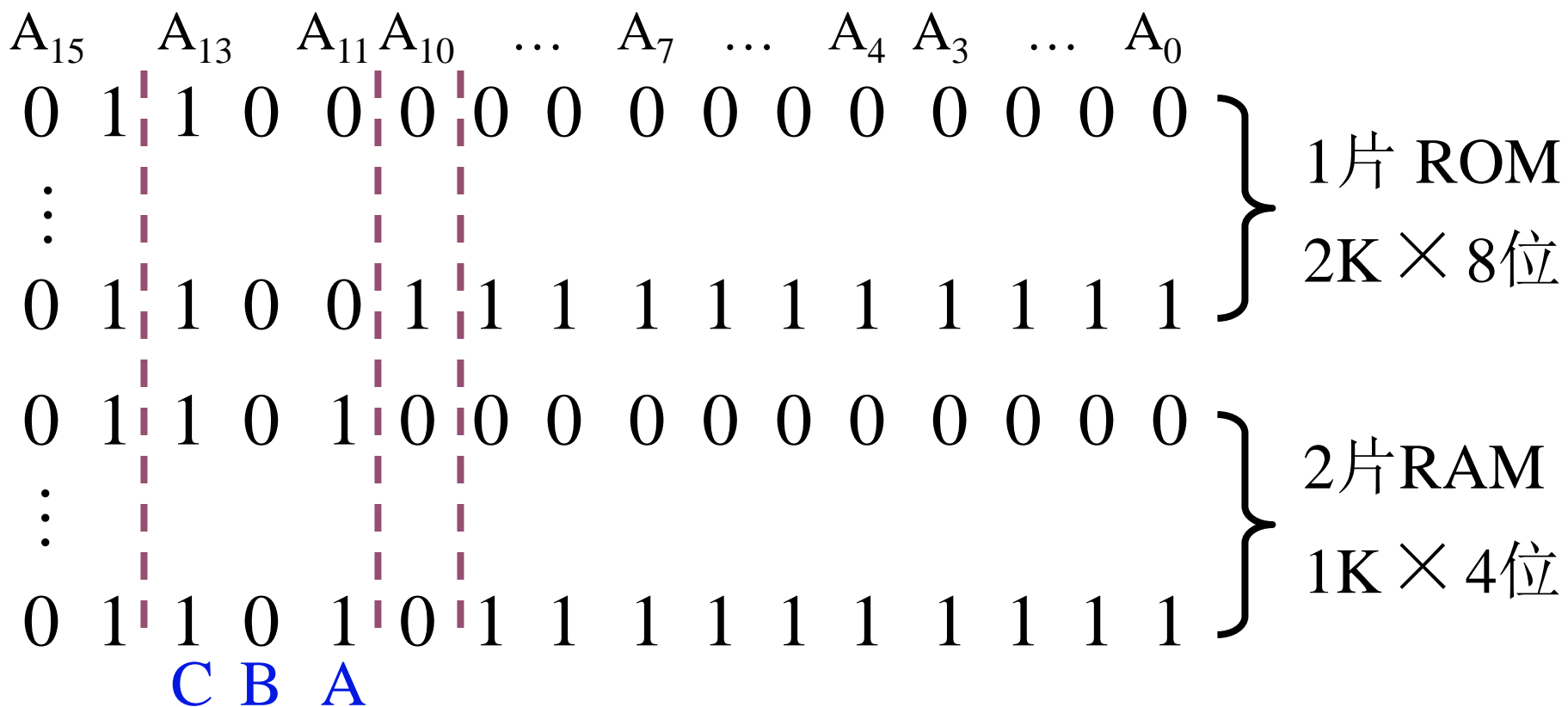
(1) 写出对应的二进制地址码



(2) 确定芯片的数量及类型

(3) 分配地址线

4.2



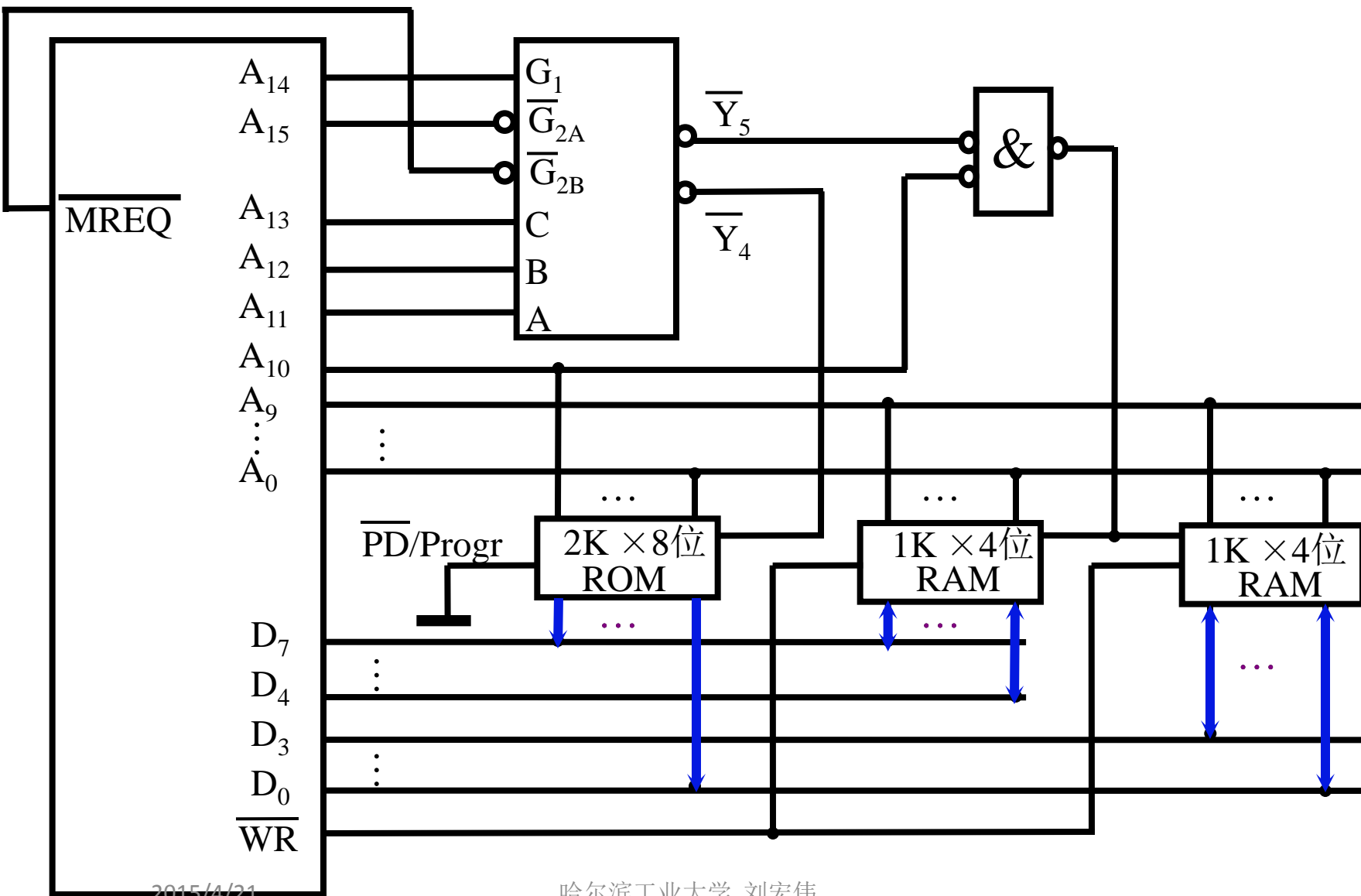
$A_{10} \sim A_0$ 接 $2K \times 8$ 位 ROM 的地址线

$A_9 \sim A_0$ 接 $1K \times 4$ 位 RAM 的地址线

(4) 确定片选信号

例 4.1 CPU 与存储器的连接图

4.2

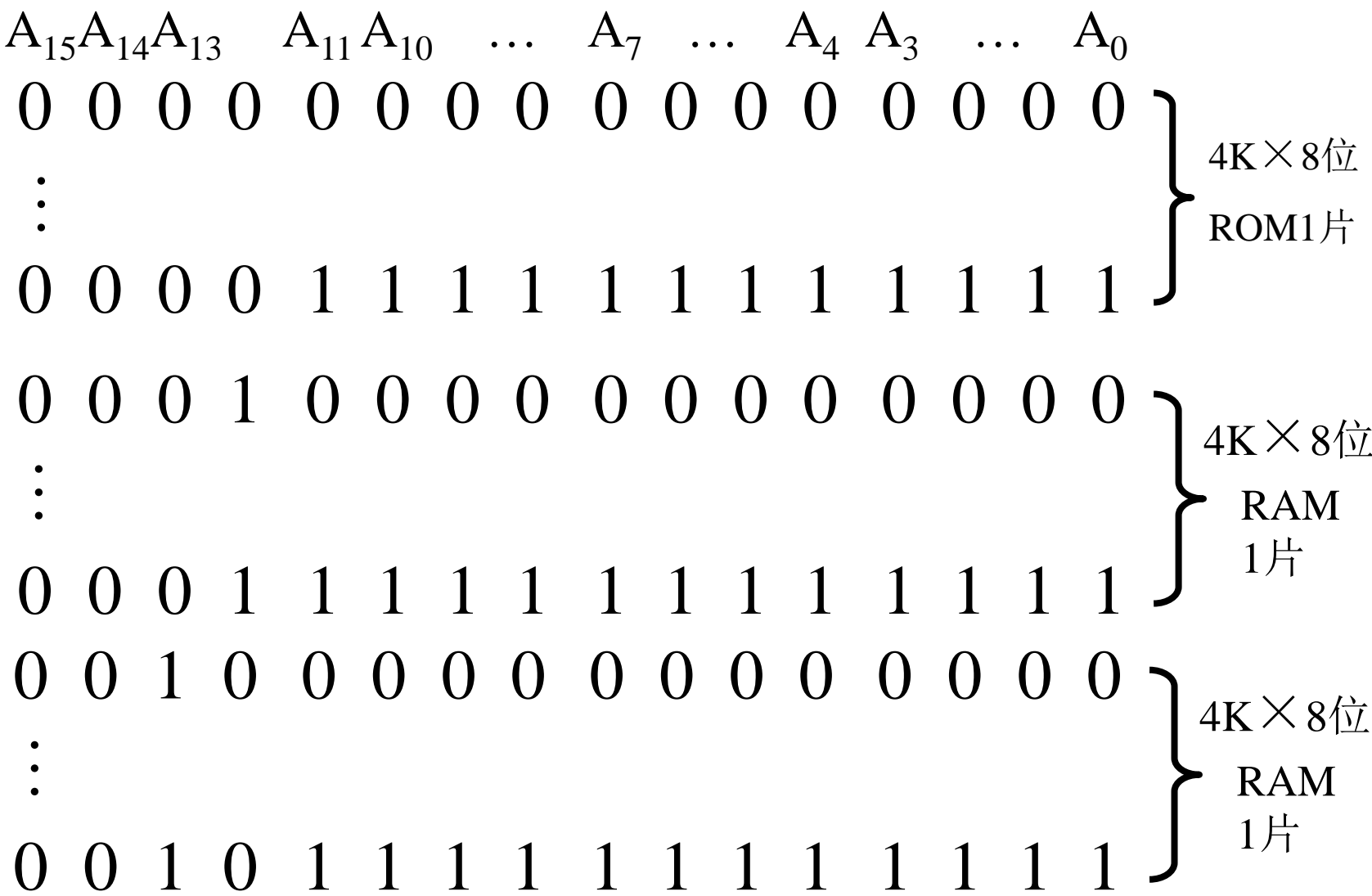


例4.2 假设同前，要求最小 4K为系统程序区，相邻 8K为用户程序区。

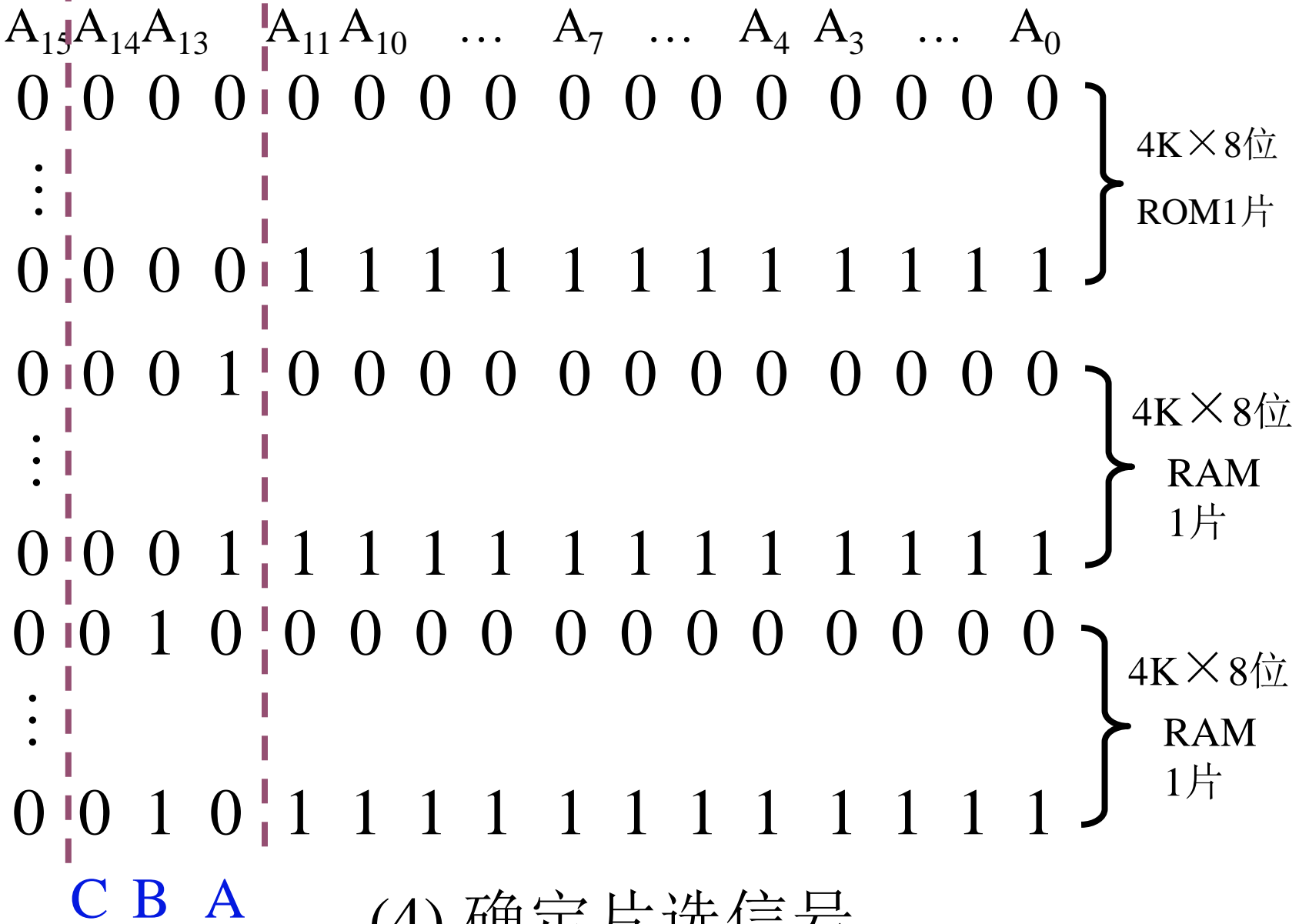
- (1) 写出对应的二进制地址码
- (2) 确定芯片的数量及类型
- (3) 分配地址线
- (4) 确定片选信号
- (5) 确定片选逻辑

例4.2 假设同前，要求最小 4K为系统程序区，相邻 8K为用户程序区。

- (1) 写出对应的二进制地址码
- (2) 确定芯片的数量及类型



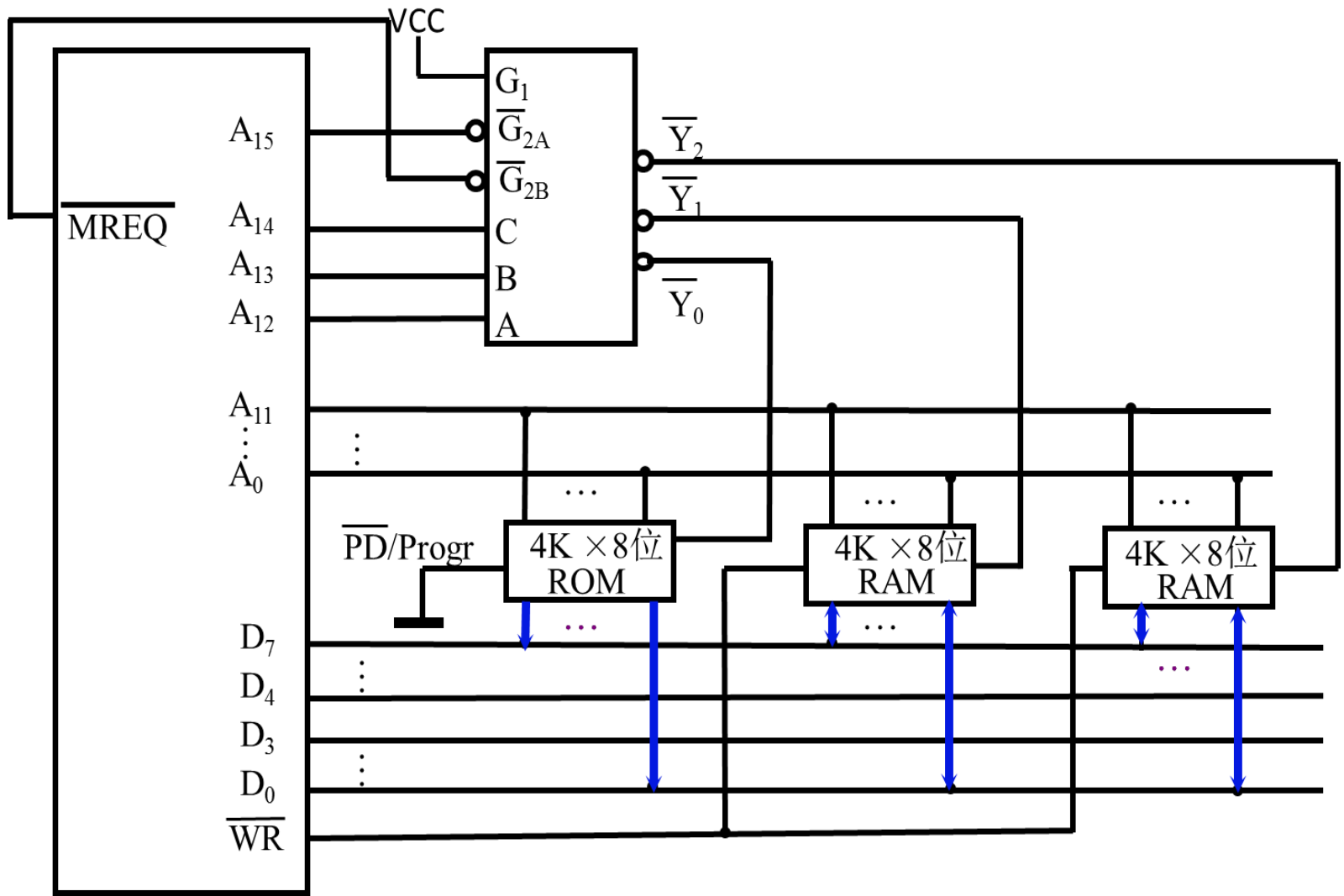
(3) 分配地址线



(4) 确定片选信号

例 4.2 CPU 与存储器的连接图

4.2



4.2 主存储器

- 一、概述
- 二、半导体存储芯片简介
- 三、随机存取存储器 (**RAM**)
- 四、只读存储器 (**ROM**)
- 五、存储器与 **CPU** 的连接
- **六、存储器的校验**
- 七、提高访存速度的措施

4.2 主存储器——存储器的校验

- 1、为什么要对存储器的信息进行校验？
- 2、为了能够校验出信息是否正确，如何进行编码？
- 3、纠错或检错能力与什么因素有关？
- 4、校验出信息出错后是如何进行纠错？
- 5、除了我们教材上讲的校验码，你还知道哪些容错编码？，原理是什么？

4.2 主存储器——存储器的校验

• 合法代码集合

1、{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111} 检0位错、纠0位错

2、{000, 011, 101, 110}

↓
100 检1位错, 纠0位错

3、{000, 111} 检1位错, 纠1位错

↓ ? ↓
100 110

4、{0000, 1111} 检2位错, 纠1位错

1000 1100

5、{00000, 11111} 检2位错, 纠2位错

11000 11100

编码的检测能力和纠错能力和什么有关呢

任意两组合法
代码之间 二
进制位的 最
少差异数

六、存储器的校验

4.2

1. 编码的最小距离

任意两组合法代码之间 二进制位数 的 最少差异

编码的纠错、检错能力与编码的最小距离有关

$$L - 1 = D + C \quad (D \geq C)$$

L —— 编码的最小距离 $L = 3$

D —— 检测错误的位数 具有 一位 纠错能力

C —— 纠正错误的位数

汉明码是具有一位纠错能力的编码

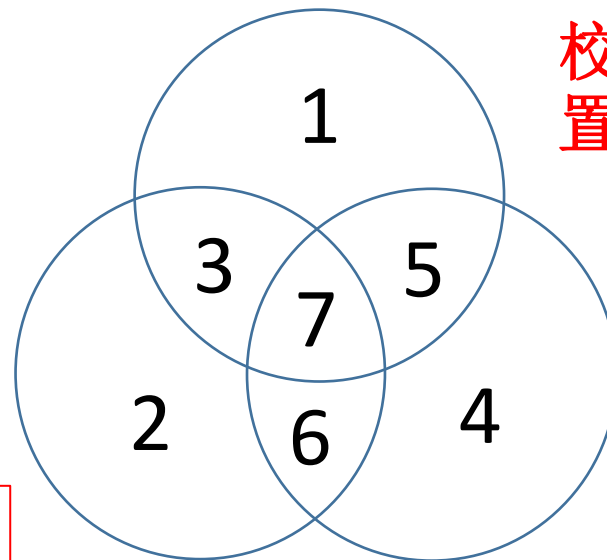
2. 汉明码的组成

4.2

- 汉明码采用奇偶检验
- 汉明码采用分组校验

00100011 100100011 1001000011

校验位 校验位



校验位应该放在哪些位置呢？

1, 2, 4, 8
位置放校验码

P₃P₂P₁
0 0 0
0 0 1
1 0 1
1 1 0
1 1 1

无差错
1
5
6
7

给出了出错的位

- 汉明码的分组是一种非划分方式 如何分组的呢？

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

分成3组，每组有1位校验位，
共包括4位数据位

第1组 XXXX1
第2组 XXX1X
第3组 XX1XX
第4组 X1XXX
第5组 1XXXX

2. 汉明码的组成

4.2

组成汉明码的三要素

汉明码的组成需增添 ? 位检测位

$$2^k \geq n + k + 1$$

检测位的位置 ?

$$2^i \quad (i = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

检测位的取值 ?

检测位的取值与该位所在的检测“小组”中
承担的奇偶校验任务有关

各检测位 C_i 所承担的检测小组为

4.2

C_1 检测的 g_1 小组包含第 1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots 位置的二进制编码为 $X \dots XXX1$

C_2 检测的 g_2 小组包含第 2, 3, 6, 7, 10, 11, \dots 位置的二进制编码为 $X \dots XX1X$

C_4 检测的 g_3 小组包含第 4, 5, 6, 7, 12, 13, \dots 位置的二进制编码为 $X \dots X1XX$

C_8 检测的 g_4 小组包含第 8, 9, 10, 11, 12, 13, \dots
位置的二进制编码为 $X \dots 1XXX$

g_i 小组独占第 2^{i-1} 位 位置的二进制编码为 $0 \dots 10 \dots 0$

g_i 和 g_j 小组共同占第 $2^{i-1} + 2^{j-1}$ 位

位置的二进制编码为 $0 \dots 010 \dots 010 \dots 0$

g_i 、 g_j 和 g_l 小组共同占第 $2^{i-1} + 2^{j-1} + 2^{l-1}$ 位

位置的二进制编码为 $0 \dots 010 \dots 010 \dots 010 \dots 0$

例4.4 求 0101 按 “偶校验” 配置的汉明码

解： $\because n = 4$

根据 $2^k \geq n + k + 1$

得 $k = 3$

汉明码排序如下：

二进制序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	C_1	C_2	0	C_4	1	0	1
	0	1		0			

\therefore 0101 的汉明码为 0100101

练习1 按配偶原则配置 0011 的汉明码 4.2

解： $\because n = 4$ 根据 $2^k \geq n + k + 1$

取 $k = 3$

二进制序号	1	2	3	4	5	6	7
名称	C_1	C_2	0	C_4	0	1	1
	1	0		0			

$$C_1 = 3 \oplus 5 \oplus 7 = 1$$

$$C_2 = 3 \oplus 6 \oplus 7 = 0$$

$$C_4 = 5 \oplus 6 \oplus 7 = 0$$

\therefore 0011 的汉明码为 1000011

3. 汉明码的纠错过程

4.2

形成新的检测位 P_i ，其位数与增添的检测位有关，
如增添 3 位（ $k=3$ ），新的检测位为 $P_4 P_2 P_1$ 。

以 $k=3$ 为例， P_i 的取值为

$$P_1 = \overset{C_1}{1} \oplus 3 \oplus 5 \oplus 7$$

$$P_2 = \overset{C_2}{2} \oplus 3 \oplus 6 \oplus 7$$

$$P_4 = \overset{C_4}{4} \oplus 5 \oplus 6 \oplus 7$$

对于按“偶校验”配置的汉明码

不出错时 $P_1=0, P_2=0, P_4=0$

例4.5 已知接收到的汉明码为 0100111

(按配偶原则配置) 试问要求传送的信息是什么?

解: 纠错过程如下

$$P_1 = 1 \oplus 3 \oplus 5 \oplus 7 = 0 \quad \text{无错}$$

$$P_2 = 2 \oplus \underset{\checkmark}{3} \oplus \boxed{6} \oplus \underset{\checkmark}{7} = 1 \quad \text{有错}$$

$$P_4 = 4 \oplus \underset{\checkmark}{5} \oplus \boxed{6} \oplus \underset{\checkmark}{7} = 1 \quad \text{有错}$$

$$\therefore P_4 P_2 P_1 = 110$$

第 6 位出错, 可纠正为 0100101,
故要求传送的信息为 0101。

练习2 写出按偶校验配置的汉明码

0101101 的纠错过程

$$P_4 = 4 \oplus 5 \oplus 6 \oplus 7 = 1$$

$$P_2 = 2 \oplus 3 \oplus 6 \oplus 7 = 0$$

$$P_1 = 1 \oplus 3 \oplus 5 \oplus 7 = 0$$

$\therefore P_4 P_2 P_1 = 100$ 第4位错，可不纠

练习3 按配奇原则配置 0011 的汉明码

配奇的汉明码为 0101011

4.2 主存储器

- 一、概述
- 二、半导体存储芯片简介
- 三、随机存取存储器 (**RAM**)
- 四、只读存储器 (**ROM**)
- 五、存储器与 **CPU** 的连接
- 六、存储器的校验
- 七、提高访存速度的措施

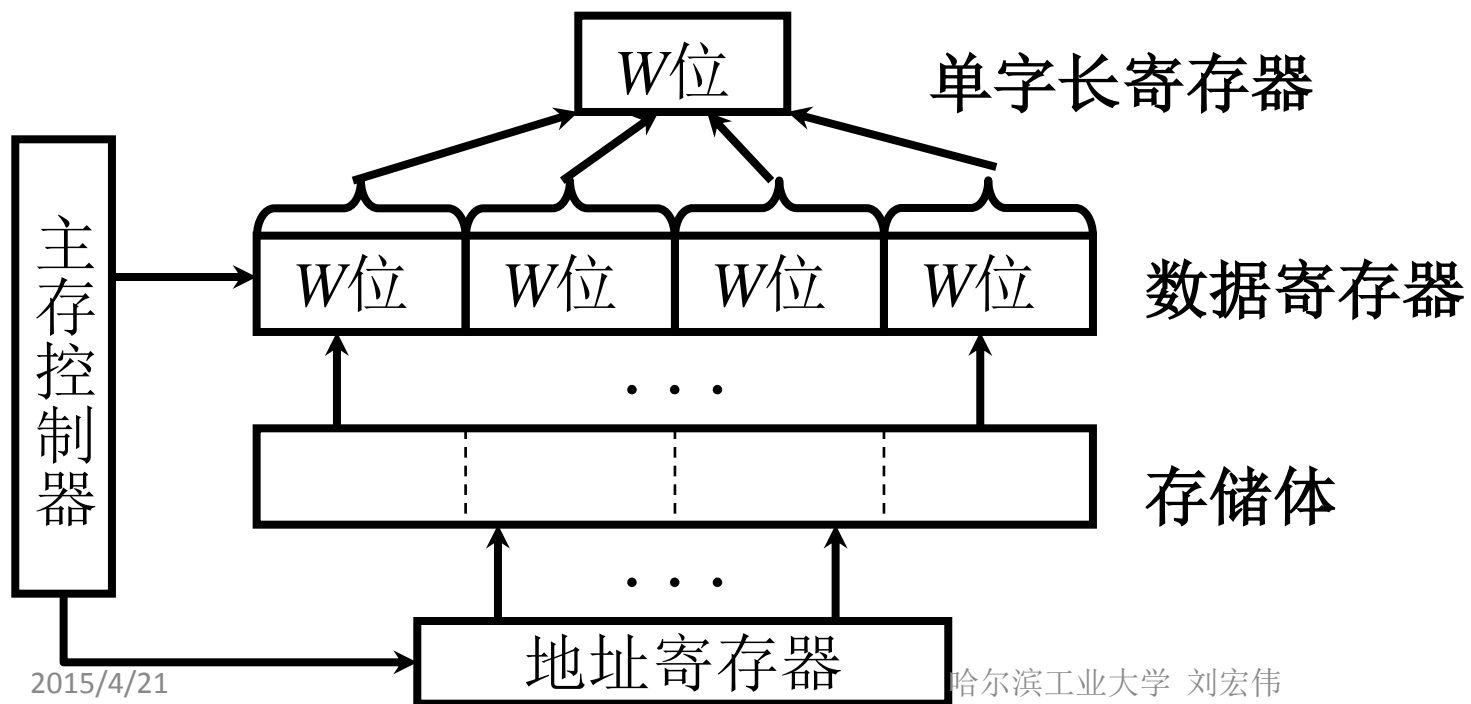
七、提高访存速度的措施

4.2

- 采用高速器件
- 采用层次结构 Cache –主存
- 调整主存结构

1. 单体多字系统

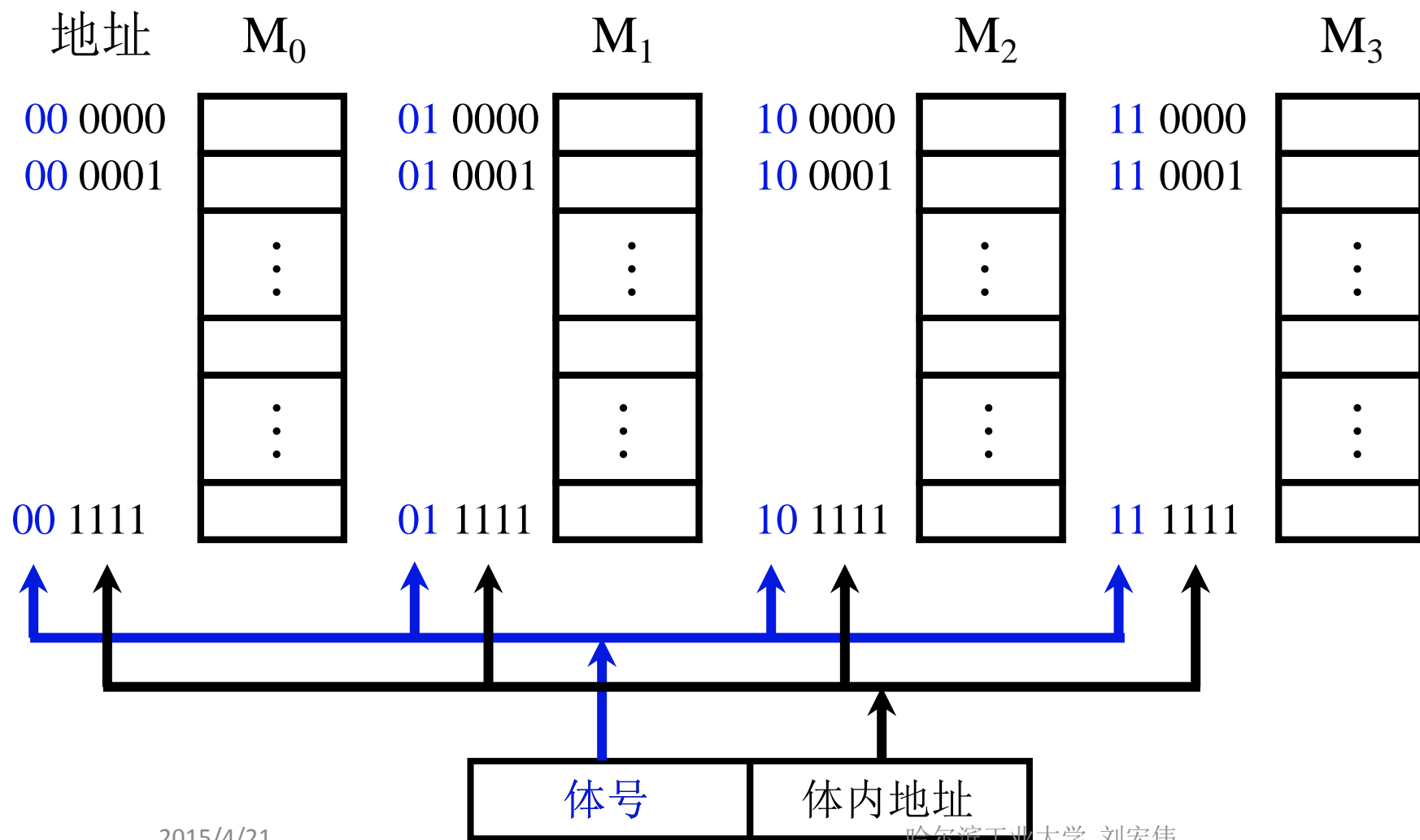
增加存储器的带宽



2. 多体并行系统

4.2

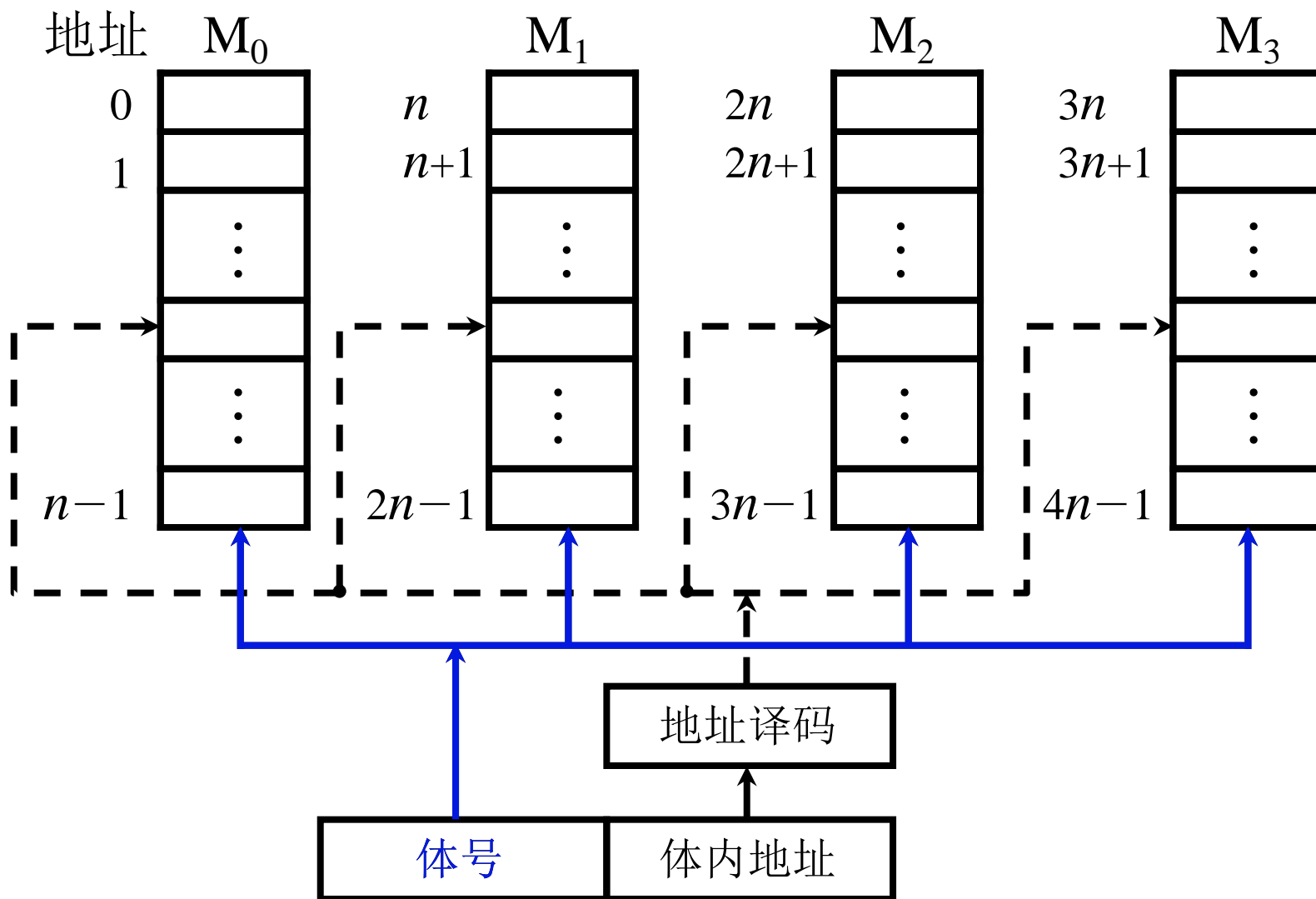
(1) 高位交叉 顺序编址



(1) 高位交叉

各个体并行工作

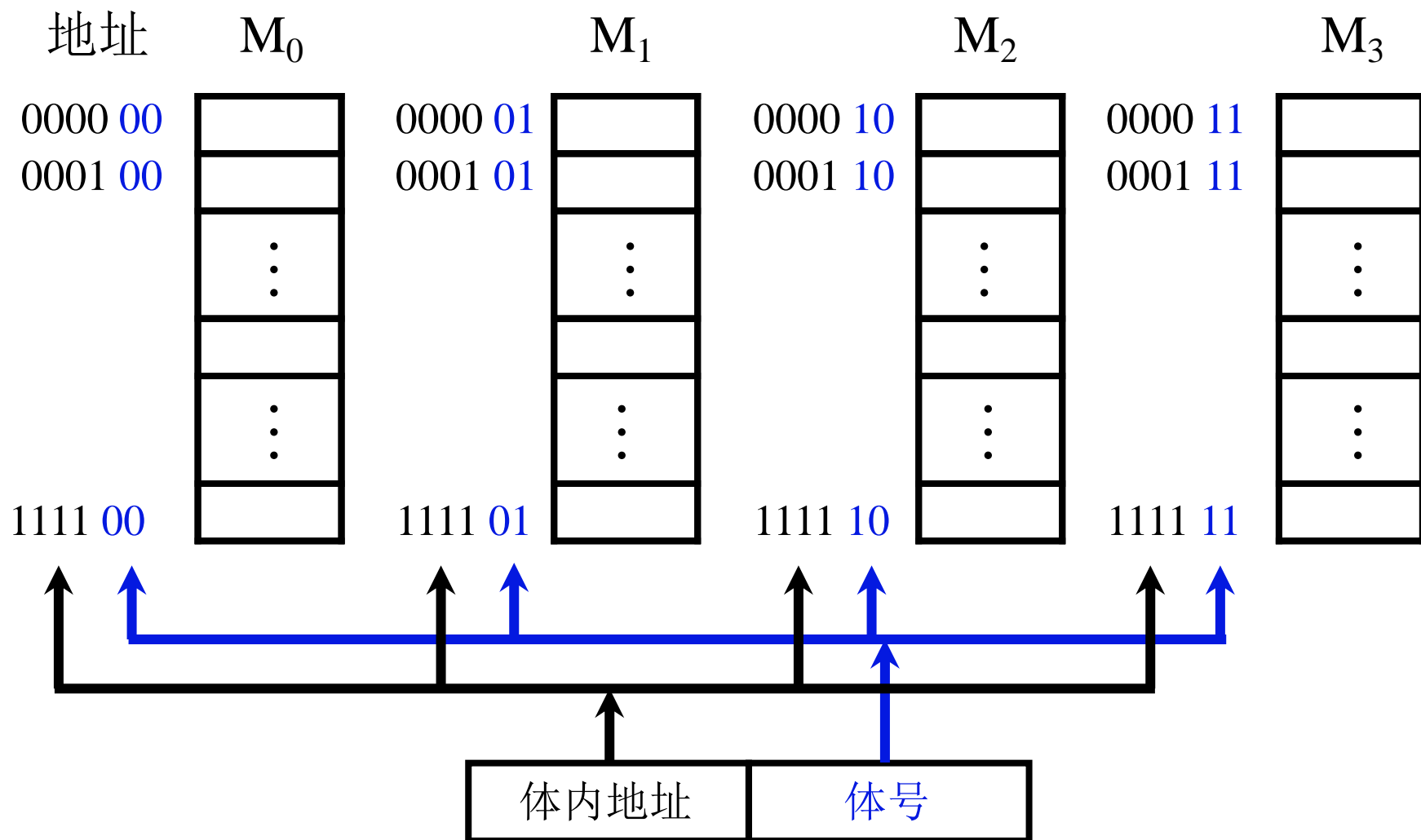
4.2



(2) 低位交叉

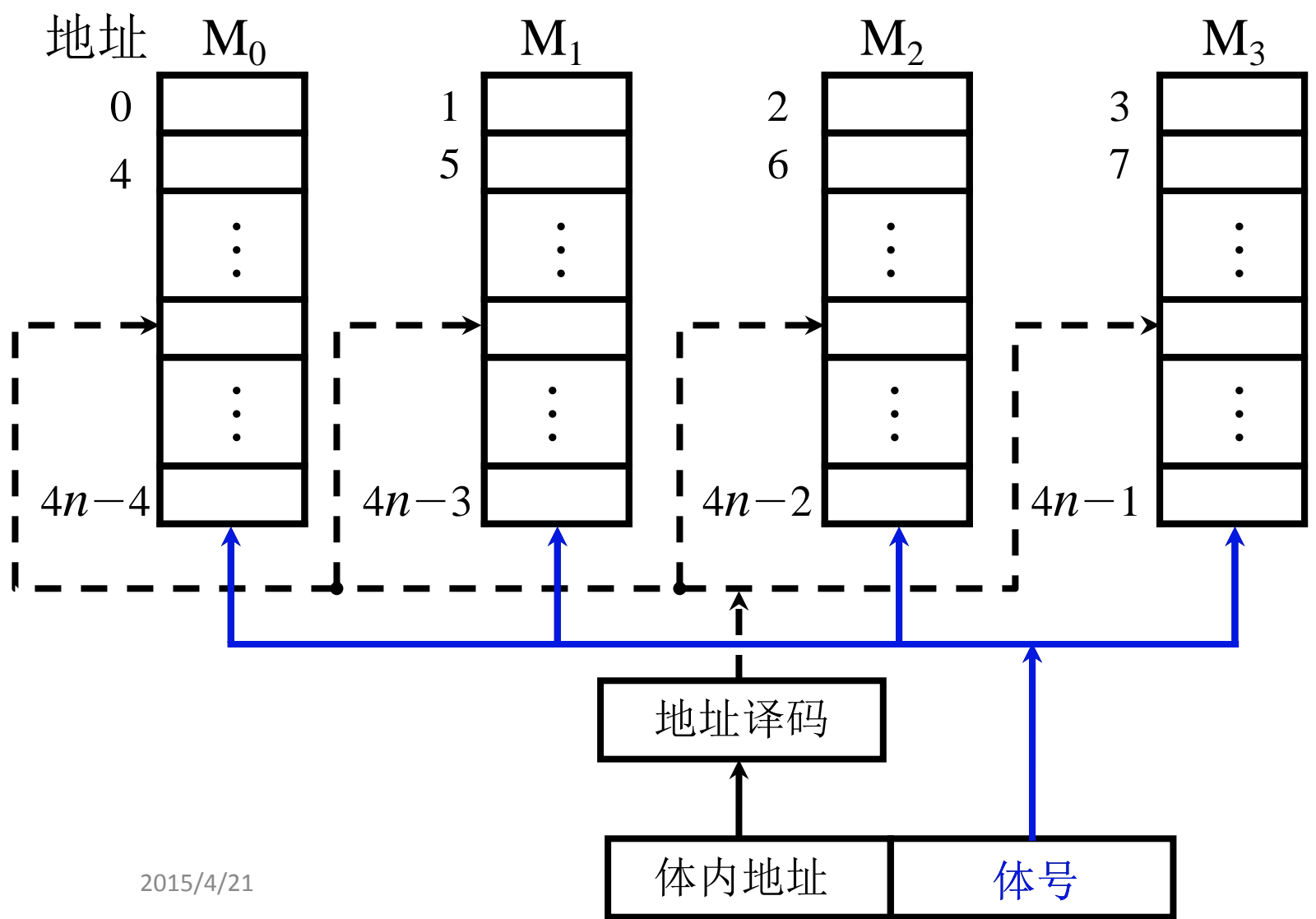
各个体轮流编址

4.2



(2) 低位交叉 各个体轮流编址

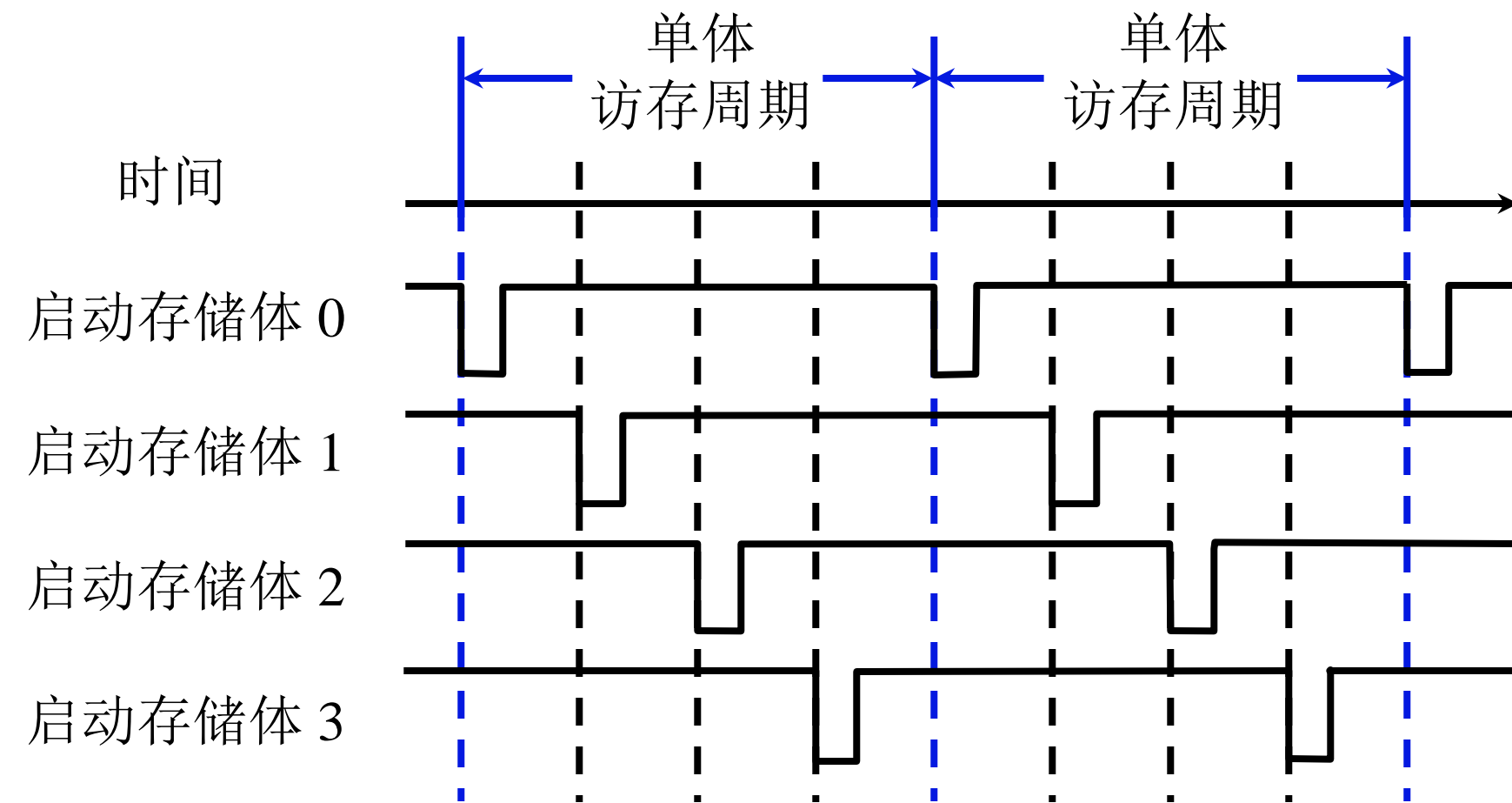
4.2



低位交叉的特点

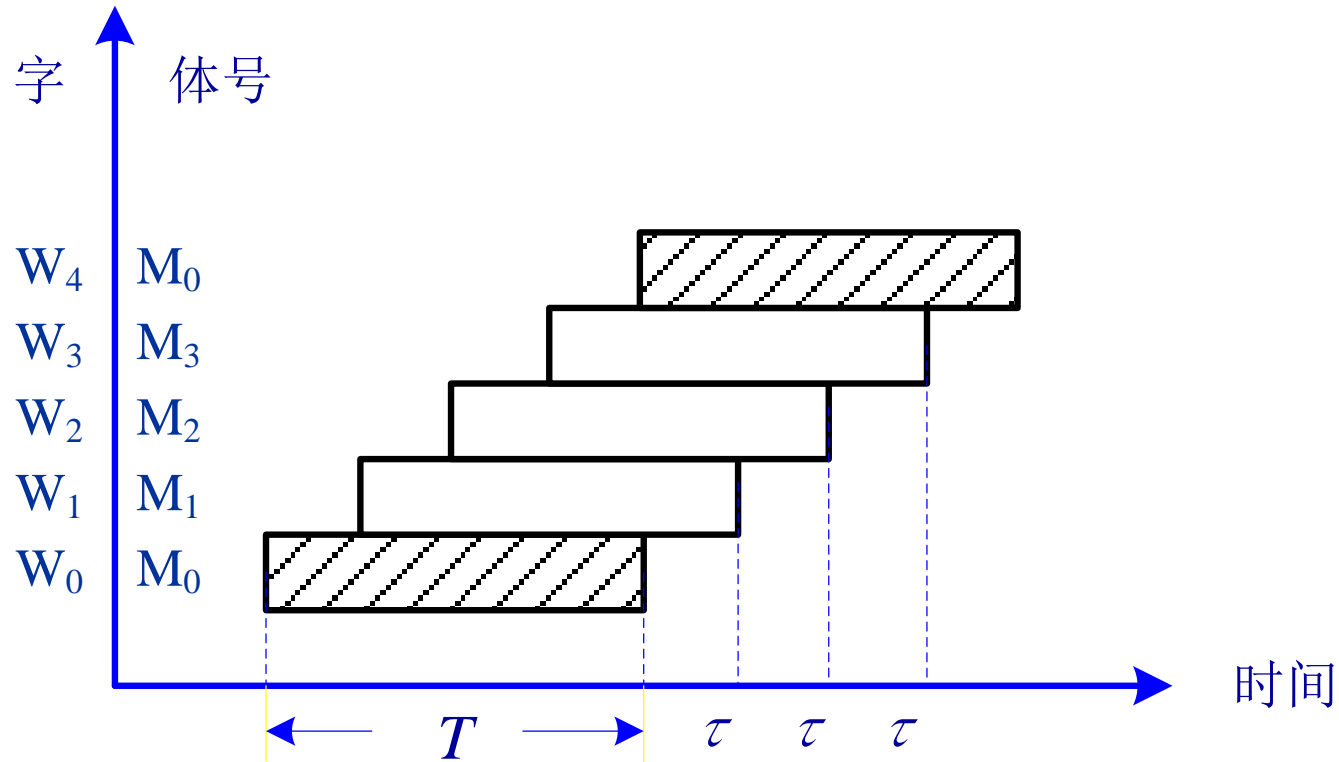
4.2

在不改变存取周期的前提下，增加存储器的带宽



4.2

设四体低位交叉存储器，存取周期为 T ，总线传输周期为 τ ，为实现流水线方式存取，应满足 $T = 4\tau$ 。



连续读取 4 个字所需的时间为 $T + (4 - 1)\tau$

3.高性能存储芯片

4.2

(1) SDRAM (同步 DRAM)

在系统时钟的控制下进行读出和写入

CPU 无须等待

(2) RDRAM

由 Rambus 开发，主要解决 存储器带宽 问题

(3) 带 Cache 的 DRAM

在 DRAM 的芯片内 集成 了一个由 SRAM 组成的

Cache，有利于 猝发式读取